



24-Bit Delta Sigma A/D Flash 单片机
内置稳压器

BH66F5233

版本 : V1.40 日期 : 2019-11-28

www.holtek.com

目录

特性	6
CPU 特性	6
周边特性	6
概述	7
方框图	7
引脚图	8
引脚说明	9
极限参数	10
直流电气特性	11
工作电压特性	11
待机电流特性	11
工作电流特性	12
交流电气特性	12
内部高速振荡器频率精度	12
内部低速振荡器电气特性	13
工作频率特性曲线图	13
系统上电时间特性	13
输入 / 输出口电气特性	14
存储器电气特性	15
LDO+PGA+ADC+VCM 电气特性	16
LVD / LVR 电气特性	19
上电复位特性	19
系统结构	20
时序和流水线结构	20
程序计数器	21
堆栈	21
算术逻辑单元 – ALU	22
Flash 程序存储器	23
结构	23
特殊向量	23
查表	23
查表范例	24
在线烧录 – ICP	25
片上调试 – OCDS	25
数据存储器	26
结构	26
通用数据存储器	26
特殊功能数据存储器	27

特殊功能寄存器	28
间接寻址寄存器 – IAR0, IAR1	28
存储器指针 – MP0, MP1	28
存储区指针 – BP	29
累加器 – ACC	29
程序计数器低字节寄存器 – PCL	29
表格寄存器 – TBLP, TBHP, TBLH	29
状态寄存器 – STATUS	30
EEPROM 数据存储器	32
EEPROM 数据存储器结构	32
EEPROM 寄存器	32
从 EEPROM 中读取数据	33
写数据到 EEPROM	33
写保护	34
EEPROM 写中断	34
编程注意事项	34
振荡器	35
振荡器概述	35
系统时钟配置	35
内部高速 RC 振荡器 – HIRC	36
内部 32kHz 振荡器 – LIRC	36
工作模式和系统时钟	37
系统时钟	37
系统工作模式	37
控制寄存器	39
工作模式切换	40
静态电流的注意事项	44
唤醒	44
看门狗定时器	45
看门狗定时器时钟源	45
看门狗定时器控制寄存器	45
看门狗定时器操作	46
复位和初始化	47
复位功能	47
复位初始状态	50
输入 / 输出端口	53
上拉电阻	53
PA 口唤醒	54
输入 / 输出端口控制寄存器	54
输入 / 输出端口源电流选择	55
引脚共用功能	56
输入 / 输出引脚结构	57
编程注意事项	58

定时器模块 – TM	58
简介	58
TM 操作	58
TM 时钟源	58
TM 中断	59
TM 外部引脚	59
TM 输入 / 输出引脚选择	59
编程注意事项	59
简易型 TM – CTM	61
简易型 TM 操作	61
简易型 TM 寄存器介绍	61
简易型 TM 工作模式	65
A/D 转换器	71
A/D 转换器简介	71
内部电源	71
A/D 转换器数据传输率的定义	73
A/D 转换寄存器介绍	73
A/D 转换器操作	79
A/D 转换步骤	80
编程注意事项	81
A/D 转换功能	81
A/D 转换数据	82
A/D 转换数据转为电压值	82
温度传感器	82
A/D 转换应用范例	83
串行接口模块 – SIM	84
SPI 接口	84
I ² C 接口	91
中断	101
中断寄存器	101
中断操作	105
外部中断	106
SIM 中断	106
时基中断	106
A/D 转换器中断	108
多功能中断	108
EEPROM 中断	108
LVD 中断	108
TM 中断	108
中断唤醒功能	109
编程注意事项	109
低电压检测 – LVD	110
LVD 寄存器	110
LVD 操作	111

应用电路	112
指令集	113
简介	113
指令周期	113
数据的传送	113
算术运算	113
逻辑和移位运算	113
分支和控制转换	114
位运算	114
查表运算	114
其它运算	114
指令集概要	115
惯例	115
指令定义	118
封装信息	130
10-pin SOP (150mil) 外形尺寸	131
16-pin NSOP (150mil) 外形尺寸	132
20-pin NSOP (150mil) 外形尺寸	133

特性

CPU 特性

- 工作电压
 - ◆ $f_{\text{SYS}}=4\text{MHz}$: 2.2V ~ 5.5V
 - ◆ $f_{\text{SYS}}=8\text{MHz}$: 2.2V ~ 5.5V
 - ◆ $f_{\text{SYS}}=12\text{MHz}$: 2.7V ~ 5.5V
- $V_{\text{DD}}=5\text{V}$, 系统时钟为 12MHz 时, 指令周期为 0.33 μs
- 提供暂停和唤醒功能, 以降低功耗
- 振荡器类型:
 - ◆ 内部高频 RC – HIRC
 - ◆ 内部 32kHz RC – LIRC
- 多种工作模式: 快速、低速、空闲和休眠
- 内部集成 4/8/12MHz 振荡器, 无需外部元件
- 所有指令都可在 1~2 个指令周期内完成
- 查表指令
- 63 条功能强大的指令系统
- 4 层堆栈
- 位操作指令

周边特性

- Flash 程序存储器: 2K \times 16
- RAM 数据存储器: 96 \times 8
- True EEPROM 存储器: 32 \times 8
- 看门狗定时器功能
- 14 个双向 I/O 口
- 2 个引脚与外部中断口共用
- 1 个定时器模块用于时间测量、比较匹配输出及 PWM 输出
- 串行接口模块 – SIM, 用于 SPI 或 I²C 通信
- 双时基功能, 可提供固定时间的中断信号
- 1 组差分通道或 2 个单端外部通道 24 位分辨精度的 Delta Sigma 型 A/D 转换器
- 低电压复位功能
- 低电压检测功能
- 封装类型: 10-pin SOP, 16/20-pin NSOP

概述

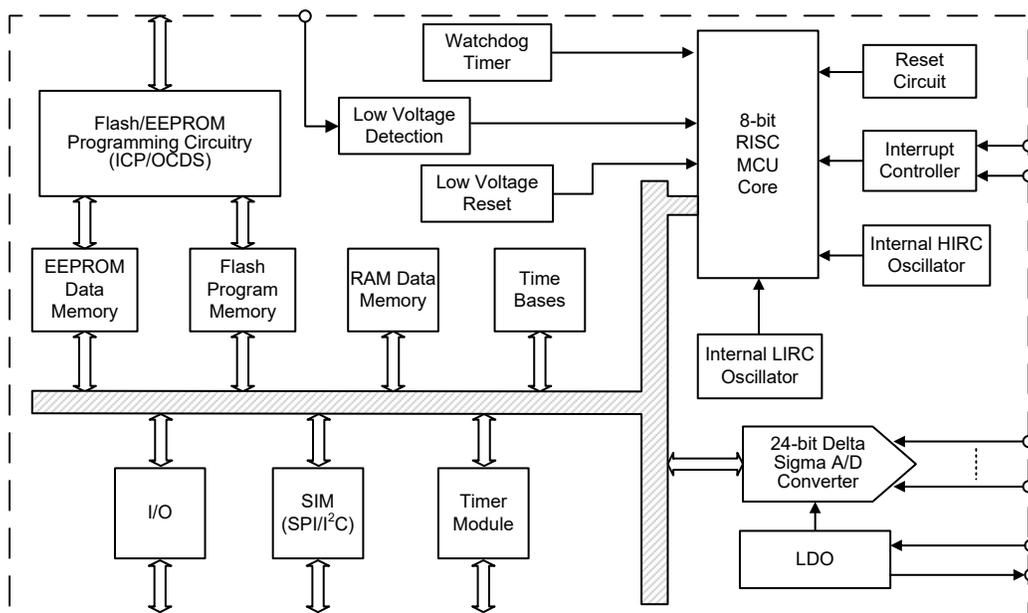
该单片机是一款 A/D 型具有 8 位高性能精简指令集的 Flash 单片机，内置的多通道 24-bit Delta Sigma 型 A/D 转换器专门为需要具有低噪声和高准确度的 A/D 转换而设计。该单片机具有一系列功能和特性，其 Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了极大的方便。存储器方面，还包含了一个 RAM 数据存储器和一个可用于存储序号、校准数据等非易失性数据的 True EEPROM 存储器。

在模拟特性方面，该单片机包含一个多通道 24-bit A/D 转换器和一个可编程增益放大器 PGA。还带有多个使用灵活的定时器模块，可提供定时功能、脉冲产生功能及 PWM 产生功能。内建完整的 SPI 和 I²C 功能，为设计者提供了一个易于外部硬件通信的接口。另外，内部 LDO 功能为内部和外部设备提供了各种电源选项。内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等内部保护特性，外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能，确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。

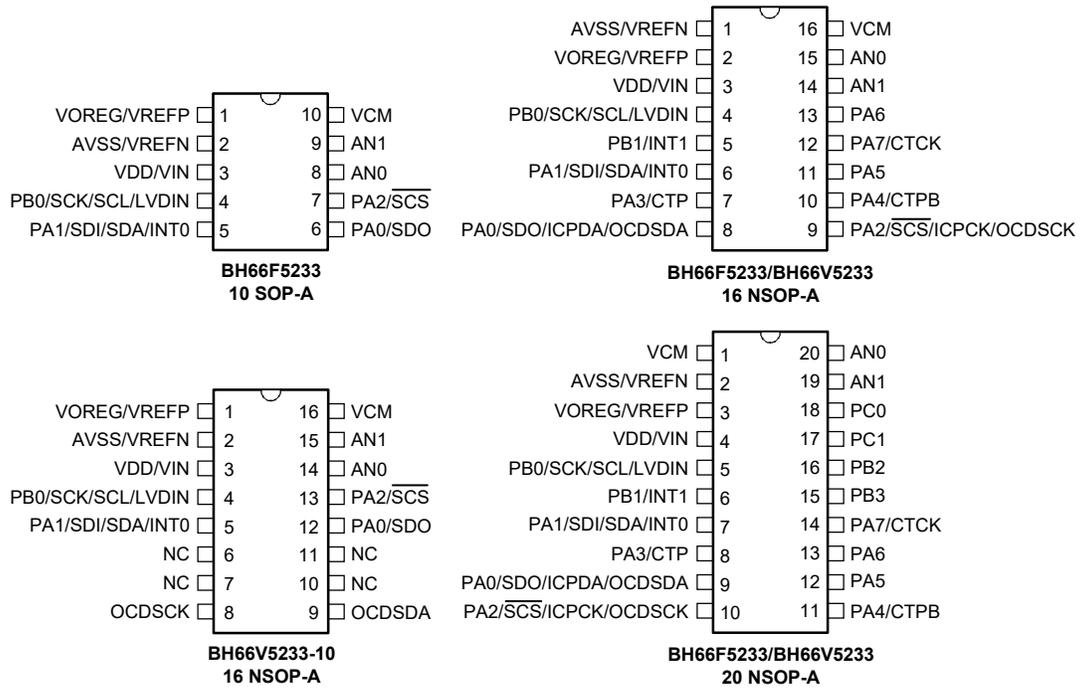
该单片机提供了内部低速和高速振荡器功能选项，且内建完整的系统振荡器，无需外接元件。其在不同工作模式之间动态切换的能力，为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。

外加 I/O 使用灵活、时基功能等其它特性，使该单片机可以广泛应用于各种产品中，例如体重秤、电子测量仪器、环境监控、手持式测量工具、家庭应用、电子控制工具、马达控制等方面。

方框图



引脚图



- 注：1. 若共用脚同时有多种输出，所需引脚共用功能通过引脚共用寄存器中相应的软件控制位控制。
 2. BH66V5233 是 BH66F5233 的 EV 芯片，OCDSCK 和 OCSDA 引脚仅存在于 OCDS EV 芯片。
 3. 在较小封装中可能含有未引出的引脚，需合理设置其状态以避免输入浮空造成额外耗电，详见“待机电流注意事项”和“输入/输出端口”章节。

引脚说明

每个引脚的功能如下表所述，而引脚配置的详细内容见规格书其它章节。

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PA0/SDO/ICPDA/ OCSDA	PA0	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	SDO	PAS0 SIMC2	—	CMOS	SPI 串行数据输出
	ICPDA	—	ST	CMOS	ICP 数据 / 地址
	OCSDA	—	ST	CMOS	OCDS 数据 / 地址，仅用于 EV 芯片
PA1/SDI/SDA/INT0	PA1	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	SDI	PAS0 SIMC2	ST	—	SPI 串行数据输入
	SDA	PAS0 SIMC0	ST	NMOS	I ² C 数据线
	INT0	INTEG INTC0	ST	—	外部中断 0 输入
PA2/ $\overline{\text{SCS}}$ /ICPCK/ OCDSCK	PA2	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	$\overline{\text{SCS}}$	PAS0 SIMC2	ST	CMOS	SPI 从机选择
	ICPCK	—	ST	—	ICP 时钟引脚
	OCDSCK	—	ST	—	OCDS 时钟引脚，仅用于 EV 芯片
PA3/CTP	PA3	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	CTP	PAS0	—	CMOS	CTM 输出
PA4/CTPB	PA4	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	CTPB	PAS1	—	CMOS	CTM 反相输出
PA5~ PA6	PA5~PA6	PAPU PAWU	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
PA7/CTCK	PA7	PAPU PAWU	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	CTCK	—	ST	—	CTM 时钟输入
PB0/SCK/SCL/ LVDIN	PB0	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SCK	PBS0	ST	CMOS	SPI 串行时钟
	SCL	PBS0	ST	NMOS	I ² C 时钟线
	LVDIN	PBS0	AN	—	LVD 输入

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PB1/INT1	PB1	PBPU	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	INT1	INTEG INTC0	ST	—	外部中断 1 输入
PB2~PB3	PB2~PB3	PBPU	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
PC0~PC1	PC0~PC1	PCPU	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
VOREG/VREFP	VOREG	—	—	PWR	LDO 输出引脚
			PWR	—	VCM, A/D 转换器, PGA 正电源供电
	VREFP	—	AN	—	A/D 转换器外部正极参考电压输入
AVSS/VREFN	AVSS	—	PWR	—	VCM, A/D 转换器, PGA 负电源供电
	VREFN	—	AN	—	A/D 转换器外部负极参考电压输入
AN0~AN1	AN0~AN1	—	AN	—	A/D 转换器输入通道
VCM	VCM	—	AN	—	A/D 转换器外部共模电压输入
			—	AN	A/D 转换器共模电压输出
VDD/VIN	VDD	—	PWR	—	数字正电源
	VIN	—	PWR	—	LDO 输入引脚

注：I/T：输入类型；

OPT：通过寄存器选项来配置；

ST：施密特触发输入；

NMOS：NMOS 输出

O/T：输出类型；

PWR：电源；

CMOS：CMOS 输出；

AN：模拟信号；

极限参数

电源供应电压	$V_{SS}-0.3V \sim V_{SS}+6.0V$
输入电压	$V_{SS}-0.3V \sim V_{DD}+0.3V$
储存温度	$-50^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$
工作温度	$-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$
I_{OH} 总电流	-80mA
I_{OL} 总电流.....	80mA
总功耗	500mW

注：这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态，而且若长期在标示范围外的条件下工作，可能影响芯片的可靠性。

直流电气特性

以下表格中参数测量结果可能受多个因素影响，如振荡器类型、工作温度、工作频率、引脚负载状况、温度和程序指令等等。

工作电压特性

Ta = -40°C~85°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V _{DD}	工作电压 – HIRC	f _{SYS} = f _{HIRC} = 4MHz	2.2	—	5.5	V
		f _{SYS} = f _{HIRC} = 8MHz	2.2	—	5.5	
		f _{SYS} = f _{HIRC} = 12MHz	2.7	—	5.5	
	工作电压 – LIRC	f _{SYS} = f _{LIRC} = 32kHz	2.2	—	5.5	V

待机电流特性

Ta = 25°C

符号	待机模式	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{STB}	休眠模式	3V	WDT off	—	0.08	0.12	μA
		5V		—	0.15	0.29	
		3V	WDT on	—	1.5	3.0	μA
		5V		—	3	5	
	空闲模式 0	3V	f _{SUB} on	—	3	5	μA
		5V		—	5	10	
	空闲模式 1 – HIRC	3V	f _{SUB} on, f _{SYS} = 4MHz	—	0.18	0.25	mA
		5V		—	0.4	0.6	
		3V	f _{SUB} on, f _{SYS} = 8MHz	—	0.36	0.50	mA
		5V		—	0.6	0.8	
3V		f _{SUB} on, f _{SYS} = 12MHz	—	0.54	0.75	mA	
5V			—	0.8	1.2		

注：当使用该电气特性表格数据时，以下几点需注意：

1. 任何数字输入都设置为非浮空的状态。
2. 所有测量都在无负载且所有外围功能关闭的条件下进行。
3. 无直流电流通路。
4. 所有待机电流数值都是在 HALT 指令执行后即所有指令执行停止时测得。

工作电流特性

Ta=25°C

符号	工作模式	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{DD}	慢速模式 – LIRC	3V	f _{sys} = 32kHz	—	10	20	μA
		5V		—	30	50	
	快速模式 – HIRC	3V	f _{sys} = 4MHz	—	0.4	0.6	mA
		5V		—	0.8	1.2	
		3V	f _{sys} = 8MHz	—	0.8	1.2	mA
		5V		—	1.6	2.4	
		3V	f _{sys} = 12MHz	—	1.2	1.8	mA
		5V		—	2.4	3.6	

注：当使用该电气特性表格数据时，以下几点需注意：

1. 任何数字输入都设置为非浮空的状态。
2. 所有测量都在无负载且所有外围功能关闭的条件下进行。
3. 无直流电流通路。
4. 所有工作电流数据都是通过执行连续 NOP 指令程序回路进行测量。

交流电气特性

以下表格中参数测量结果可能受多个因素影响，如振荡器类型、工作电压、工作频率和温度等等。

内部高速振荡器频率精度

程序烧录时，烧录器会在 3V 或 5V 电压 (可由用户选择) 下 trim HIRC 振荡器为用户选择的 HIRC 频率。

4/8/12MHz

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	温度				
f _{HIRC}	通过烧录器调整后的 4MHz HIRC 频率	3V/5V	25°C	-1%	4	+1%	MHz
			-40°C ~ 85°C	-2%	4	+2%	
		2.2V~5.5V	25°C	-1.5%	4	+1.5%	
			-40°C ~ 85°C	-3%	4	+3%	
	通过烧录器调整后的 8MHz HIRC 频率	3V/5V	25°C	-1%	8	+1%	MHz
			-40°C ~ 85°C	-2%	8	+2%	
2.2V~5.5V		25°C	-1.5%	8	+1.5%		
		-40°C ~ 85°C	-3%	8	+3%		
通过烧录器调整后的 12MHz HIRC 频率	3V/5V	25°C	-1%	12	+1%	MHz	
		-40°C ~ 85°C	-2%	12	+2%		
	2.7V~5.5V	25°C	-1.5%	12	+1.5%		
		-40°C ~ 85°C	-3%	12	+3%		

注：1. 烧录器可选择在 3V 或 5V 电压下 trim HIRC 频率，在此提供 V_{DD}=3V/5V 时的参数值。

2. 表格中 3V/5V 一列下面提供的是全压条件下的参数值。

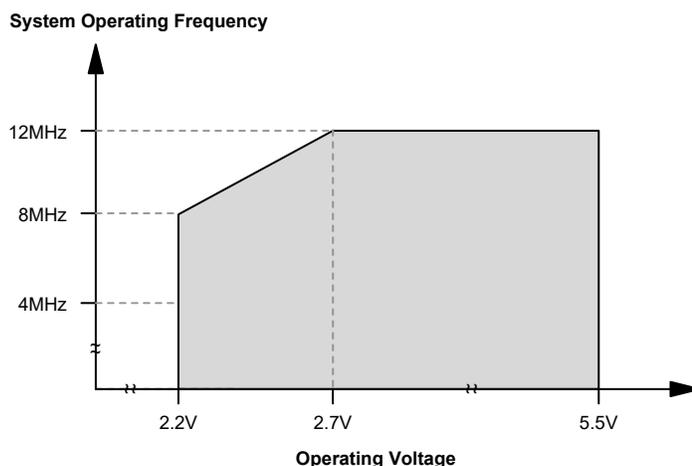
3. 表格中提供的为将 HIRC 频率通过应用程序设置在烧录器 trim 的频率值时，频率的最小和最大误差值。若通过应用程序将 HIRC 频率改为其它值时，频率误差范围将增加到 ±20%。

内部低速振荡器电气特性

Ta=25°C, 除非另外规定

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	温度				
f _{LIRC}	LIRC 频率	3V	25°C	-5%	32	+5%	kHz
			-40°C ~ 85°C	-10%	32	+10%	
		2.2V~5.5V	-40°C ~ 85°C	-20%	32	+20%	
占空比	占空比	—	—	10	—	90	%
t _{START}	LIRC 启动时间	3V/5V	—	—	—	500	μs

工作频率特性曲线图



系统上电时间特性

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
t _{SST}	系统启动时间 (从 f _{sys} off 的状态下唤醒)	f _{sys} = f _H ~ f _H /64, f _H = f _{HIRC}	16	—	—	t _{HIRC}
		f _{sys} = f _{SUB} = f _{LIRC}	2	—	—	t _{LIRC}
	系统启动时间 (从 f _{sys} on 的状态下唤醒)	f _{sys} = f _H ~ f _H /64, f _H = f _{HIRC}	2	—	—	t _H
		f _{sys} = f _{SUB} = f _{LIRC}	2	—	—	t _{SUB}
	系统速度切换时间 (快速模式 → 低速模式或 低速模式 → 快速模式)	f _{HIRC} off → on	16	—	—	t _{HIRC}
t _{RSTD}	系统复位延迟时间 (上电复位或 LVR 硬件复位)	RR _{POR} = 5V/ms	42	48	54	ms
	系统复位延迟时间 (LVRC/WDTC/RSTC 软件复位)	—				
	系统复位延迟时间 (WDT 溢出)	—	14	16	18	ms

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
t _{SRESET}	最小软件复位时间	—	45	90	120	μs

- 注：1. 系统启动时间里提到的 f_{sys on/off} 状态取决于工作模式类型以及所选的系统时钟振荡器。更多相关细节请参考系统工作模式章节。
2. t_{HXT}、t_{HIRC} 等时间单位，是对应频率值的倒数，相关频率值在前面表格有说明。例如，t_{HIRC} = 1/f_{HIRC}，t_{sys} = 1/f_{sys} 等等。
3. 若 LIRC 被选择作为系统时钟源且在休眠模式下 LIRC 关闭，则上面表格中对应 t_{SST} 数值还需加上 LIRC 启动时间 t_{START}。
4. 系统速度切换时间实际上是指新使能的振荡器的启动时间。

输入 / 输出口电气特性

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{IL}	I/O 口低电平输入电压	5V	—	0	—	1.5	V
		—	—	0	—	0.2V _{DD}	
V _{IH}	I/O 口高电平输入电压	5V	—	3.5	—	5.0	V
		—	—	0.8V _{DD}	—	V _{DD}	
V _{OL}	I/O 口低电平输出电压	3V	I _{OL} = 16mA	—	—	0.3	V
		5V	I _{OL} = 32mA	—	—	0.5	
V _{OH}	I/O 口高电平输出电压	3V	I _{OH} = -0.7mA, SLEDCn[m+1:m] = 00, (n = 0, 1, m = 0, 2, 4 or 6)	2.7	—	—	V
		5V	I _{OH} = -1.5mA, SLEDCn[m+1:m] = 00, (n = 0, 1, m = 0, 2, 4 or 6)	4.5	—	—	
		3V	I _{OH} = -1.3mA, SLEDCn[m+1:m] = 01, (n = 0, 1, m = 0, 2, 4 or 6)	2.7	—	—	
		5V	I _{OH} = -2.5mA, SLEDCn[m+1:m] = 01, (n = 0, 1, m = 0, 2, 4 or 6)	4.5	—	—	
		3V	I _{OH} = -1.8mA, SLEDCn[m+1:m] = 10, (n = 0, 1, m = 0, 2, 4 or 6)	2.7	—	—	
		5V	I _{OH} = -3.6mA, SLEDCn[m+1:m] = 10, (n = 0, 1, m = 0, 2, 4 or 6)	4.5	—	—	
		3V	I _{OH} = -4mA, SLEDCn[m+1:m] = 11, (n = 0, 1, m = 0, 2, 4 or 6)	2.7	—	—	
		5V	I _{OH} = -8mA, SLEDCn[m+1:m] = 11, (n = 0, 1, m = 0, 2, 4 or 6)	4.5	—	—	

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{OL}	I/O 口灌电流	3V	V _{OL} = 0.1V _{DD}	16	32	—	mA
		5V		32	65	—	
I _{OH}	I/O 口源电流	3V	V _{OH} = 0.9V _{DD} ,	-0.7	-1.5	—	mA
		5V	SLEDCn[m+1:m] = 00, (n = 0,1, m = 0, 2, 4 or 6)	-1.5	-2.9	—	
		3V	V _{OH} = 0.9V _{DD} ,	-1.3	-2.5	—	
		5V	SLEDCn[m+1:m] = 01, (n = 0, 1, m = 0, 2, 4 or 6)	-2.5	-5.1	—	
		3V	V _{OH} = 0.9V _{DD} ,	-1.8	-3.6	—	
		5V	SLEDCn[m+1:m] = 10, (n = 0, 1, m = 0, 2, 4 or 6)	-3.6	-7.3	—	
		3V	V _{OH} = 0.9V _{DD} ,	-4	-8	—	
		5V	SLEDCn[m+1:m] = 11, (n = 0, 1, m = 0, 2, 4 or 6)	-8	-16	—	
R _{PH}	I/O 口上拉电阻 (注)	3V	—	20	60	100	kΩ
		5V	—	10	30	50	
I _{LEAK}	输入漏电流	3V	V _{IN} = V _{DD} or V _{IN} = V _{SS}	—	—	±1	μA
		5V		—	—	±1	
t _{TCK}	TM 时钟输入最小脉宽	—	—	0.3	—	—	μs
t _{INT}	中断引脚最小输入脉宽	—	—	10	—	—	μs

注: R_{PH} 内部上拉电阻值的计算方法是: 将其接地并使能输入引脚的上拉电阻选项, 然后在特定电源电压下测量输入灌电流, 用此电压值除此测得的电流值得到此上拉电阻阻值。

存储器电气特性

T_a = -40°C ~ 85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{RW}	存储器读 / 写工作电压	—	—	V _{DDmin}	—	V _{DDmax}	V
Flash ROM / EEPROM 存储器							
t _{DEW}	擦除 / 写周期时间	—	—	2.2	2.5	2.8	ms
I _{DDPGM}	V _{DD} 电压下烧录 / 擦除电流	—	—	—	—	5.0	mA
E _P	最小擦除 / 写次数 - Flash ROM	—	—	10K	—	—	E/W
	最小擦除 / 写次数 - EEPROM 存储器	—	—	100K	—	—	
t _{RETD}	ROM 数据保存时间	—	T _a = 25°C	—	40	—	Year
RAM 数据存储器							
V _{DR}	RAM 数据保存电压	—	单片机处于休眠模式	1.0	—	—	V

LDO+PGA+ADC+VCM 电气特性

 $V_{DD}=V_{IN}, T_a=25^{\circ}\text{C}$

LDO + VCM 测试条件: MCU 进入 SLEEP 模式, 其它功能除能

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V_{DD}	条件				
V_{IN}	LDO 输入电压	—	—	2.6	—	5.5	V
I_Q	LDO 静态电流	—	LDOVS[1:0]=00B, $V_{IN}=3.6\text{V}$, 无负载	—	400	520	μA
V_{OUT_LDO}	LDO 输出电压	—	LDOVS[1:0]=00B, $V_{IN}=3.6\text{V}$, $I_{LOAD}=0.1\text{mA}$	-5%	2.4	+5%	V
			LDOVS[1:0]=01B, $V_{IN}=3.6\text{V}$, $I_{LOAD}=0.1\text{mA}$		2.6		
			LDOVS[1:0]=10B, $V_{IN}=3.6\text{V}$, $I_{LOAD}=0.1\text{mA}$		2.9		
			LDOVS[1:0]=11B, $V_{IN}=3.6\text{V}$, $I_{LOAD}=0.1\text{mA}$		3.3		
ΔV_{LOAD}	LDO 负载调整率 (注1)	—	LDOVS[1:0]=00B, $V_{IN}=V_{OUT_LDO}+0.2\text{V}$, $0\text{mA}\leq I_{LOAD}\leq 10\text{mA}$	—	0.105	0.21	%/mA
V_{DROP_LDO}	LDO 压降 (注2)	—	LDOVS[1:0]=00B, $V_{IN}=3.6\text{V}$, $I_{LOAD}=10\text{mA}$, $\Delta V_{OUT_LDO}=2\%$	—	—	100	mV
			LDOVS[1:0]=01B, $V_{IN}=3.6\text{V}$, $I_{LOAD}=10\text{mA}$, $\Delta V_{OUT_LDO}=2\%$	—	—	130	
			LDOVS[1:0]=10B, $V_{IN}=3.6\text{V}$, $I_{LOAD}=10\text{mA}$, $\Delta V_{OUT_LDO}=2\%$	—	—	180	
			LDOVS[1:0]=11B, $V_{IN}=3.6\text{V}$, $I_{LOAD}=10\text{mA}$, $\Delta V_{OUT_LDO}=2\%$	—	—	200	
TC_{LDO}	LDO 温度系数	—	$T_a=-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$, LDOVS[1:0]=00B, $V_{IN}=3.6\text{V}$, $I_{LOAD}=100\mu\text{A}$	—	—	0.48	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$
ΔV_{LINE_LDO}	LDO 线性调整率	—	LDOVS[1:0]=00B, $2.6\text{V}\leq V_{IN}\leq 5.5\text{V}$, $I_{LOAD}=100\mu\text{A}$	—	—	0.3	%/V
V_{OUT_VCM}	VCM 输出电压	—	$VCMS=0$, $V_{OREG}=3.3\text{V}$, 无负载	-5%	1.05	+5%	V
		—	$VCMS=1$, $V_{OREG}=3.3\text{V}$, 无负载	-5%	1.25	+5%	
TC_{VCM}	VCM 温度系数	—	$T_a=-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$, $VCMS=1$, $V_{OREG}=3.3\text{V}$, $I_{LOAD}=10\mu\text{A}$	—	—	0.24	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$
ΔV_{LINE_VCM}	VCM 线性调整率	—	$VCMS=1$, 无负载 $2.4\text{V}\leq V_{OREG}\leq 3.3\text{V}$,	—	—	0.3	%/V
t_{VCMs}	VCM 开启稳定时间	—	$VCMS=1$, $V_{OREG}=3.3\text{V}$, 无负载	—	—	10	ms
I_{OH}	VCM 输出引脚源电流	—	$VCMS=1$, $V_{OREG}=3.3\text{V}$, $\Delta V_{OUT_VCM}=-2\%$	1	—	—	mA

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{OL}	VCM 输出引脚灌电流	—	VCMS=1, V _{OREG} =3.3V, ΔV _{OUT_VCM} =+2%	1	—	—	mA
ADC & ADC 内部参考电压 (Delta Sigma ADC)							
V _{OREG}	VCM、ADC 和 PGA 的电源电压	—	LDOEN=0	2.4	—	3.3	V
		—	LDOEN=1	2.4	—	3.3	
V _{CM_ADC}	共模电压范围	—	VCMEN = 0	1.05	—	1.25	V
		—	VCMEN = 1	1.05	—	1.25	
I _{ADC}	ADC 使能的额外电流	—	VCM 使能, VRBUFP=1, VRBUFN=1	—	750	900	μA
		—	VCM 使能, VRBUFP=0, VRBUFN=0	—	600	750	μA
		—	VCM 除能, VRBUFP=0, VRBUFN=0	—	500	650	μA
I _{ADSTB}	待机电流	—	MCU 进入 SLEEP 模式, 无负载	—	—	1	μA
N _R	分辨率	—	—	—	—	24	Bit
INL	非线性积分误差	—	V _{OREG} =3.3V, V _{REF} =1.25V, ΔSI=±450mV, PGA gain=1	—	±50	±200	ppm
NFB	无噪音位	—	PGA gain=128 数据传输速率 = 10Hz	—	15.4	—	Bit
ENOB	有效位数	—	PGA gain=128 数据传输速率 = 10Hz	—	18.1	—	Bit
f _{ADCK}	ADC 时钟频率	—	—	40	409.6	440	kHz
f _{ADO}	ADC 输出数据传输速率	—	f _{MCLK} =4MHz, FLMS[2:0]=000B	4	—	521	Hz
		—	f _{MCLK} =4MHz, FLMS[2:0]=010B	10	—	1302	Hz
V _{REFP}	参考输入电压	—	VGS[1:0]=00B, VREFS=1, VRBUFP=0, VRBUFN=0	0.96	1.25	2.2	V
V _{REFN}		—	—	0	0	1.0	V
V _{REF}		—	VGS[1:0]=00B, V _{REF} =V _{REFP} -V _{REFN}	0.96	1.25	1.44	V
PGA							
V _{CM_PGA}	共模电压范围	—	—	0.4	—	V _{OREG} -1.1	V
ΔD _I	差分输入电压范围	—	Gain=PGS×AGS	-V _{REF} /Gain	—	+V _{REF} /Gain	V
温度传感器							
TC _{TS}	温度传感器的温度系数	—	T _a =-40°C~85°C, V _{REF} =1.25V, VGS[1:0]=00B (Gain=1), VRBUFP=0, VRBUFN=0	—	175	—	μV/°C
D/A 转换器							
V _{DACO}	输出电压范围	—	—	V _{SS}	—	V _{REF}	V
V _{REF}	参考电压	—	—	1.05	—	V _{DD}	V

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{DAC}	DAC 使能的额外电流	—	V _{REF} =5V	—	—	450	μA
DNL	非线性微分误差	—	2.4V≤V _{DD} ≤5.5V	—	—	±4	LSB
INL	非线性积分误差	—	2.4V≤V _{DD} ≤5.5V	—	—	±8	LSB

注：1. 负载调整率是在恒结温条件下使用一个低 ON 时间的脉冲测得，测量时确保达到最大的功耗。功耗由输入 / 输出差分电压和输出电流决定。确保的最大功耗不允许超出全输入 / 输出范围。任何环境温度下的最大可允许功耗为 $P_D=(T_{J(MAX)}-T_a)/\theta_{JA}$ 。

2. 压降的定义：是指将输出电压维持在 2% 以内所需的输入电压 V_{IN} 与输出电压 V_{OUT} 的差值。

有效位数 (ENOB)

V_{OREG}=3.3V, V_{REF}=1.25V, FLMS[2:0]=000

数据率 (SPS)	PGA 增益							
	1	2	4	8	16	32	64	128
5	19.7	19.8	19.6	19.7	19.7	19.6	19.2	18.6
10	19.4	19.3	19.3	19.3	19.3	19.1	18.7	18.1
20	19.0	18.8	18.7	18.9	18.8	18.6	18.2	17.5
40	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3	18.1	17.7	17.0
80	18.1	17.9	18.0	17.9	17.9	17.6	17.2	16.5
160	17.6	17.4	17.4	17.4	17.3	17.1	16.6	15.9
320	15.8	15.8	15.9	15.8	15.9	15.9	15.8	15.3
640	14.1	14.0	14.0	14.1	14.1	14.0	14.1	14.4

有效位数 (ENOB)

V_{OREG}=3.3V, V_{REF}=1.25V, FLMS[2:0]=010

数据率 (SPS)	PGA 增益							
	1	2	4	8	16	32	64	128
12.5	19.4	18.8	18.7	18.8	18.8	18.7	18.9	18.1
25	19.0	18.3	18.3	18.3	18.3	18.2	17.9	17.3
50	18.5	17.8	17.8	17.8	17.9	17.7	17.4	16.8
100	18.2	18.2	18.1	18.2	18.1	17.8	17.2	16.4
200	17.9	17.8	17.8	17.8	17.6	17.3	16.7	15.9
400	17.4	17.2	17.2	17.2	17.1	16.8	16.2	15.4
800	16.2	16.1	16.1	16.1	16.1	15.9	15.5	14.8
1600	14.5	14.5	14.5	14.4	14.5	14.5	14.3	14.0

LVD / LVR 电气特性

Ta=25°C

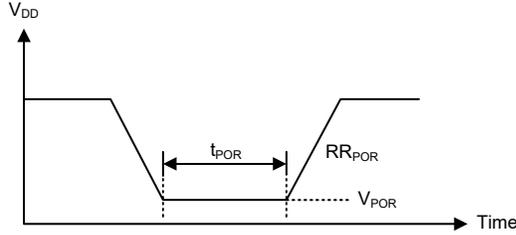
符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{DD}	工作电压	—	—	2.2	—	5.5	V
V _{LVR}	低电压复位电压	—	LVR 使能, 电压选择 2.1V	-5%	2.1	+5%	V
			LVR 使能, 电压选择 2.55V		2.55		
			LVR 使能, 电压选择 3.15V		3.15		
			LVR 使能, 电压选择 3.8V		3.8		
V _{LVD}	低电压检测电压	—	LVD 使能, 电压选择 1.04V	-10%	1.04	+10%	V
			LVD 使能, 电压选择 2.2V		2.2		
			LVD 使能, 电压选择 2.4V	2.4			
			LVD 使能, 电压选择 2.7V	2.7			
			LVD 使能, 电压选择 3.0V	-5%	3.0	+5%	
			LVD 使能, 电压选择 3.3V		3.3		
			LVD 使能, 电压选择 3.6V		3.6		
I _{LVRLVDBG}	工作电流	—	LVD 使能, LVR 使能, VBGEN=0	—	—	18	μA
			5V		20	25	
			LVD 使能, LVR 使能, VBGEN=1	—	—	150	μA
			5V		25	30	
I _{LVR}	使用 LVR 的额外功耗	—	LVD 除能, VBGEN=0	—	—	24	μA
I _{LVD}	使用 LVD 的额外功耗	—	LVR 除能, VBGEN=0	—	—	24	μA
I _{BG}	使用 V _{BG} 的额外电流	—	LVR disable, LVD disable	—	—	180	μA
t _{LVDS}	LVDO 稳定时间	—	LVR 使能, VBGEN=0, LVD off → on	—	—	15	μs
			LVR 除能, VBGEN=0, LVD off → on	—	—	150	μs
t _{LVR}	复位最小低电压保持时间	—	—	120	240	480	μs
t _{LVD}	中断最小低电压保持时间	—	—	60	120	240	μs

注：当选择 V_{LVD}=1.04V 时，用于监测 LVDIN 引脚输入电压是否低于 1.04V。其它 V_{LVD} 选项用于监测电源电压 V_{DD}。

上电复位特性

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{POR}	上电复位电压	—	—	—	—	100	mV
RR _{POR}	上电复位电压速率	—	—	0.035	—	—	V/ms
t _{POR}	V _{DD} 保持为 V _{POR} 的最小时间	—	—	1	—	—	ms

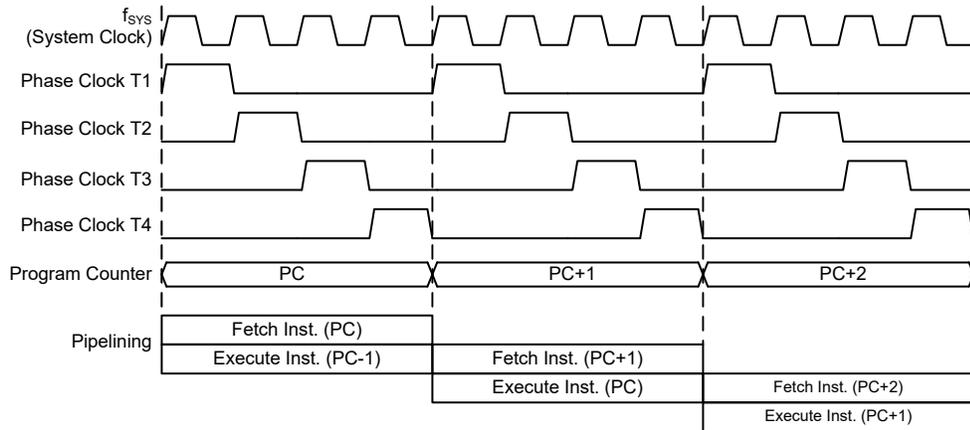


系统结构

内部系统结构是 Holtek 单片机具有良好性能的主要因素。由于采用 RISC 结构，此单片机具有高运算速度和高性能的特点。通过流水线的方式，指令的取得和执行同时进行，此举使得除了跳转和调用指令外，其它指令都能在一个指令周期内完成。8 位 ALU 参与指令集中所有的运算，它可完成算术运算、逻辑运算、移位、递增、递减和分支等功能，而内部的数据路径则是以通过累加器和 ALU 的方式加以简化。有些寄存器在数据存储中被实现，且可以直接或间接寻址。简单的寄存器寻址方式和结构特性，确保了在提供具有最大可靠性和灵活性的 I/O 和 A/D 控制系统时，仅需要少数的外部器件。使得这些单片机适用于低成本和批量生产的控制应用。

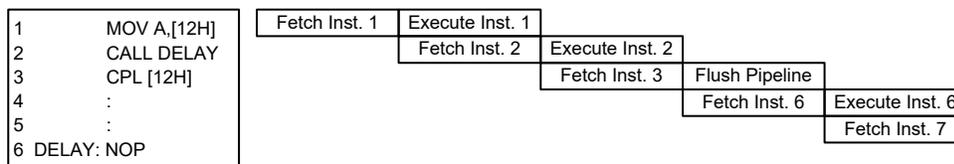
时序和流水线结构

主系统时钟由 HIRC 或 LIRC 振荡器提供，它被细分为 T1~T4 四个内部产生的非重叠时序。在 T1 时间，程序计数器自动加一并抓取一条新的指令。剩下的时间 T2~T4 完成译码和执行功能，因此，一个 T1~T4 时钟周期构成一个指令周期。虽然指令的抓取和执行发生在连续的指令周期，但单片机流水线结构会保证指令在一个指令周期内被有效执行。除非程序计数器的内容被改变，如子程序的调用或跳转，在这种情况下指令将需要多一个指令周期的时间去执行。



系统时序和流水线

如果指令牵涉到分支，例如跳转或调用等指令，则需要两个指令周期才能完成指令执行。需要一个额外周期的原因是程序先用一个周期取出实际要跳转或调用的地址，再用另一个周期去实际执行分支动作，因此用户需要特别考虑额外周期的问题，尤其是在执行时间要求较严格的时候。



指令捕捉

程序计数器

在程序执行期间，程序计数器用来指向下一个要执行的指令地址。除了“JMP”和“CALL”指令需要跳转到一个非连续的程序存储器地址之外，它会在每条指令执行完成以后自动加一。只有较低的 8 位，即所谓的程序计数器低字节寄存器 PCL，可以被用户直接读写。

当执行的指令要求跳转到不连续的地址时，如跳转指令、子程序调用、中断或复位等，单片机通过加载所需要的地址到程序寄存器来控制程序，对于条件跳转指令，一旦条件符合，在当前指令执行时取得的下一条指令将会被舍弃，而由一个空指令周期来取代。

程序计数器	
程序计数器高字节	PCL 寄存器
PC10~PC8	PCL7~PCL0

程序计数器

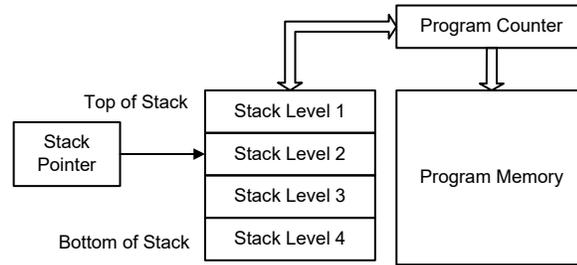
程序计数器的低字节，即程序计数器的低字节寄存器 PCL，可以通过程序控制，且它是可以读取和写入的寄存器。通过直接写入数据到这个寄存器，一个程序短跳转可直接执行，然而只有低字节的操作是有效的，跳转被限制在存储器的当前页中，即 256 个存储器地址范围内，当这样一个程序跳转要执行时，会插入一个空指令周期。PCL 的使用可能引起程序跳转，因此需要额外的指令周期。

堆栈

堆栈是一个特殊的存储空间，用来存储程序计数器中的内容。该单片机有 4 层堆栈，堆栈既不是数据部分也不是程序空间部分，而且它既不是可读取也不是可写入的。当前层由堆栈指针 (SP) 加以指示，同样也是不可读写的。在子程序调用或中断响应服务时，程序计数器的内容被压入到堆栈中。当子程序或中断响应结束时，返回指令 (RET 或 RETI) 使程序计数器从堆栈中重新得到它以前的值。当一个芯片复位后，堆栈指针将指向堆栈顶部。

如果堆栈已满，且有非屏蔽的中断发生，中断请求标志会被置位，但中断响应将被禁止。当堆栈指针减少 (执行 RET 或 RETI)，中断将被响应。这个特性提供程序设计者简单的方法来预防堆栈溢出。然而即使堆栈已满，CALL 指令仍然可以被执行，而造成堆栈溢出。使用时应避免堆栈溢出的情况发生，因为这可能导致不可预期的程序分支指令执行错误。

若堆栈溢出，则首个存入堆栈的程序计数器数据将会丢失。



算术逻辑单元 – ALU

算术逻辑单元是单片机中很重要的部分，执行指令集中的算术和逻辑运算。ALU 连接到单片机的数据总线，在接收相关的指令码后执行需要的算术与逻辑操作，并将结果存储在指定的寄存器，当 ALU 计算或操作时，可能导致进位、借位或其它状态的变化，而相关的状态寄存器会因此更新内容以显示这些改变，ALU 所提供的功能如下：

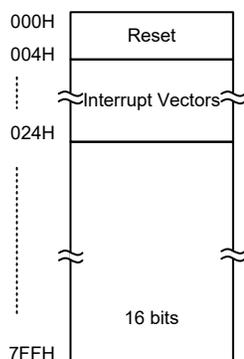
- 算术运算：
ADD, ADDM, ADC, ADCM, SUB, SUBM, SBC, SBCM, DAA
- 逻辑运算：
AND, OR, XOR, ANDM, ORM, XORM, CPL, CPLA
- 移位运算：
RRA, RR, RRCA, RRC, RLA, RL, RLCA, RLC
- 递增和递减：
INCA, INC, DECA, DEC
- 分支判断：
JMP, SZ, SZA, SNZ, SIZ, SDZ, SIZA, SDZA, CALL, RET, RETI

Flash 程序存储器

程序存储器用来存放用户代码即储存程序。程序存储器为 Flash 类型意味着可以多次重复编程，方便用户使用同一芯片进行程序的修改。使用适当的单片机编程工具，此单片机提供用户灵活便利的调试方法和项目开发规划及更新。

结构

程序存储器的容量为 $2K \times 16$ 位，程序存储器用程序计数器来寻址，其中也包含数据、表格和中断入口。数据表格可以设定在程序存储器的任何地址，由表格指针来寻址。



程序存储器结构

特殊向量

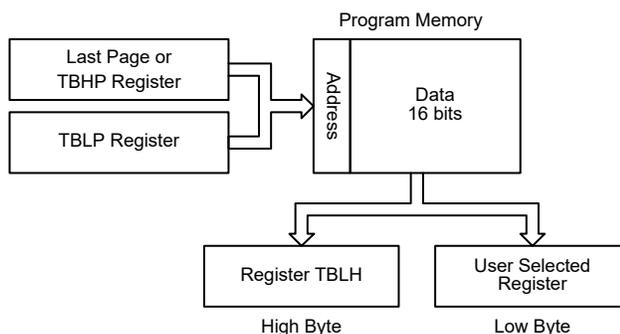
程序存储器内部某些地址保留用做诸如复位和中断入口等特殊用途。地址 000H 是芯片复位后的程序起始地址。在芯片复位之后，程序将跳到这个地址并开始执行。

查表

程序存储器中的任何地址都可以定义成一个表格，以便储存固定的数据。使用表格时，表格指针必须先行设定，其方式是将表格的地址放在表格指针寄存器 TBLP 和 TBHP 中。这些寄存器定义表格总的地址。

在设定完表格指针后，表格数据可以使用“TABRD [m]”或“TABRDL [m]”指令分别从程序存储器查表读取。当这些指令执行时，程序存储器中表格数据低字节，将被传送到使用者所指定的数据存储器 [m]，程序存储器中表格数据的高字节，则被传送到 TBLH 特殊寄存器。

下图是查表中寻址 / 数据流程：



查表范例

以下范例说明表格指针和表格数据如何被定义和执行。这个例子使用的表格数据用 ORG 伪指令储存在存储器中。ORG 指令的值“700H”指向的地址是单片机 2K 程序存储器中最后一页的起始地址。表格指针低字节寄存器的初始值设为 06H，这可保证从数据表格读取的第一笔数据位于程序存储器地址 706H，即最后一页起始地址后的第六个地址。值得注意的是，假如“TABRD [m]”指令被使用，则表格指针指向 TBHP 和 TBLP 指定的地址。在这个例子中，表格数据的高字节等于零，而当“TABRD [m]”指令被执行时，此值将会自动的被传送到 TBLH 寄存器。

TBLH 寄存器为只读寄存器，不能重新储存，若主程序和中断服务程序都使用表格读取指令，应该注意它的保护。使用表格读取指令，中断服务程序可能会改变 TBLH 的值，若随后在主程序中再次使用这个值，则会发生错误，因此建议避免同时使用表格读取指令。然而在某些情况下，如果同时使用表格读取指令是不可避免的，则在执行任何主程序的表格读取指令前，中断应该先除能，另外要注意的是所有与表格相关的指令，都需要两个指令周期去完成操作。

表格读取程序举例

```

tempreg1 db ?      ; temporary register #1
tempreg2 db ?      ; temporary register #2
:
:
mov a,06h          ; initialise low table pointer - note that this address
                  ; is referenced
mov tblp,a         ; to the last page or the page that tbhp pointed
mov a,07h          ; initialise high table pointer
mov tbhp,a
:
:
tabrd tempreg1     ; transfers value in table referenced by table pointer
                  ; data at program memory address "706H" transferred to
                  ; tempreg1 and TBLH
dec tblp           ; reduce value of table pointer by one
tabrd tempreg2     ; transfers value in table referenced by table pointer
                  ; data at program memory address "705H" transferred to
                  ; tempreg2 and TBLH in this example the data "1AH" is
                  ; transferred to tempreg1 and data "0FH" to register
                  ; tempreg2
:
:
org 0700h          ; sets initial address of program memory
dc 00Ah, 00Bh, 00Ch, 00Dh, 00Eh, 00Fh, 01Ah, 01Bh
:
:

```

在线烧录 – ICP

Flash 型程序存储器提供用户便利地对同一芯片进行程序的更新和修改。

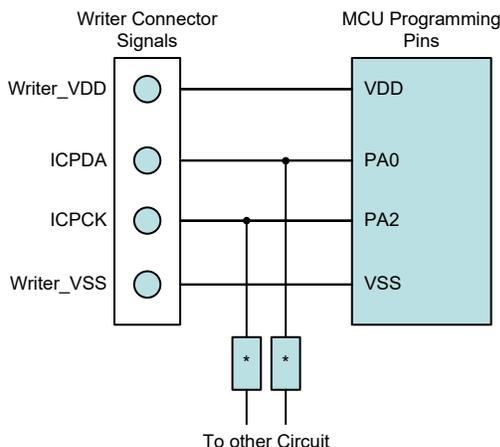
另外，Holtek 单片机提供 4 线接口的在线烧录方式。用户可将进行过烧录或未经过烧录的单片机芯片连同电路板一起制成，最后阶段进行程序的更新和程序的烧写，在无需去除或重新插入芯片的情况下方便地保持程序为最新版。

Holtek Flash MCU 与烧录器引脚对应表如下：

Holtek 烧录器引脚名称	MCU 在线烧录引脚名称	功能
ICPDA	PA0	串行数据 / 地址烧录
ICPCK	PA2	串行时钟
VDD	VDD	电源
VSS	VSS	地

芯片内部程序存储器可以通过 4 线的接口在线进行烧录。其中 PA0 用于数据串行下载或上传，PA2 用于串行时钟，两条用于提供电源。芯片在线烧写的详细使用说明超出此文档的描述范围，将由专门的参考文献提供。

在烧录过程中，烧录器会控制 ICPDA 和 ICPCK 脚进行数据和时钟烧录，用户必须确保这两个引脚没有连接至其它输出脚。



注：* 可能为电阻或电容。若为电阻则其值必须大于 1kΩ，若为电容则其必须小于 1nF。

片上调试 – OCDS

EV 芯片 BH66V5233 用于 BH66F5233 单片机仿真。此 EV 芯片提供片上调试功能 (OCDS—On-Chip Debug Support) 用于开发过程中的单片机调试。除了片上调试功能方面，EV 芯片和实际单片机在功能上几乎是兼容的。用户可将 OCSDA 和 OCDSCK 引脚连接至 Holtek HT-IDE 开发工具，从而实现 EV 芯片对实际单片机的仿真。OCSDA 引脚为 OCDS 数据 / 地址输入 / 输出脚，OCDSCK 引脚为 OCDS 时钟输入脚。当用户用 EV 芯片进行调试时，实际单片机 OCSDA 和 OCDSCK 引脚上的其它共用功能无效。由于这两个 OCDS 引脚与 ICP 引脚共用，因此在线烧录时仍用作 Flash 存储器烧录引脚。关于 OCDS 功能的详细描述，请参考“Holtek e-Link for 8-bit MCU OCDS User's Guide”文件。

Holtek e-Link 引脚名称	EV 芯片引脚名称	功能
OCSDA	OCSDA	片上调试串行数据 / 地址输入 / 输出
OCDSCK	OCDSCK	片上调试时钟输入
VDD	VDD	电源
VSS	VSS	地

数据存储器

数据存储器是内容可更改的 8 位 RAM 内部存储器，用来储存临时数据。

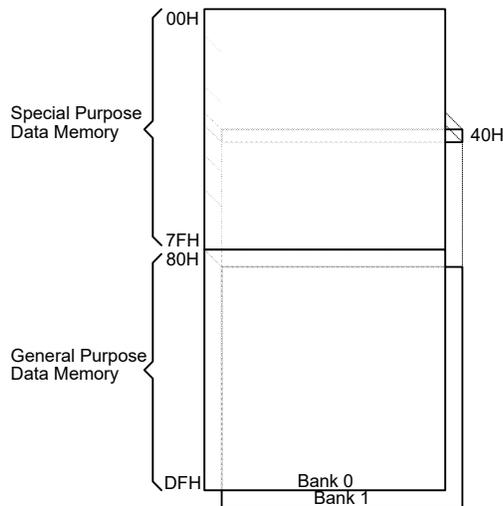
结构

数据存储器分为两个部分，第一部分是特殊功能数据存储器。这些寄存器有固定的地址且与单片机的正确操作密切相关。大多特殊功能寄存器都可在程序控制下直接读取和写入，但有些被加以保护而不对用户开放。第二部分数据存储器是做一般用途使用，都可在程序控制下进行读取和写入。

总的存储器被分为两个 Bank。特殊功能数据存储器地址范围为 Bank 0 的 00H~7FH，处于“40H”地址的 EEC 寄存器却只能在 Bank 1 中被访问到。切换不同区域可通过设置区域指针 (BP) 实现。单片机数据存储器的起始地址是“00H”。

特殊功能数据存储器		通用数据存储器	
有效 Banks	Banks	容量	Banks
0,1	Bank 0: 00H~7FH Bank 1: 40H (EEC)	96× 8	Bank 0: 80H~DFH

数据存储器概要



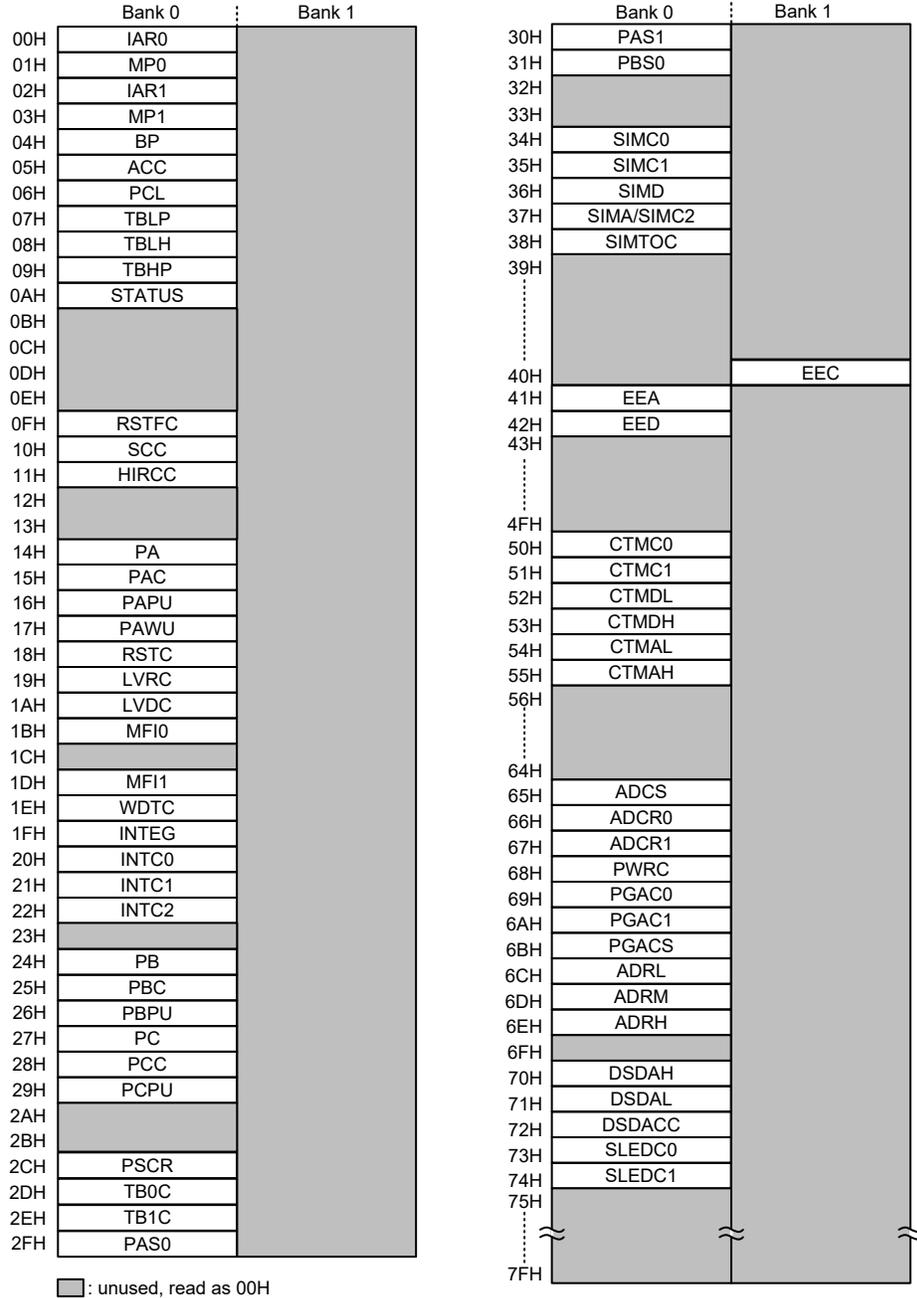
数据存储器结构

通用数据存储器

所有的单片机程序需要一个读 / 写的存储区，让临时数据可以被储存和再使用，该 RAM 区域就是通用数据存储器。这个数据存储区可让使用者进行读取和写入的操作。使用位操作指令可对个别的位做置位或复位的操作，极大地方便了用户在数据存储器内进行位操作。

特殊功能数据存储单元

这个区域的数据存储器是存放特殊寄存器的，这些寄存器与单片机的正确操作密切相关，大多数的寄存器可进行读取和写入，只有一些是被写保护而只能读取的，相关细节的介绍请参看有关特殊功能寄存器的部分。要注意的是，任何读取指令对存储器中未定义的地址进行读取将返回“00H”。



特殊功能数据存储单元结构

特殊功能寄存器

大部分特殊功能寄存器的细节将在相关功能章节描述，但有几个寄存器需在此章节单独描述。

间接寻址寄存器 – IAR0, IAR1

间接寻址寄存器 IAR0 和 IAR1 的地址虽位于数据存储区，但其并没有实际的物理地址。间接寻址的方法准许使用存储器指针做数据操作，以取代定义实际存储器地址的直接存储器寻址方法。在间接寻址寄存器 IAR0 和 IAR1 上的任何动作，将对存储器指针 MP0 和 MP1 所指定的存储器地址产生对应的读 / 写操作。它们总是成对出现，IAR0 和 MP0 只可以访问 Bank 0，而 IAR1 和 MP1 可以访问所有 Bank。因为这些间接寻址寄存器不是实际存在的，直接读取将返回“00H”的结果，而直接写入此寄存器则不做任何操作。

存储器指针 – MP0, MP1

该单片机提供两个存储器指针，即 MP0 和 MP1。由于这些指针在数据存储区中能像普通的寄存器一般被操作，因此提供了一个寻址和数据追踪的有效方法。当对间接寻址寄存器进行任何操作时，单片机指向的实际地址是由存储器指针所指定的地址。MP0、IAR0 用于访问 Bank 0，而 MP1 和 IAR1 可通过 BP 寄存器访问所有的 Bank。直接寻址仅可以用在 Bank 0 中，所有 Bank 都可使用 MP1 和 IAR1 进行间接寻址。

以下例子说明如何清除一个具有 4 RAM 地址的区块，它们已事先定义成地址 adres1 到 adres4。

间接寻址程序举例

```
data .section 'data'
adres1 db ?
adres2 db ?
adres3 db ?
adres4 db ?
block db ?
code .section at 0 'code'
org 00h
start:
mov a,04h                ; setup size of block
mov block,a
mov a,offset adres1     ; Accumulator loaded with first RAM address
mov mp0,a               ; setup memory pointer with first RAM address
loop:
clr IAR0                ; clear the data at address defined by MP0
inc mp0                 ; increment memory pointer
sdz block               ; check if last memory location has been cleared
jmp loop
continue:
:
```

在上面的例子中有一点值得注意，即并没有确定 RAM 地址。

存储区指针 – BP

数据存储器被分为两个部分，即 Bank 0 和 Bank 1。可以通过设置存储区指针 (Bank Pointer) 值来访问不同的数据存储器。BP 指针的第 0 位用于选择数据存储器的 Bank 0 或 Bank 1。

复位后，数据存储器会初始化到 Bank 0，但是在休眠模式或空闲模式下的 WDT 溢出复位，选择的数据存储器 Bank 不会改变。应该注意的是特殊功能数据存储器不受存储区的影响，也就是说，不论是在哪一个存储区，都能对特殊功能寄存器进行读写操作。数据存储器的直接寻址总是访问 Bank 0，不影响存储区指针的值。要访问 Bank 0 之外的存储区，则必须要使用间接寻址方式。

• BP 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	DMBP0
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1 未定义，读为“0”

Bit 0 **DMBP0**: 数据存储器 Bank 选择位

0: Bank 0

1: Bank 1

累加器 – ACC

对任何单片机来说，累加器是相当重要的，且与 ALU 所完成的运算有密切关系，所有 ALU 得到的运算结果都会暂时存在 ACC 累加器里。若没有累加器，ALU 必须在每次进行如加法、减法和移位的运算时，将结果写入到数据存储器，这样会造成程序编写和时间的负担。另外数据传送也常常牵涉到累加器的临时储存功能，例如在使用者定义的一个寄存器和另一个寄存器之间传送数据时，由于两寄存器之间不能直接传送数据，因此必须通过累加器来传送数据。

程序计数器低字节寄存器 – PCL

为了提供额外的程序控制功能，程序计数器低字节设置在数据存储器的特殊功能区域内，程序员可对此寄存器进行操作，很容易的直接跳转到其它程序地址。直接给 PCL 寄存器赋值将导致程序直接跳转到程序存储器的某一地址，然而由于寄存器只有 8 位长度，因此只允许在本页的程序存储器范围内进行跳转，而当使用这种运算时，要注意会插入一个空指令周期。

表格寄存器 – TBLP, TBHP, TBLH

这三个特殊功能寄存器对存储在程序存储器中的表格进行操作。TBLP 和 TBHP 为表格指针，指向表格数据存储的地址。它们的值必须在任何表格读取指令执行前加以设定，由于它们的值可以被如“INC”或“DEC”的指令所改变，这就提供了一种简单的方法对表格数据进行读取。表格读取数据指令执行之后，表格数据高字节存储在 TBLH 中。其中要注意的是，表格数据低字节会被传送到使用者指定的地址。

状态寄存器 – STATUS

这 8 位的状态寄存器由零标志位 (Z)、进位标志位 (C)、辅助进位标志位 (AC)、溢出标志位 (OV)、暂停标志位 (PDF) 和看门狗定时器溢出标志位 (TO) 组成。这些算术 / 逻辑操作和系统运行标志位是用来记录单片机的运行状态。

除了 PDF 和 TO 标志外，状态寄存器中的位像其它大部分寄存器一样可以被改变。任何数据写入到状态寄存器将不会改变 TO 或 PDF 标志位。另外，执行不同的指令后，与状态寄存器有关的运算可能会得到不同的结果。TO 标志位只会受系统上电、看门狗溢出或执行“CLR WDT”或“HALT”指令影响。PDF 标志位只会受执行“HALT”或“CLR WDT”指令或系统上电影响。

Z、OV、AC 和 C 标志位通常反映最近运算的状态。

- C: 当加法运算的结果产生进位，或减法运算的结果没有产生借位时，则 C 被置位，否则 C 被清零，同时 C 也会被带进位的移位指令所影响。
- AC: 当低半字节加法运算的结果产生进位，或低半字节减法运算的结果没有产生借位时，AC 被置位，否则 AC 被清零。
- Z: 当算术或逻辑运算结果是零时，Z 被置位，否则 Z 被清零。
- OV: 当运算结果高两位的进位状态异或结果为 1 时，OV 被置位，否则 OV 被清零。
- PDF: 系统上电或执行“CLR WDT”指令会清零 PDF，而执行“HALT”指令则会置位 PDF。
- TO: 系统上电或执行“CLR WDT”或“HALT”指令会清零 TO，而当 WDT 溢出则会置位 TO。

另外，当进入一个中断程序或执行子程序调用时，状态寄存器不会自动压入到堆栈保存。假如状态寄存器的内容是重要的且子程序可能改变状态寄存器的话，则需谨慎的去做正确的储存。

● STATUS 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	TO	PDF	OV	Z	AC	C
R/W	—	—	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	x	x	x	x

“x”：未知

- Bit 7~6 未定义，读为“0”
- Bit 5 **TO**: 看门狗溢出标志位
0: 系统上电或执行“CLR WDT”或“HALT”指令后
1: 看门狗溢出发生
- Bit 4 **PDF**: 暂停标志位
0: 系统上电或执行“CLR WDT”指令后
1: 执行“HALT”指令
- Bit 3 **OV**: 溢出标志位
0: 无溢出
1: 运算结果高两位的进位状态异或结果为 1
- Bit 2 **Z**: 零标志位
0: 算术或逻辑运算结果不为 0
1: 算术或逻辑运算结果为 0
- Bit 1 **AC**: 辅助进位标志位
0: 无辅助进位
1: 在加法运算中低四位产生了向高四位进位，或减法运算中低四位不发生从高四位借位
- Bit 0 **C**: 进位标志位
0: 无进位
1: 如果在加法运算中结果产生了进位，或在减法运算中结果不发生借位
C 也受循环移位指令的影响。

EEPROM 数据存储

此单片机的一个特性是内建 EEPROM 数据存储。 “Electrically Erasable Programmable Read Only Memory” 为电可擦可编程只读存储器，由于其非易失的存储结构，即使在电源掉电的情况下存储器内的数据仍然保存完好。这种存储区扩展了 ROM 空间，对设计者来说增加了许多新的应用机会。EEPROM 可以用来存储产品编号、校准值、用户特定数据、系统配置参数或其它产品信息等。EEPROM 的数据读取和写入过程也会变的更简单。

EEPROM 数据存储结构

该单片机的 EEPROM 数据存储容量为 32×8 位。由于映射方式与程序存储器和数据存储不同，因此不能像其它类型的存储器一样寻址。使用 Bank 0 中的一个地址和数据寄存器以及 Bank 1 中的一个控制寄存器，可以实现对 EEPROM 的单字节读写操作。

EEPROM 寄存器

有三个寄存器控制内部 EEPROM 数据存储总的操作，地址寄存器 EEA、数据寄存器 EED 及控制寄存器 EEC。EEA 和 EED 位于 Bank 0 中，它们能像其它特殊功能寄存器一样直接被访问。EEC 位于 Bank 1 中，不能被直接访问，仅能通过 MP1 和 IAR1 进行间接读取或写入。由于 EEC 控制寄存器位于 Bank 1 中的“40H”，在 EEC 寄存器上的任何操作被执行前，MP1 必须先设为“40H”，BP 设为“1”。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
EEA	—	—	—	EEA4	EEA3	EEA2	EEA1	EEA0
EED	EED7	EED6	EED5	EED4	EED3	EED2	EED1	EED0
EEC	—	—	—	—	WREN	WR	RDEN	RD

EEPROM 寄存器列表

- EEA 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	EEA4	EEA3	EEA2	EEA1	EEA0
R/W	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	0	0	0	0	0

Bit 7~5 未定义，读为“0”

Bit 4~0 **EEA4~ EEA0**: 数据 EEPROM 地址 Bit 4~Bit 0

- EED 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	EED7	EED6	EED5	EED4	EED3	EED2	EED1	EED0
R/W								
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **EED7~ EED0**: 数据 EEPROM 数据 Bit 7~Bit 0

● EEC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	WREN	WR	RDEN	RD
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3 **WREN**: 数据 EEPROM 写使能位

- 0: 除能
- 1: 使能

此位为数据 EEPROM 写使能位，向数据 EEPROM 写操作之前需将此位置高。将此位清零时，则禁止向数据 EEPROM 写操作。

Bit 2 **WR**: EEPROM 写控制位

- 0: 写周期结束
- 1: 写周期有效

此位为数据 EEPROM 写控制位，由应用程序将此位置高将激活写周期。写周期结束后，硬件自动将此位清零。当 WREN 未先置高时，此位置高无效。

Bit 1 **RDEN**: 数据 EEPROM 读使能位

- 0: 除能
- 1: 使能

此位为数据 EEPROM 读使能位，向数据 EEPROM 读操作之前需将此位置高。将此位清零时，则禁止向数据 EEPROM 读操作。

Bit 0 **RD**: EEPROM 读控制位

- 0: 读周期结束
- 1: 读周期有效

此位为数据 EEPROM 读控制位，由应用程序将此位置高将激活读周期。读周期结束后，硬件自动将此位清零。当 RDEN 未首先置高时，此位置高无效。

注：在同一条指令中 WREN、WR、RDEN 和 RD 不能同时置为“1”。WR 和 RD 不能同时置为“1”。

从 EEPROM 中读取数据

从 EEPROM 中读取数据，EEC 寄存器中的读使能位 RDEN 先置为高以使能读功能，EEPROM 中读取数据的地址要先放入 EEA 寄存器中。若 EEC 寄存器中的 RD 位被置高，一个读周期将开始。若 RD 位已置为高而 RDEN 位还未被设置则不能开始读操作。若读周期结束，RD 位将自动清除为“0”，数据可以从 EED 寄存器中读取。数据在其它读或写操作执行前将一直保留在 EED 寄存器中。应用程序将轮询 RD 位以确定数据可以有效地被读取。

写数据到 EEPROM

写数据至 EEPROM，EEPROM 中写入数据的地址要先放入 EEA 寄存器中，写入的数据需存入 EED 寄存器中。EEC 寄存器中的写使能位 WREN 先置为高以使能写功能，然后 EEC 寄存器中的 WR 位需立即置高以开始写操作，这两条指令必须连续执行。总中断位 EMI 在写周期开始前应当被清零，写周期开始后再将其使能。若 WR 位已置为高而 WREN 位还未被设置则不能开始写操作。由于控制 EEPROM 写周期是一个内部时钟，与单片机的系统时钟异步，所以数据写入 EEPROM 的时间将有所延迟。可通过轮询 EEC 寄存器中的 WR 位或判断 EEPROM 写中断以侦测写周期是否完成。若写周期完成，WR 位将自动清除为“0”，通知用户数据已写入 EEPROM。因此，应用程序将轮询 WR 位以确定写周期是否结束。

写保护

防止误写入的写保护有以下几种。单片机上电后控制寄存器中的写使能位将被清除以杜绝任何写入操作。上电后存储区指针 BP 将重置为 0，这意味着数据存储区 Bank 0 被选中。由于 EEPROM 控制寄存器位于 Bank 1 中，这增加了对写操作的保护措施。在正常程序操作中确保控制寄存器中的写使能位被清除将能防止不正确的写操作。

EEPROM 写中断

EEPROM 写周期结束后将产生 EEPROM 写中断，需先通过设置相关中断寄存器的 DEE 位使能 EEPROM 中断。由于 EEPROM 中断包含在多功能中断中，相应的多功能中断使能位需被设置。当 EEPROM 写周期结束，DEF 请求标志位及其相关多功能中断请求标志位将被置位。若总中断、EEPROM 中断和多功能中断使能且堆栈未满的情况下将跳转到相应的多功能中断向量中执行。当中断被响应，只有多功能中断标志位将自动复位，而 EEPROM 中断标志将通过应用程序手动复位。更多细节将在中断章节讲述。

编程注意事项

必须注意的是数据不会无意写入 EEPROM。在没有写动作时写使能位被正常清零可以增强保护功能。存储器指针 BP 也可以正常清零以阻止进入 EEPROM 控制寄存器存在的 Bank 1。尽管没有必要，写一个简单的读回程序以检查新写入的数据是否正确还是应该考虑的。

WREN 位置位后，EEC 寄存器中的 WR 位需立即置位，以确保写周期正确地执行。写周期执行前总中断位 EMI 应先清零，写周期开始执行后再将此位重新使能。注意，在 EEPROM 读或写操作完全完成之前单片机不能进入空闲或休眠模式，否则会导致 EEPROM 读或写操作失败。

程序举例

从 EEPROM 中读取数据 — 轮询法

```

MOV A, EEPROM_ADRES      ; user defined address
MOV EEA, A
MOV A, 040H               ; setup memory pointer MP1
MOV MP1, A               ; MP1 points to EEC register
MOV A, 01H               ; setup Bank Pointer
MOV BP, A
SET IAR1.1               ; set RDEN bit, enable read operations
SET IAR1.0               ; start Read Cycle - set RD bit
BACK:
SZ IAR1.0                ; check for read cycle end
JMP BACK
CLR IAR1                  ; disable EEPROM write
CLR BP
MOV A, EED                ; move read data to register
MOV READ_DATA, A

```

写数据到 EEPROM — 轮询法

```
MOV A, EEPROM_ADRES      ; user defined address
MOV EEA, A
MOV A, EEPROM_DATA      ; user defined data
MOV EED, A
MOV A, 040H              ; setup memory pointer MP1
MOV MP1, A               ; MP1 points to EEC register
MOV A, 01H               ; setup Bank Pointer
MOV BP, A
CLR EMI
SET IAR1.3                ; set WREN bit, enable write operations
SET IAR1.2                ; start Write Cycle - set WR bit - executed
                           ; immediately after set WREN bit

SET EMI
BACK:
SZ IAR1.2                 ; check for write cycle end
JMP BACK
CLR IAR1                  ; disable EEPROM write
CLR BP
```

振荡器

不同的振荡器选择可以让使用者在不同的应用需求中实现更大范围的功能。振荡器的灵活性使得在速度和功耗方面可以达到最优化。振荡器选择是通过应用程序和相关的控制寄存器共同完成的。

振荡器概述

振荡器除了作为系统时钟源，还作为看门狗定时器和时基功能的时钟源。集成的两个内部振荡器不需要任何外围器件。它们提供的高速和低速系统振荡器具有较宽的频率范围。较高频率的振荡器提供更高的性能，但要求有更高的功率，反之亦然。动态切换快慢系统时钟的能力使单片机具有灵活而优化的性能 / 功耗比，此特性对功耗敏感的应用领域尤为重要。

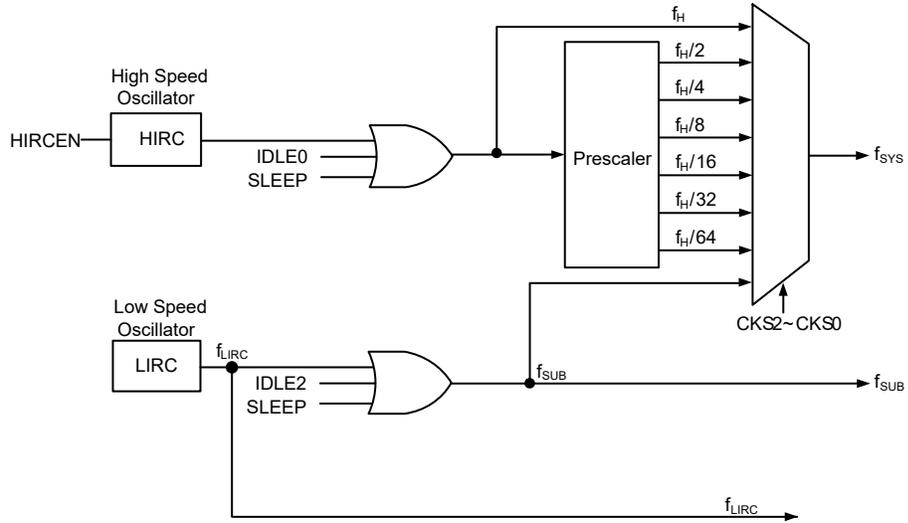
类型	名称	频率
内部高速 RC	HIRC	4/8/12MHz
内部低速 RC	LIRC	32kHz

振荡器类型

系统时钟配置

该单片机有两个系统振荡器，包括一个高速振荡器和一个低速振荡器。高速振荡器为内部 4 /8/12MHz RC 振荡器 – HIRC。低速振荡器为内部 32kHz 振荡器 – LIRC。

低速或高速系统时钟频率由 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位决定的。请注意，两个振荡器必须做出选择，即一个高速和一个低速振荡器。



系统时钟配置

内部高速 RC 振荡器 – HIRC

内部 RC 振荡器是一个集成的系统振荡器，不需其它外部器件。内部 RC 振荡器具有三种固定的频率：4MHz，8MHz，12MHz。芯片在制造时进行调整且内部含有频率补偿电路，使得振荡频率因电源电压、温度以及芯片制成工艺不同的影响减至最低程度。

内部 32kHz 振荡器 – LIRC

内部 32kHz 系统振荡器是一个低频振荡器。它是一个完全集成 RC 振荡器，它在 5V 电压下运行的典型频率值为 32kHz 且无需外部元件。芯片在制造时进行调整且内部含有频率补偿电路，使得振荡器因电源电压、温度及芯片制成工艺不同的影响减至最低。

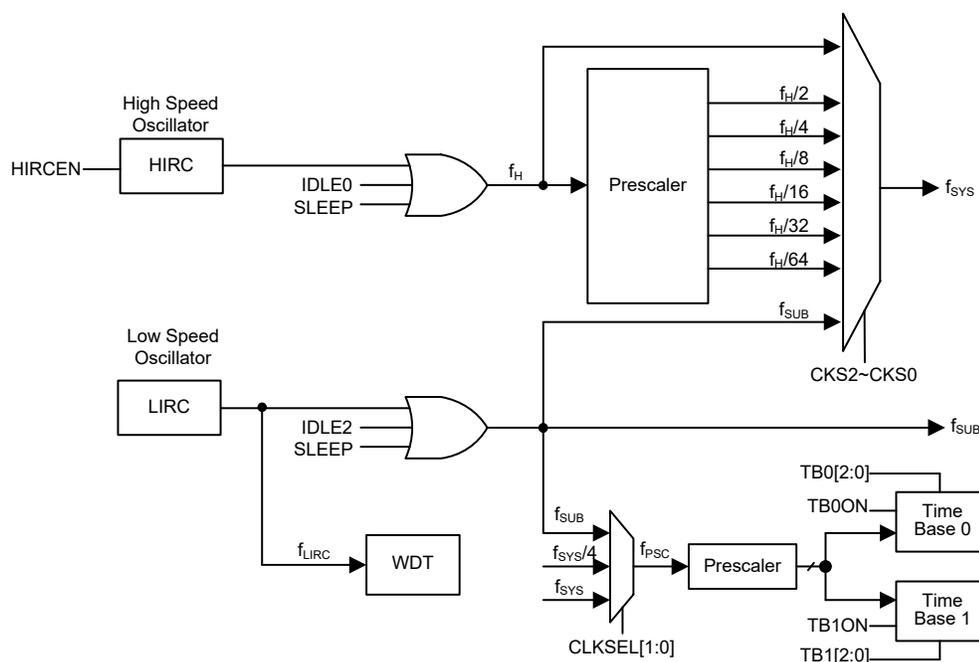
工作模式和系统时钟

现今的应用要求单片机具有较高的性能及尽可能低的功耗，这种矛盾的要求在便携式电池供电的应用领域尤为明显。高性能所需要的高速时钟将增加功耗，反之亦然。此单片机提供高、低速两种时钟源，它们之间可以动态切换，用户可通过优化单片机操作来获得最佳性能 / 功耗比。

系统时钟

单片机为 CPU 和外围功能操作提供了两种不同的时钟源。用户使用寄存器编程可获取多种时钟，进而使系统时钟获取最大的应用性能。

主系统时钟可来自高频时钟源 f_H 或低频时钟源 f_{SUB} ，通过 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位进行选择。高频时钟来自 HIRC 振荡器。低频系统时钟源来自 f_{SUB} ，若 f_{SUB} 被选择，低频时钟来自 LIRC 振荡器。其它系统时钟还有高速系统振荡器的分频 $f_H/2 \sim f_H/64$ 。



单片机时钟配置

注：当系统时钟源 f_{SYS} 由 f_H 到 f_{SUB} 转换时，可以通过设置相应的高速振荡器使能控制位，选择停止以节省耗电，或者继续振荡，为外围电路提供 $f_H \sim f_H/64$ 频率的时钟源。

系统工作模式

单片机有 6 种不同的工作模式，每种有它自身的特性，根据应用中不同的性能和功耗要求可选择不同的工作模式。单片机正常工作有两种模式：快速模式和低速模式。剩余的 4 种工作模式：休眠模式、空闲模式 0、空闲模式 1 和空闲模式 2 用于单片机 CPU 关闭时以节省耗电。

工作模式	CPU	寄存器设置			f _{sys}	f _H	f _{sub}	f _{LIRC}
		FHIDEN	FSIDEN	CKS2~CKS0				
快速模式	On	x	x	000~110	f _H ~f _H /64	On	On	On
低速模式	On	x	x	111	f _{sub}	On/Off ⁽¹⁾	On	On
空闲模式 0	Off	0	1	000~110	Off	Off	On	On
				111	On			
空闲模式 1	Off	1	1	xxx	On	On	On	On
空闲模式 2	Off	1	0	000~110	On	On	Off	On
				111	Off			
休眠模式	Off	0	0	xxx	Off	Off	Off	On/Off ⁽²⁾

“x”：无关

- 注：1. 在低速模式中，f_H 开启或关闭由相应的振荡器使能位控制。
2. 在休眠模式中，f_{LIRC} 开启或关闭由 WDT 功能使能或除能控制。

快速模式

顾名思义，这是主要的工作模式之一，单片机的所有功能均可在此模式中实现且系统时钟由一个高速振荡器提供。该模式下单片机正常工作的时钟源来自 HIRC 振荡器。高速振荡器频率可被分为 1~64 的不等比率，实际的比率由 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位选择。单片机使用高速振荡器分频作为系统时钟可减少工作电流。

低速模式

此模式的系统时钟虽为较低速时钟源，但单片机仍能正常工作。该低速时钟源可来自 f_{sub}，而 f_{sub} 可来自于 LIRC 振荡器。

休眠模式

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为低时，系统进入休眠模式。在休眠模式中，CPU 停止运行，f_{sub} 停止为外围功能提供时钟。若看门狗定时器功能使能，f_{LIRC} 继续运行。

空闲模式 0

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为低、FSIDEN 位为高时，系统进入空闲模式 0。在空闲模式 0 中，CPU 停止，但低速振荡器会开启以驱动一些外围功能。

空闲模式 1

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为高时，系统进入空闲模式 1。在空闲模式 1 中，CPU 停止，但高速和低速振荡器都会开启以确保一些外围功能继续工作。

空闲模式 2

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为高、FSIDEN 位为低时，系统进入空闲模式 2。在空闲模式 2 中，CPU 停止，但高速振荡器会开启以确保一些外围功能继续工作。

控制寄存器

寄存器 SCC 和 HIRCC 用于控制系统时钟和相应的振荡器配置。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SCC	CKS2	CKS1	CKS0	—	—	—	FHIDEN	FSIDEN
HIRCC	—	—	—	—	HIRC1	HIRC0	HIRCF	HIRCEN

系统工作模式控制寄存器列表

• SCC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	CKS2	CKS1	CKS0	—	—	—	FHIDEN	FSIDEN
R/W	R/W	R/W	R/W	—	—	—	R/W	R/W
POR	0	0	0	—	—	—	0	0

Bit 7~5 **CKS2~CKS0**: 系统时钟选择位

000: f_H
001: $f_H/2$
010: $f_H/4$
011: $f_H/8$
100: $f_H/16$
101: $f_H/32$
110: $f_H/64$
111: f_{SUB}

这三位用于选择系统时钟源。除了 f_H 或 f_{SUB} 提供的系统时钟源外，也可使用高频振荡器的分频作为系统时钟。

Bit 4~2 未定义，读为“0”

Bit 1 **FHIDEN**: CPU 关闭时高频振荡器控制位

0: 除能
1: 使能

此位用来控制在 CPU 执行 HALT 指令关闭后高速振荡器是被激活还是停止。

Bit 0 **FSIDEN**: CPU 关闭时低频振荡器控制位

0: 除能
1: 使能

此位用来控制在 CPU 执行 HALT 指令关闭后低速振荡器是被激活还是停止。无论是 LIRC 被选择作为低速振荡器时钟源还是 WDT 功能使能，LIRC 振荡器都是由该位与 WDT 功能控制位共同控制的。如果该位被清零，但 WDT 功能使能，LIRC 振荡器也将使能。

• HIRCC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	HIRC1	HIRC0	HIRCF	HIRCEN
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	1

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3~2 **HIRC1~HIRC0**: HIRC 频率选择位
 00: 4MHz
 01: 8MHz
 10: 12MHz
 11: 4MHz

当 HIRC 振荡器使能或通过应用程序改变 HIRC 频率选择位时，在 HIRCF 标志位置高后时钟频率会自动改变。

Bit 1 **HIRCF**: HIRC 振荡器稳定标志位
 0: HIRC 未稳定
 1: HIRC 稳定

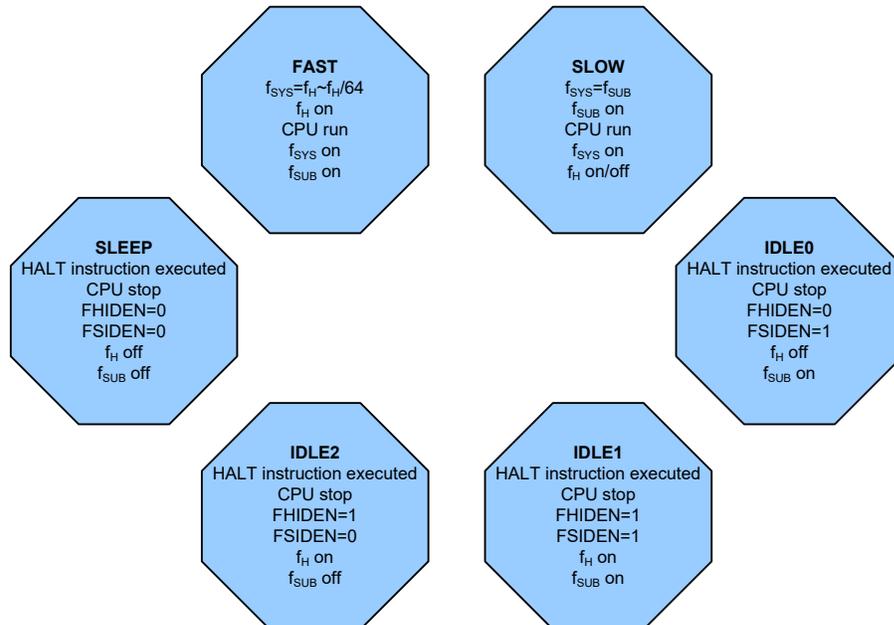
此位用于表明 HIRC 振荡器是否稳定。HIRCEN 位置高使能 HIRC 振荡器，HIRCF 位会先被清零，在 HIRC 稳定后会被置高。

Bit 0 **HIRCEN**: HIRC 振荡器使能控制位
 0: 除能
 1: 使能

工作模式切换

单片机可在各个工作模式间自由切换，使得用户可根据所需选择最佳的性能 / 功耗比。用此方式，对单片机工作的性能要求不高的情况下，可使用较低频时钟以减少工作电流，在便携式应用上延长电池的使用寿命。

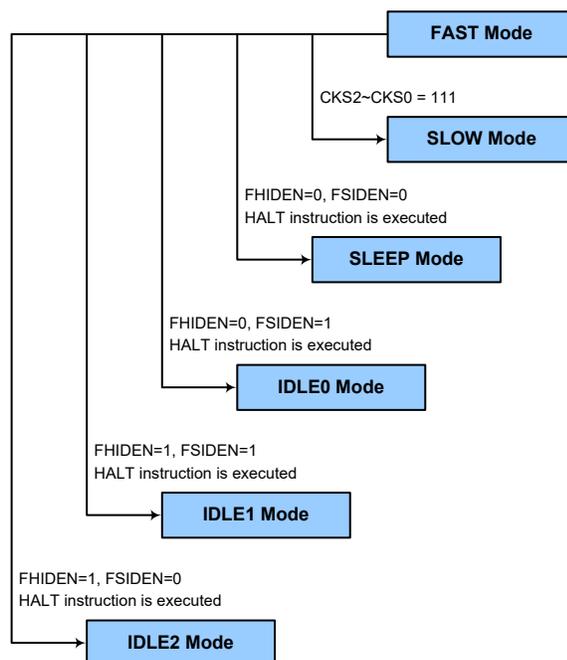
简单来说，快速模式和低速模式间的切换仅需设置 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位即可实现，而快速模式 / 低速模式与休眠模式 / 空闲模式间的切换经由 HALT 指令实现。当 HALT 指令执行后，单片机是否进入空闲模式或休眠模式由 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位决定的。



快速模式切换到低速模式

系统运行在快速模式时使用高速系统振荡器，因此较为耗电。可通过设置 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位为“111”使系统时钟切换至运行在低速模式下。此时将使用低速系统振荡器以节省耗电。用户可在对性能要求不高的操作中使用此方法以减少耗电。

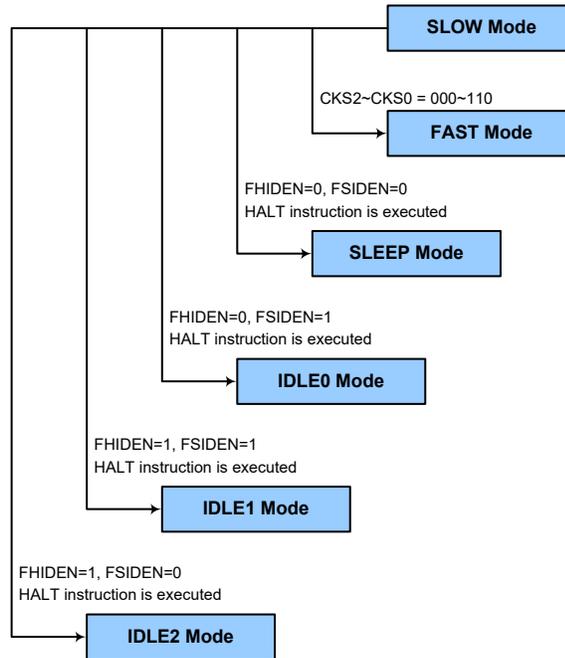
低速模式的时钟源来自 LIRC 振荡器，因此要求这些振荡器在所有模式切换动作发生前稳定下来。



低速模式切换到快速模式

在低速模式时系统时钟来自 f_{SUB} 。切换回快速模式时，需设置 $CKS2 \sim CKS0$ 位为“000”~“110”使系统时钟从 f_{SUB} 切换到 $f_H \sim f_H/64$ 。

然而，如果在低速模式下 f_H 因未使用而关闭，那么从低速模式切换到快速模式时，它需要一定的时间来重新起振和稳定，可通过检测 HIRCC 寄存器中的 HIRCF 位进行判断，所需的高速系统振荡器稳定时间在系统上电时间电气特性中有说明。



进入休眠模式

进入休眠模式的方法仅有一种——应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为“0”。在这种模式下，除了 WDT 以外的所有时钟和功能都将关闭。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- 系统时钟停止运行，应用程序停止在“HALT”指令处。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清除。
- 如果 WDT 功能使能，WDT 将被清零并重新开始计数。如果 WDT 功能除能，WDT 将被清零并停止计数。

进入空闲模式 0

进入空闲模式 0 的方法仅有一种——应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为“0”且 FSIDEN 位为“1”。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- f_H 时钟停止运行，应用程序停止在“HALT”指令处，但 f_{SUB} 时钟将继续运行。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清除。
- 如果 WDT 功能使能，WDT 将被清零并重新开始计数。如果 WDT 功能除能，WDT 将被清零并停止计数。

进入空闲模式 1

进入空闲模式 1 的方法仅有一种——应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为“1”。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- f_H 和 f_{SUB} 时钟开启，应用程序停止在“HALT”指令处。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清除。
- 如果 WDT 功能使能，WDT 将被清零并重新开始计数。如果 WDT 功能除能，WDT 将被清零并停止计数。

进入空闲模式 2

进入空闲模式 2 的方法仅有一种——应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为“1”且 FSIDEN 位为“0”。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- f_H 时钟开启， f_{SUB} 时钟关闭，应用程序停止在“HALT”指令处。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清除。

- 如果 WDT 功能使能，WDT 将被清零并重新开始计数。如果 WDT 功能除能，WDT 将被清零并停止计数。

静态电流的注意事项

由于单片机进入休眠或空闲模式的主要原因是将单片机的电流降低到尽可能低，可能到只有几个微安的级别（空闲模式 1 和空闲模式 2 除外），所以如果要将电路的电流降到最低，电路设计者还应有其它的考虑。应该特别注意的是单片机的输入 / 输出引脚。所有高阻抗输入脚都必须连接到固定的高或低电平，因为引脚浮空会造成内部振荡并导致耗电增加。这也应用于有不同封装的单片机，因为它们可能含有未引出的引脚，这些引脚也必须设为输出或带有上拉电阻的输入。

另外还需注意单片机设为输出的 I/O 引脚上的负载。应将它们设置在有最小拉电流的状态或将它们和其它的 CMOS 输入一样接到没有拉电流的外部电路上。还应注意的，如果选择 LIRC 振荡器，会导致耗电增加。

在空闲模式 1 和空闲模式 2 中，高速振荡器开启。若外围功能时钟源来自高速振荡器，额外的静态电流也可能会有几百微安。

唤醒

单片机进入休眠模式或空闲模式后，系统时钟将停止以降低功耗。然而单片机再次唤醒，原来的系统时钟重新起振、稳定且恢复正常工作需要一定的时间。

系统进入休眠或空闲模式之后，可以通过以下几种方式唤醒：

- PA 口下降沿
- 系统中断
- WDT 溢出

单片机执行 HALT 指令，系统进入省电模式，PDF 将被置位。系统上电或执行清除看门狗的指令，PDF 将被清零。若系统由看门狗定时器溢出唤醒，会发生看门狗定时器复位，TO 将被置位。看门狗定时器溢出将会置位 TO 标志并唤醒系统，这种复位会重置程序计数器和堆栈指针，其它标志保持原有状态。

PA 口中的每个引脚都可以通过 PAWU 寄存器使能下降沿唤醒功能。PA 端口唤醒后，程序将在“HALT”指令后继续执行。如果系统是通过中断唤醒，则有两种可能发生。第一种情况是：相关中断除能或是中断使能且堆栈已满，则程序会在“HALT”指令之后继续执行。这种情况下，唤醒系统的中断会等到相关中断使能或有堆栈层可以使用之后才执行。第二种情况是：相关中断使能且堆栈未滿，则中断可以马上执行。如果在进入休眠或空闲模式之前中断标志位已经被设置为“1”，则相关中断的唤醒功能将无效。

看门狗定时器

看门狗定时器的功能在于防止如电磁的干扰等外部不可控制事件，所造成的程序不正常动作或跳转到未知的地址。

看门狗定时器时钟源

WDT 定时器时钟源由内部低速振荡器 LIRC 提供。内部振荡器 LIRC 的频率大约为 32kHz，这个特殊的内部时钟周期会随 V_{DD} 、温度和制成的不同而变化。看门狗定时器的时钟源可分频为 $2^8 \sim 2^{18}$ 以提供更大的溢出周期，分频比由 WDT 寄存器中的 WS2~WS0 位来决定。

看门狗定时器控制寄存器

WDT 寄存器用于控制 WDT 功能的使能 / 除能、选择溢出周期以及软件复位单片机。

• WDT 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	WE4	WE3	WE2	WE1	WE0	WS2	WS1	WS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	1	0	1	0	0	1	1

Bit 7~3 **WE4~WE0**: WDT 软件控制位

10101: 除能
01010: 使能
其它值: 单片机复位

如果因外部环境干扰使这些位发生改变，则单片机将在一段延迟时间 t_{SRESET} 后复位，且在复位后 RSTFC 寄存器中的 WRF 标志位会被置位。

Bit 2~0 **WS2~WS0**: WDT 溢出周期选择位

000: $2^8/f_{LIRC}$
001: $2^{10}/f_{LIRC}$
010: $2^{12}/f_{LIRC}$
011: $2^{14}/f_{LIRC}$
100: $2^{15}/f_{LIRC}$
101: $2^{16}/f_{LIRC}$
110: $2^{17}/f_{LIRC}$
111: $2^{18}/f_{LIRC}$

这三位控制 WDT 时钟源的分频比，从而实现了对 WDT 溢出周期的控制。

• RSTFC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	RSTF	LVRF	LRF	WRF
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	x	0	0

“x”：未知

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3 **RSTF**: 复位控制寄存器软件复位标志位
详见别处的描述。

Bit 2 **LVRF**: LVR 复位标志位
详见别处的描述。

- Bit 1 **LRF**: LVR 控制寄存器软件复位标志位
 详见别处的描述。
- Bit 0 **WRF**: WDT 控制寄存器软件复位标志位
 0: 未发生
 1: 发生
 当 WDT 控制寄存器软件复位发生时，此位被置为“1”，且只能通过应用程序清零。

看门狗定时器操作

当 WDT 溢出时，它产生一个单片机复位的动作。这也就意味着正常工作期间，用户需在应用程序中看门狗溢出前有策略地清看门狗定时器以防止其产生复位，可使用清除看门狗指令实现。无论什么原因，程序失常跳转到一个未知的地址或进入一个死循环，这些清除指令都不能被正确执行，此种情况下，看门狗将溢出以使单片机复位。看门狗定时器控制寄存器 WDTC 中的 WE4~WE0 位可提供使能 / 除能控制以及控制看门狗定时器复位操作。当 WE4~WE0 设置为“10101B”时除能 WDT 功能，而当设置为“01010B”时使能 WDT 功能。如果 WE4~WE0 设置为除“01010B”和“10101B”以外的值时，单片机将在一段延迟时间 t_{SRESET} 后复位。上电后这些位初始化为“01010B”。

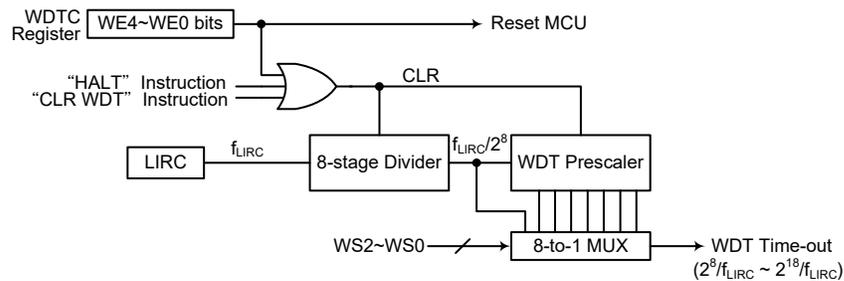
WE4~WE0 位	WDT 功能
10101B	除能
01010B	使能
其它值	单片机复位

看门狗定时器使能 / 除能控制

程序正常运行时，WDT 溢出将导致芯片复位，并置位状态标志位 TO。若系统处于休眠或空闲模式，当 WDT 发生溢出时，状态寄存器中的 TO 应置位，仅 PC 和堆栈指针复位。有三种方法可以用来清除 WDT 的内容。第一种是 WDT 复位，即写入除 01010 和 10101 外任何值到 WE4~WE0 位，第二种是通过软件清除指令，而第三种是通过“HALT”指令。

只有一种软件指令用于清除看门狗寄存器。因此只要执行“CLR WDT”便清除 WDT。

当设置分频比为 2^{18} 时，溢出周期最大。例如，时钟源为 32kHz LIRC 振荡器，分频比为 2^{18} 时最大溢出周期约 8s，分频比为 2^8 时最小溢出周期约 8ms。



看门狗定时器

复位和初始化

复位功能在任何单片机中基本的部分，使得单片机可以设定一些与外部参数无关的先置条件。最重要的复位条件是在单片机首次上电以后，经过短暂的延迟，内部硬件电路使得单片机处于预期的稳定状态并开始执行第一条程序指令。上电复位以后，在程序执行之前，部分重要的内部寄存器将会被设定为预先设定的状态。程序计数器就是其中之一，它会被清除为零，使得单片机从最低的程序存储器地址开始执行程序。

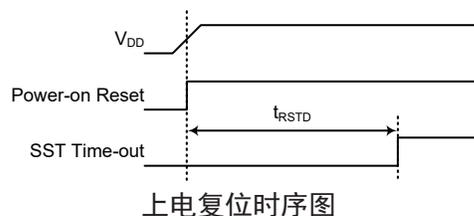
除了上电复位外，另一种复位为低电压复位即 LVR 复位，在电源供应电压低于 LVR 设定值时，系统会产生 LVR 复位。还有一种复位为看门狗溢出单片机复位，不同方式的复位操作会对寄存器产生不同的影响。

复位功能

单片机的几种内部复位方式将在此处做具体介绍。

上电复位

这是最基本且不可避免的复位，发生在单片机上电后。除了保证程序存储器从开始地址执行，上电复位也使得其它寄存器被设定在预设条件。所有的输入/输出端口控制寄存器在上电复位时会保持高电平，以确保上电后所有引脚被设定为输入状态。



内部复位控制

内部复位控制寄存器 RSTC 用于为单片机在受到环境噪声干扰而异常工作时提供复位。如果 RSTC 寄存器的内容被设置为除 01010101B 或 10101010B 以外的任何值，单片机会在一段延迟时间 t_{SRESET} 后发生复位。上电后寄存器的值为 01010101B。

RSTC7~RSTC0 位	复位功能
01010101B	无操作
10101010B	无操作
其它值	单片机复位

内部复位功能控制

● RSTC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	RSTC7	RSTC6	RSTC5	RSTC4	RSTC3	RSTC2	RSTC1	RSTC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	1	0	1	0	1	0	1

Bit 7~0 **RSTC7~RSTC0**: 复位功能控制位

01010101: 无操作

10101010: 无操作

其它值: 单片机复位

如果由于不利的环境因素使这些位发生改变, 单片机将复位。复位动作发生在一段延迟时间 t_{SRESET} 后, 且 RSTFC 寄存器的 RSTF 位将置为“1”。

● RSTFC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	RSTF	LVRF	LRF	WRF
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	x	0	0

“x”: 未知

Bit 7~4 未定义, 读为“0”

Bit 3 **RSTF**: 复位控制寄存器软件复位标志位

0: 未发生

1: 发生

当 RSTC 控制寄存器软件复位发生时, 此位被置为“1”, 且只能通过应用程序清零。

Bit 2 **LVRF**: LVR 复位标志位

详见别处的描述。

Bit 1 **LRF**: LVR 控制寄存器软件复位标志位

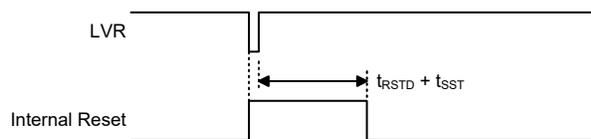
详见别处的描述。

Bit 0 **WRF**: WDT 控制寄存器软件复位标志位

详见别处的描述。

低电压复位 – LVR

单片机具有低电压复位电路, 用来监测它的电源电压。低电压复位功能总是使能于特定的电压值, V_{LVR} 。例如在更换电池的情况下, 单片机供应的电压可能会在 $0.9V \sim V_{LVR}$ 之间, 这时 LVR 将会自动复位单片机且 RSTFC 寄存器中的 LVRF 标志位置位。LVR 包含以下的规格: 有效的 LVR 信号, 即在 $0.9V \sim V_{LVR}$ 的低电压状态的时间, 必须超过 LVD/LVR 电气特性中 t_{LVR} 参数的值。如果低电压存在不超过 t_{LVR} 参数的值, 则 LVR 将会忽略它且不会执行复位功能。 V_{LVR} 参数值可通过 LVRC 寄存器中的 LVS7~LVS0 位设置。若由于受到干扰 LVS7~LVS0 变为其它值时, 需经过一段延迟时间 t_{SRESET} 响应复位。此时 RSTFC 寄存器的 LRF 位被置位。上电后寄存器的值为 01010101B。LVR 会于休眠或空闲时自动除能关闭。



低电压复位时序图

• LVRC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	LVS7	LVS6	LVS5	LVS4	LVS3	LVS2	LVS1	LVS0
R/W								
POR	0	1	0	1	0	1	0	1

Bit 7~0 **LVS7~LVS0**: LVR 电压选择

01010101: 2.1V
00110011: 2.55V
10011001: 3.15V
10101010: 3.8V

其它值: 单片机复位 – 寄存器复位为 POR 值

若低电压情况发生且满足以上定义的低电压复位值, 则单片机复位。保持低电压状态的时间需超过 t_{LVR} 才能响应复位。此时复位后的寄存器内容保持不变。

除了以上定义的四个低电压复位值外, 其它值也能导致单片机复位。需要经过一段延迟时间 t_{SRESET} 响应复位。但此时寄存器内容将复位为 POR 值。

• RSTFC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	RSTF	LVRF	LRF	WRF
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	x	0	0

“x”: 未知

Bit 7~4 未定义, 读为 “0”

Bit 3 **RSTF**: 复位控制寄存器软件复位标志位
详见别处的描述。

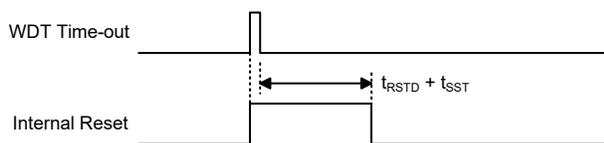
Bit 2 **LVRF**: LVR 复位标志位
0: 未发生
1: 发生
当特定的低电压复位条件发生时, 此位被置为 “1”, 且只能通过应用程序清零。

Bit 1 **LRF**: LVR 控制寄存器软件复位标志位
0: 未发生
1: 发生
如果 LVRC 寄存器包含任何非定义的 LVR 电压值, 此位被置为 “1”, 这类似于软件复位功能, 且只能通过应用程序清零。

Bit 0 **WRF**: WDT 控制寄存器软件复位标志位
详见别处的描述。

正常运行时看门狗溢出复位

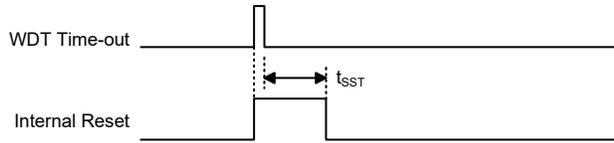
除了看门狗溢出标志位 TO 将被设为 “1” 之外, 在快速模式或低速模式时看门狗溢出复位和 LVR 复位相同。



正常运行时看门狗溢出复位时序图

休眠或空闲时看门狗溢出复位

休眠或空闲时看门狗溢出复位和其它种类的复位有些不同，除了程序计数器与堆栈指针将被清 0 及 TO 位被设为 1 外，绝大部份的条件保持不变。图中 t_{SS1} 的详细说明请参考系统上电时间电气特性。



休眠或空闲时看门狗溢出复位时序图

复位初始状态

不同的复位形式以不同的途径影响复位标志位。这些标志位，即 PDF 和 TO 位存放在状态寄存器中，由休眠或空闲模式功能或看门狗计数器等几种控制器操作控制。复位标志位如下所示：

TO	PDF	复位条件
0	0	上电复位
u	u	快速模式或低速模式时的 LVR 复位
1	u	快速模式或低速模式时的 WDT 溢出复位
1	1	空闲或休眠模式时的 WDT 溢出复位

“u”代表不改变

在单片机上电复位之后，各功能单元初始化的情形，列于下表。

项目	复位后情况
程序计数器	清除为零
中断	所有中断被除能
看门狗定时器，时基	都清除，且 WDT 重新计数
定时器模块	所有定时器模块停止
输入 / 输出口	I/O 口设为输入模式
堆栈指针	堆栈指针指向堆栈顶端

不同的复位形式对单片机内部寄存器的影响是不同的。为保证复位后程序能正常执行，了解寄存器在特定条件复位后的设置是非常重要的。下表即为不同方式复位后内部寄存器的状况。

寄存器	上电复位	LVR 复位 (快速模式)	LVR 复位 (空闲/休眠)	WDT 溢出 (快速模式)	WDT 溢出 (空闲/休眠)
IAR0	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP0	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
IAR1	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP1	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
BP	---- --0	---- --0	---- --0	---- --0	---- --u
ACC	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PCL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000
TBLP	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBLH	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBHP	---- -xxx	---- -uuu	---- -uuu	---- -uuu	---- -uuu
STATUS	--00 xxxx	--uu uuuu	--01 uuuu	--1u uuuu	--11 uuuu
RSTFC	---- 0x00	---- uuuu	---- uuuu	---- uuuu	---- uuuu
SCC	000- 0000	000- 0000	000- 0000	000- 0000	uuu- uuuu
HIRCC	---- 0001	---- 0001	---- 0001	---- 0001	---- uuuu
PA	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PAC	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PAPU	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAWU	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
RSTC	0101 0101	0101 0101	0101 0101	0101 0101	uuuu uuuu
LVRC	0101 0101	0101 0101	0101 0101	0101 0101	uuuu uuuu
LVDC	--00 0000	--00 0000	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
MFI0	--00 --00	--00 --00	--00 --00	--00 --00	--uu --uu
MFI1	--00 --00	--00 --00	--00 --00	--00 --00	--uu --uu
WDTC	0101 0011	0101 0011	0101 0011	0101 0011	uuuu uuuu
INTEG	---- 0000	---- 0000	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
INTC0	-000 0000	-000 0000	-000 0000	-000 0000	-uuu uuuu
INTC1	-000 -000	-000 -000	-000 -000	-000 -000	-uuu -uuu
INTC2	--00 --00	--00 --00	--00 --00	--00 --00	--uu --uu
PB	---- 1111	---- 1111	---- 1111	---- 1111	---- uuuu
PBC	---- 1111	---- 1111	---- 1111	---- 1111	---- uuuu
PBPU	---- 0000	---- 0000	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
PC	---- --11	---- --11	---- --11	---- --11	---- --uu
PCC	---- --11	---- --11	---- --11	---- --11	---- --uu
PCPU	---- --00	---- --00	---- --00	---- --00	---- --uu
PSCR	---- --00	---- --00	---- --00	---- --00	---- --uu
TB0C	0--- -000	0--- -000	0--- -000	0--- -000	u--- -uuu
TB1C	0--- -000	0--- -000	0--- -000	0--- -000	u--- -uuu
PAS0	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAS1	---- --00	---- --00	---- --00	---- --00	---- --uu
PBS0	---- --00	---- --00	---- --00	---- --00	---- --uu

寄存器	上电复位	LVR 复位 (快速模式)	LVR 复位 (空闲/休眠)	WDT 溢出 (快速模式)	WDT 溢出 (空闲/休眠)
SIMC0	111- 0000	111- 0000	111- 0000	111- 0000	uuu- uuuu
SIMC1	1000 0001	1000 0001	1000 0001	1000 0001	uuuu uuuu
SIMD	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
SIMA	0000 000-	0000 000-	0000 000-	0000 000-	uuuu uu-
SIMC2	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SIMTOC	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
EEC	---- 0000	---- 0000	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
EEA	---0 0000	---0 0000	---0 0000	---0 0000	---u uuuu
EED	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
CTMC0	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
CTMC1	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
CTMDL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
CTMDH	---- --00	---- --00	---- --00	---- --00	---- --uu
CTMAL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
CTMAH	---- --00	---- --00	---- --00	---- --00	---- --uu
ADCS	---0 0000	---0 0000	---0 0000	---0 0000	---u uuuu
ADCR0	0010 00-0	0010 00-0	0010 00-0	0010 00-0	uuuu uu-u
ADCR1	0000 000-	0000 000-	0000 000-	0000 000-	uuuu uu-
PWRC	00-- -000	00-- -000	00-- -000	00-- -000	uu-- -uuu
PGAC0	-000 0000	-000 0000	-000 0000	-000 0000	-uuu uuuu
PGAC1	1000 000-	1000 000-	1000 000-	1000 000-	uuuu uu-
PGACS	--00 0000	--00 0000	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
ADRL	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ADRM	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ADRH	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
DSDAH	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
DSDAL	---- 0000	---- 0000	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
DSDACC	00-- ----	00-- ----	00-- ----	00-- ----	uu-- ----
SLEDC0	--00 0000	--00 0000	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
SLEDC1	---- --00	---- --00	---- --00	---- --00	---- --uu

注：“u”表示不改变
“x”表示未知
“-”表示未定义

输入 / 输出端口

Holtek 单片机的输入 / 输出控制具有很大的灵活性。大部分引脚可在用户程序控制下被设定为输入或输出。所有引脚的上拉电阻设置以及指定引脚的唤醒设置也都由软件控制，这些特性也使得此类单片机在广泛应用上都能符合开发的需求。

此单片机提供 PA~PC 双向输入 / 输出。这些寄存器在数据存储寄存器有特定的地址。所有 I/O 口用于输入输出操作。作为输入操作，输入引脚无锁存功能，也就是说输入数据必须在执行“MOV A, [m]”，T2 的上升沿准备好，m 为端口地址。对于输出操作，所有数据都是被锁存的，且保持不变直到输出锁存被重写。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PA	PA7	PA6	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0
PAC	PAC7	PAC6	PAC5	PAC4	PAC3	PAC2	PAC1	PAC0
PAPU	PAPU7	PAPU6	PAPU5	PAPU4	PAPU3	PAPU2	PAPU1	PAPU0
PAWU	PAWU7	PAWU6	PAWU5	PAWU4	PAWU3	PAWU2	PAWU1	PAWU0
PB	—	—	—	—	PB3	PB2	PB1	PB0
PBC	—	—	—	—	PBC3	PBC2	PBC1	PBC0
PBPU	—	—	—	—	PBPU3	PBPU2	PBPU1	PBPU0
PC	—	—	—	—	—	—	PC1	PC0
PCC	—	—	—	—	—	—	PCC1	PCC0
PCPU	—	—	—	—	—	—	PCPU1	PCPU0

“—”：未定义，读为“0”

I/O 逻辑功能寄存器列表

上拉电阻

许多产品应用在端口处于输入状态时需要外加一个上拉电阻来实现上拉的功能。为了免去外部上拉电阻，当引脚规划为输入时，可由内部连接到一个上拉电阻。这些上拉电阻可通过相应的上拉控制寄存器 PAPU~PCPU 来设置，它用一个 PMOS 晶体管来实现上拉电阻功能。

需要注意的是，当 I/O 引脚设为输入或 NMOS 输出时，上拉功能才会受 PxPU 控制开启，其它状态下上拉功能不可用。

● PxPU 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PxPU7	PxPU6	PxPU5	PxPU4	PxPU3	PxPU2	PxPU1	PxPU0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

PxPUn: I/O Px 口上拉电阻控制位

0: 除能

1: 使能

PxPUn 位用于控制上拉电阻功能。这里的 x 可以是端口 A、B 和 C。但是，每个 I/O 端口实际有效位可能不同。

PA 口唤醒

当使用暂停指令“HALT”迫使单片机进入休眠或空闲模式，单片机的系统时钟将会停止以降低功耗，此功能对于电池及低功耗应用很重要。唤醒单片机有很多种方法，其中之一就是使 PA 口的其中一个引脚从高电平转为低电平。这个功能特别适合于通过外部开关来唤醒的应用。PA 口的每个引脚可以通过设置 PAWU 寄存器来单独选择是否具有唤醒功能。

需要注意的是，只有当引脚功能为通用 I/O 功能且单片机处于省电模式时，唤醒功能才会受 PAWU 控制开启，其它状态下此唤醒功能不可用。

● PAWU 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAWU7	PAWU6	PAWU5	PAWU4	PAWU3	PAWU2	PAWU1	PAWU0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **PAWU7~PAWU0:** PA 口 bit 7~bit 0 唤醒功能控制位
 0: 除能
 1: 使能

输入 / 输出端口控制寄存器

每一个输入 / 输出口都具有各自的控制寄存器，即 PAC~PCC，用来控制输入 / 输出状态。从而每个 I/O 引脚都可以通过软件控制，动态的设置为 CMOS 输出或输入。所有的 I/O 端口的引脚都各自对应于 I/O 端口控制的某一位。若 I/O 引脚要实现输入功能，则对应的控制寄存器的位需要设置为“1”。这时程序指令可以直接读取输入脚的逻辑状态。若控制寄存器相应的位被设定为“0”，则此引脚被设置为 CMOS 输出。当引脚设置为输出状态时，程序指令读取的是输出端口寄存器的内容。注意，如果对输出口做读取动作时，程序读取到的是内部输出数据锁存器中的状态，而不是输出引脚上实际的逻辑状态。

● PxC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PxC7	PxC6	PxC5	PxC4	PxC3	PxC2	PxC1	PxC0
R/W								
POR	1	1	1	1	1	1	1	1

PxCn: I/O Px 口类型选择位
 0: 输出
 1: 输入

PxCn 位用于控制引脚类型。这里的 x 可以是端口 A、B、和 C。但是，每个 I/O 端口实际有效位可能不同。

输入 / 输出端口源电流选择

该单片机的每个 I/O 口都支持不同的源电流驱动能力，通过相应的源电流选择位控制。仅当对应的引脚被设为 CMOS 输出时，其源电流选择位才有效。否则，这些选择位无效。用户可参考输入 / 输出口电气特性章节为不同应用选择所需的源电流。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SLEDC0	—	—	SLEDC05	SLEDC04	SLEDC03	SLEDC02	SLEDC01	SLEDC00
SLEDC1	—	—	—	—	—	—	SLEDC11	SLEDC10

I/O 口源电流选择寄存器列表

• SLEDC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	SLEDC05	SLEDC04	SLEDC03	SLEDC02	SLEDC01	SLEDC00
R/W	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 未定义，读为“0”

Bit 5~4 **SLEDC05~SLEDC04**: PB3~PB0 源电流选择位
00: Level 0 (最小)
01: Level 1
10: Level 2
11: Level 3 (最大)

Bit 3~2 **SLEDC03~SLEDC02**: PA7~PA4 源电流选择位
00: Level 0 (最小)
01: Level 1
10: Level 2
11: Level 3 (最大)

Bit 1~0 **SLEDC01~SLEDC00**: PA3~PA0 源电流选择位
00: Level 0 (最小)
01: Level 1
10: Level 2
11: Level 3 (最大)

• SLEDC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	SLEDC11	SLEDC10
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **SLEDC11~SLEDC10**: PC1~PC0 源电流选择位
00: Level 0 (最小)
01: Level 1
10: Level 2
11: Level 3 (最大)

引脚共用功能

引脚的多功能可以增加单片机应用的灵活性。有限的引脚个数将会限制设计者，而引脚的多功能将会解决很多此类问题。此外，这些引脚功能可以通过一系列寄存器进行设定。

引脚共用功能选择寄存器

封装中有限的引脚个数会对某些单片机功能造成影响。然而，引脚功能共用和引脚功能选择，使得小封装单片机具有更多不同的功能。单片机包含端口“x”输出功能选择寄存器“n”，记为 P_xS_n，这些寄存器可以用来选择共用引脚的特定功能。

要注意的最重要一点是，确保所需的引脚共用功能被正确地选择和取消。要选择所需的引脚共用功能，首先应通过相应的引脚共用控制寄存器正确地选择该功能，然后再配置相应的外围功能设置以使能外围功能。要正确地取消引脚共用功能，首先应除能外围功能，然后再修改相应的引脚共用控制寄存器以选择其它的共用功能。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PAS0	PAS07	PAS06	PAS05	PAS04	PAS03	PAS02	PAS01	PAS00
PAS1	—	—	—	—	—	—	PAS11	PAS10
PBS0	—	—	—	—	—	—	PBS01	PBS00

引脚共用功能选择寄存器列表

• PAS0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAS07	PAS06	PAS05	PAS04	PAS03	PAS02	PAS01	PAS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **PAS07~PAS06:** PA3 引脚共用功能选择

00: PA3
01: CTP
10: PA3
11: PA3

Bit 5~4 **PAS05~PAS04:** PA2 引脚共用功能选择

00: PA2
01: PA2
10: \overline{SCS}
11: PA2

Bit 3~2 **PAS03~PAS02:** PA1 引脚共用功能选择

00: PA1/INT0
01: SDI/SDA
10: PA1/INT0
11: PA1/INT0

Bit 1~0 **PAS01~PAS00:** PA0 引脚共用功能选择

00: PA0
01: SDO
10: PA0
11: PA0

● PAS1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	PAS11	PAS10
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **PAS11~PAS10**: PA4 引脚共用功能选择
00: PA4
01: CTPB
10: PA4
11: PA4

● PBS0 寄存器

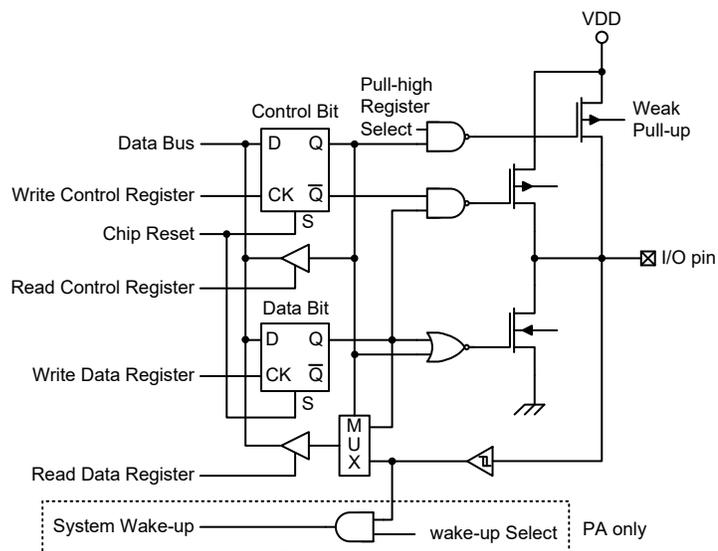
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	PBS01	PBS00
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **PBS01~PBS00**: PB0 引脚共用功能选择
00: PB0
01: PB0
10: SCK/SCL
11: LVDIN

输入 / 输出引脚结构

下图为输入 / 输出引脚逻辑功能的内部结构图。输入 / 输出引脚的准确逻辑结构图可能与此图不同，这里只是为了方便对 I/O 引脚逻辑功能的理解提供一个参考。由于存在诸多的引脚共用结构，在此不方便提供所有类型引脚功能结构图。



逻辑功能输入 / 输出端口结构

编程注意事项

在编程中，最先要考虑的是端口的初始化。复位之后，所有的输入 / 输出数据及端口控制寄存器都将被设为逻辑高。所有输入 / 输出引脚默认为输入状态，而其电平则取决于其它相连接电路以及是否选择了上拉电阻。如果端口控制寄存器某些引脚位被设定输出状态，这些输出引脚会有初始高电平输出，除非数据寄存器在程序中被预先设定。设置哪些引脚是输入及哪些引脚是输出，可通过设置正确的值到适当的端口控制寄存器，或使用指令“SET [m].i”及“CLR [m].i”来设定端口控制寄存器中个别的位。注意，当使用这些位控制指令时，系统即将产生一个读 - 修改 - 写的操作。单片机需要先读入整个端口上的数据，修改个别的位，然后重新把这些数据写入到输出端口。

PA 口的每个引脚都带唤醒功能。单片机处于休眠或空闲模式时，有很多方法可以唤醒单片机，其中之一就是通过 PA 任一引脚电平从高到低转换的方式，可以设置 PA 口一个或多个引脚具有唤醒功能。

定时器模块 – TM

控制和测量时间在任何单片机中都是一个很重要的部分。该单片机提供单个定时器模块 (简称 TM)，来实现和时间有关的功能。该定时器模块是包括多种操作的定时单元，提供的操作有：定时 / 事件计数器，比较匹配输出以及 PWM 输出等功能。该定时器模块有两个独立中断。其外加的输入输出引脚，扩大了定时器的灵活性，便于用户使用。

简介

该单片机包含一个简易型 TM 单元 – CTM，其主要特性见下表。

功能	CTM
定时 / 计数器	√
比较匹配输出	√
PWM 通道数	1
PWM 对齐方式	边沿对齐
PWM 调节周期 & 占空比	占空比或周期

TM 功能概要

TM 操作

该 TM 提供从简单的定时操作到 PWM 信号产生等多种功能。理解 TM 操作的关键是比较 TM 内独立运行的计数器的值与内部比较器的预置值。当计数器的值与比较器的预置值相同时，则比较匹配，TM 中断信号产生，清零计数器并改变 TM 输出引脚的状态。用户选择内部时钟或外部引脚来驱动内部 TM 计数器。

TM 时钟源

驱动 TM 计数器的时钟源很多。通过设置 CTM 控制寄存器的 CTCK2~CTCK0 位可选择所需的时钟源。该时钟源来自系统时钟 f_{SYS} 或内部高速时钟 f_H 或 f_{SUB} 时钟源或外部 CTCK 引脚的分频比。CTCK 引脚时钟源用于允许外部信号作为 TM 时钟源或用于事件计数。

TM 中断

简易型 TM 有两个内部中断，即内部比较器 A 和比较器 P，当发生比较匹配时比较器将产生一个 TM 中断。中断产生时将清除计数器，并改变 TM 输出引脚的状态。

TM 外部引脚

简易型 TM 有一个输入引脚 CTCK。CTM 输入引脚也作为 CTM 的时钟源输入脚，通过设置 CTMC0 寄存器中的 CTCK2~CTCK0 位进行选择。外部时钟源可通过该引脚来驱动内部 TM。CTM 输入引脚可以选择上升沿或下降沿。

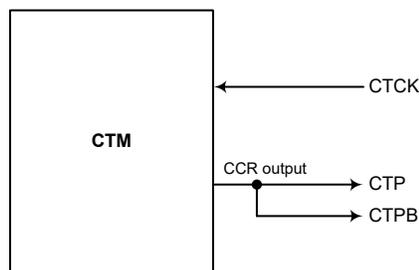
简易型 TM 有两个输出引脚 CTP 和 CTPB。当 CTM 工作在比较匹配输出模式且比较匹配发生时，这些引脚会由 TM 控制切换到高电平或低电平或翻转。外部 CTP 和 CTPB 输出引脚也被 TM 用来产生 PWM 输出波形。当 TM 输入和输出引脚与其它功能共用时，TM 输入和输出功能需要事先通过相关引脚共用功能选择寄存器先被设置。

CTM	
输入	输出
CTCK	CTP, CTPB

CTM 外部引脚

TM 输入 / 输出引脚选择

选择作为 TM 输入 / 输出引脚还是其它共用引脚功能是通过设置相关引脚共用寄存器来实现的。每个 TM 输入 / 输出引脚都有对应的引脚共用选择位。正确设置选择位将相应的引脚用作 TM 输入 / 输出。更多引脚共用功能选择详见引脚共用功能章节。

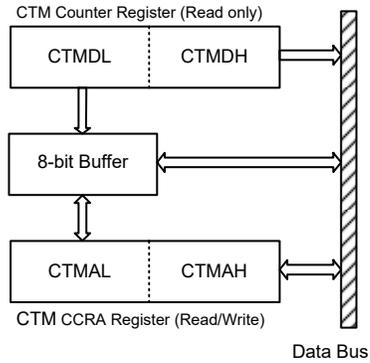


CTM 功能引脚控制方框图

编程注意事项

TM 计数寄存器和捕捉 / 比较寄存器 CCRA 寄存器，含有低字节和高字节结构。高字节可直接访问，低字节则仅能通过一个内部 8-bit 的缓存器进行访问。读写这些成对的寄存器需通过特殊的方式。值得注意的是 8-bit 缓存器的存取数据及相关低字节的读写操作仅在其相应的高字节读取操作执行时发生。

由于 CCRA 寄存器按照下图方式执行，具体存取这些寄存器对的方式如上所述，建议使用“MOV”指令，通过以下步骤访问 CCRA 低字节寄存器 CTMAL。若不采用以下步骤访问 CCRA 低字节寄存器将导致不可预期的结果。

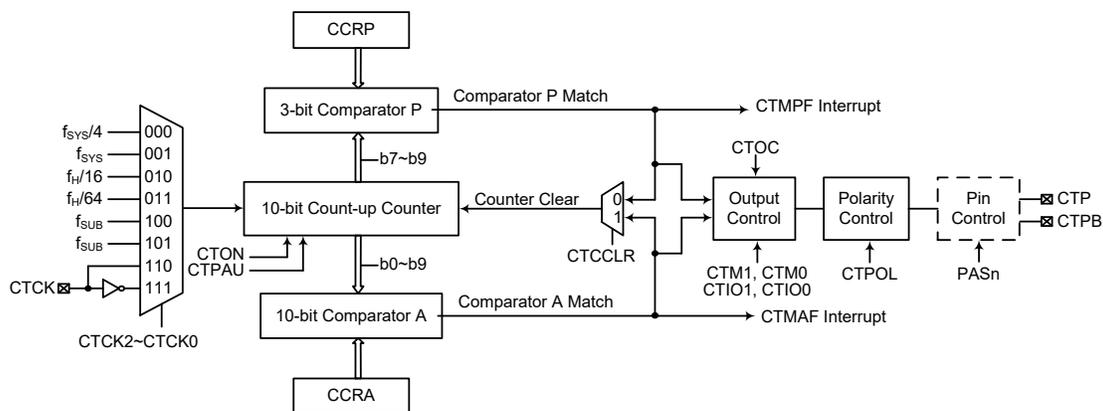


读写流程如下步骤所示：

- 写数据至 CCRA
 - ◆ 步骤 1. 写数据至低字节寄存器 CTMAL
 - 注意，此时数据仅写入 8-bit 缓存器。
 - ◆ 步骤 2. 写数据至高字节寄存器 CTMAH
 - 注意，此时数据直接写入高字节寄存器，同时锁存在 8-bit 缓存器中的数据写入低字节寄存器。
- 从计数器寄存器和 CCRA 中读取数据
 - ◆ 步骤 1. 从高字节寄存器 CTMDH、CTMAH 中读取数据
 - 注意，此时高字节寄存器中的数据直接读取，同时由低字节寄存器读取的数据锁存至 8-bit 缓存器中。
 - ◆ 步骤 2. 从低字节寄存器 CTMDL、CTMAL 中读取数据
 - 注意，此时读取 8-bit 缓存器中的数据。

简易型 TM – CTM

简易型 TM 包括三种工作模式，即比较匹配输出，定时 / 事件计数器和 PWM 输出模式。简易型 TM 也由一个外部输入脚控制并驱动两个外部输出脚。



简易型 TM 方框图

简易型 TM 操作

简易型 TM 核心是一个由用户选择的内部或外部时钟源驱动的 10 位向上计数器，它还包括两个内部比较器即比较器 A 和比较器 P。这两个比较器将计数器的值与 CCRP 和 CCRA 寄存器中的值进行比较。CCRP 是 3 位的，与计数器的高 3 位比较；而 CCRA 是 10 位的，与计数器的所有位比较。

通过应用程序改变 10 位计数器值的唯一方法是使 CTON 位发生上升沿跳变清除计数器。此外，计数器溢出或比较匹配也会自动清除计数器。上述条件发生时，通常情况下会产生 TM 中断信号。简易型 TM 可工作在不同的模式，可由包括来自输入脚的不同时钟源驱动，也可以控制两个输出脚。所有工作模式的设定都是通过设置相关内部寄存器来实现的。

简易型 TM 寄存器介绍

简易型 TM 的所有操作由一系列寄存器控制。包含一对只读寄存器用来存放 10 位计数器的值，一对读 / 写寄存器存放 10 位 CCRA 的值，剩下两个控制寄存器设置不同的操作和控制模式以及 3 位的 CCRP 值。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
CTMC0	CTPAU	CTCK2	CTCK1	CTCK0	CTON	CTRP2	CTRP1	CTRP0
CTMC1	CTM1	CTM0	CTIO1	CTIO0	CTOC	CTPOL	CTDPX	CTCCLR
CTMDL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
CTMDH	—	—	—	—	—	—	D9	D8
CTMAL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
CTMAH	—	—	—	—	—	—	D9	D8

简易型 TM 寄存器列表

• CTMC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	CTPAU	CTCK2	CTCK1	CTCK0	CTON	CTRP2	CTRP1	CTRP0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **CTPAU**: CTM 计数器暂停控制位

- 0: 运行
- 1: 暂停

通过设置此位为高可暂停计数器。此位清零可恢复正常计数器操作。在暂停情况下 CTM 将保持上电并继续产生功耗。当此位由低到高转换，计数器将保留其剩余值，当其电平再变为低时从此位开始继续计数。

Bit 6~4 **CTCK2~CTCK0**: CTM 计数器时钟选择位

- 000: $f_{SYS}/4$
- 001: f_{SYS}
- 010: $f_H/16$
- 011: $f_H/64$
- 100: f_{SUB}
- 101: f_{SUB}
- 110: CTCK 上升沿时钟
- 111: CTCK 下降沿时钟

此三位用于选择 CTM 的时钟源。外部引脚时钟源能被选择在上升沿或下降沿有效。 f_{SYS} 是系统时钟， f_H 和 f_{SUB} 是其它的内部时钟源，细节方面请参考振荡器章节。

Bit 3 **CTON**: CTM 计数器 On/Off 控制位

- 0: Off
- 1: On

此位控制 CTM 的总开关功能。设置此位为高可使能计数器使其运行，清零此位则除能 CTM。清零此位将停止计数器并关闭 CTM 减少功耗。当此位经由低到高转换时，内部计数器将复位清零，当此位由高到低转换时，内部计数器将保持其剩余值直到此位再次转变为高。

若 CTM 处于比较匹配输出模式或 PWM 输出模式，当 CTON 位经由低到高转换时，CTM 输出脚将复位至 CTC0 位指定的初始值。

Bit 2~0 **CTRP2~CTRP0**: CTM CCRP 3-bit 寄存器，与 CTM 计数器 bit 9~bit 7 比较

比较器 P 匹配周期

- 000: 1024 个 CTM 时钟
- 001: 128 个 CTM 时钟
- 010: 256 个 CTM 时钟
- 011: 384 个 CTM 时钟
- 100: 512 个 CTM 时钟
- 101: 640 个 CTM 时钟
- 110: 768 个 CTM 时钟
- 111: 896 个 CTM 时钟

此三位设定内部 CCRP 3-bit 寄存器的值，然后与内部计数器的高三位进行比较。如果 CTCCLR 位设定为 0 时，选中该比较结果清除内部计数器。CTCCLR 位设定为 0，内部计数器在比较器 P 比较匹配发生时被重置；由于 CCRP 只与计数器高三位比较，比较结果是 128 时钟周期的倍数。CCRP 被清零时，会使得计数器在最大值溢出。

• CTMC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	CTM1	CTM0	CTIO1	CTIO0	CTOC	CTPOL	CTDPX	CTCCLR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **CTM1~CTM0:** CTM 工作模式选择位

- 00: 比较匹配输出模式
- 01: 未定义
- 10: PWM 输出模式
- 11: 定时 / 计数器模式

这两个位为 CTM 设置所需的工作模式。为保证操作的可靠性，在此位段发生任何改变之前需先关闭 CTM。在定时 / 计数器模式下，CTM 输出引脚状态未定义。

Bit 5~4 **CTIO1~CTIO0:** CTP 输出功能选择位

比较匹配输出模式

- 00: 未改变
- 01: 输出低
- 10: 输出高
- 11: 输出翻转

PWM 输出模式

- 00: PWM 输出无效状态
- 01: PWM 输出有效状态
- 10: PWM 输出
- 11: 未定义

定时 / 计数器模式

未使用

这两位用于确定在达到某些条件时 CTM 输出引脚状态应如何改变。这些位的功能选择取决于当下 CTM 的运行模式。

在比较匹配输出模式下，CTIO1 和 CTIO0 位决定当比较器 A 比较匹配输出发生时 CTM 输出脚如何改变状态。当比较器 A 比较匹配输出发生时 CTM 输出脚能设为切换高、切换低或翻转当前状态。若此两位同时为 0 时，输出将不会改变。CTM 输出脚的初始值通过 CTOC 位设置取得。注意，由 CTIO1 和 CTIO0 位得到的输出电平必须与通过 CTOC 位设置的初始值不同，否则当比较匹配发生时，CTM 输出脚将不会发生变化。在 CTM 输出脚改变状态后，通过 CTON 位由低到高电平的转换可复位至初始值。

在 PWM 输出模式，CTIO1 和 CTIO0 用于决定比较匹配条件发生时怎样改变 TM 输出脚的状态。PWM 输出功能通过这两位的变化进行更新。仅在 CTM 关闭时改变 CTIO1 和 CTIO0 位的值是很有必要的。若在 CTM 运行时改变 CTIO1 和 CTIO0 的值，PWM 输出的值是无法预料的。

Bit 3 **CTOC:** CTP 输出控制位

比较匹配输出模式

- 0: 初始低
- 1: 初始高

PWM 输出模式

- 0: 低有效
- 1: 高有效

此位为 CTM 输出脚的输出控制位。它取决于 CTM 此时正运行于比较匹配输出模式还是 PWM 输出模式。若 CTM 处于定时 / 计数器模式，则其不受影响。在比较匹配输出模式时，比较匹配发生前其决定 CTM 输出脚的逻辑电平值。在 PWM 输出模式时，其决定 PWM 信号是高有效还是低有效。

- Bit2 **CTPOL:** CTP 输出极性控制位
 0: 同相
 1: 反相
 此位控制 CTM 输出脚的极性。此位为高时 CTM 输出脚反相，为低时 CTM 输出脚同相。若 CTM 处于定时 / 计数器模式时其不受影响。
- Bit 1 **CTDPX:** CTM PWM 周期 / 占空比控制位
 0: CCRP - 周期; CCRA - 占空比
 1: CCRP - 占空比; CCRA - 周期
 此位决定 CCRA 与 CCRP 寄存器哪个被用于 PWM 波形的周期和占空比控制。
- Bit 0 **CTCCLR:** 选择 CTM 计数器清零条件位
 0: CTM 比较器 P 匹配
 1: CTM 比较器 A 匹配
 此位用于选择清除计数器的方法。简易型 TM 包括两个比较器 - 比较器 A 和比较器 P。这两个比较器每个都可以用于清除内部计数器。CTCCLR 位设为高，计数器在比较器 A 比较匹配发生时被清除；此位设为低，计数器在比较器 P 比较匹配发生或计数器溢出时被清除。计数器溢出清除的方法仅在 CCRP 的位都被清除为 0 时才能生效。CTCCLR 位在 PWM 输出模式时未使用。

• **CTMDL 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~0 CTM 计数器低字节寄存器 bit 7~bit 0
 CTM 10-bit 计数器 bit 7~bit 0

• **CTMDH 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R	R
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

- Bit 7~2 未定义，读为“0”
 Bit 1~0 CTM 计数器高字节寄存器 bit 1~bit 0
 CTM 10-bit 计数器 bit 9~bit 8

• **CTMAL 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~0 CTM CCRA 低字节寄存器 bit 7~bit 0
 CTM 10-bit CCRA bit 7~bit 0

• CTMAH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 CTM CCRA 高字节寄存器 bit 1~bit 0

CTM 10-bit CCRA bit 9~bit 8

简易型 TM 工作模式

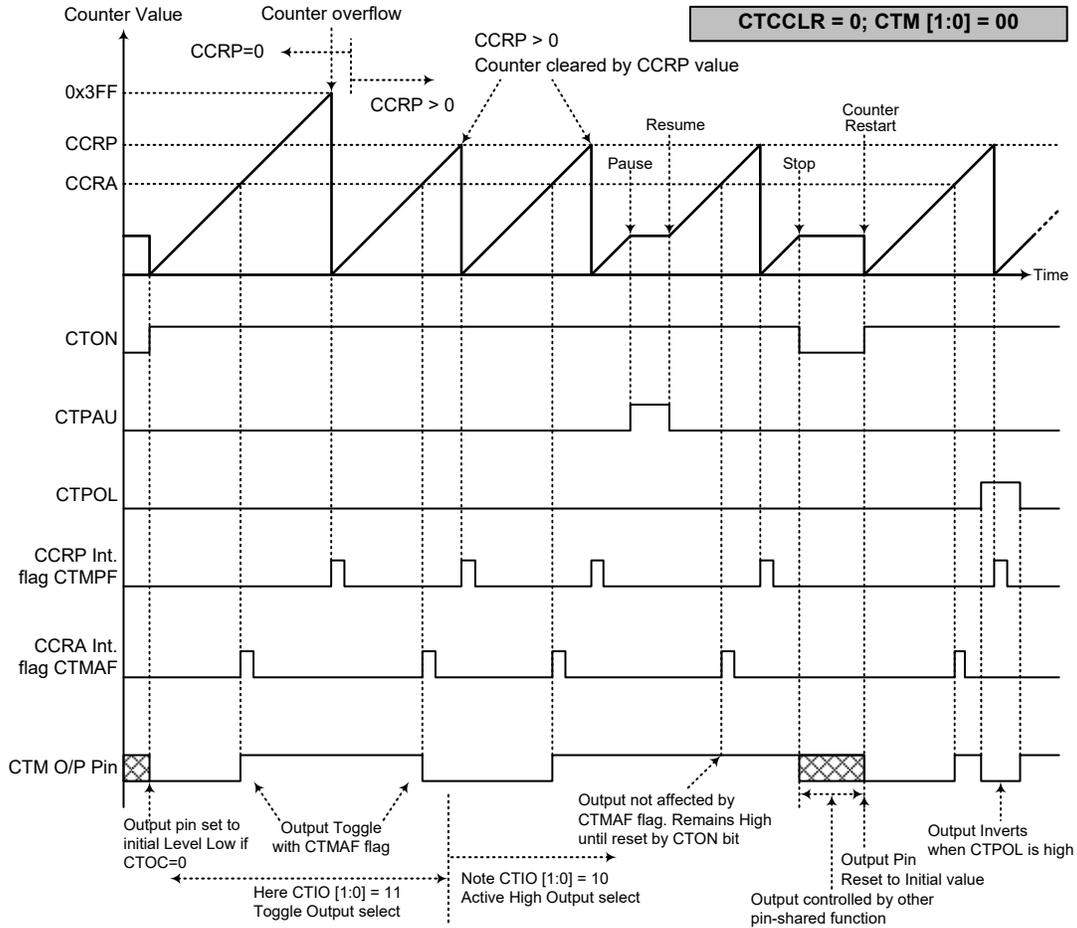
简易型 TM 有三种工作模式，即比较匹配输出模式，PWM 输出模式或定时 / 计数器模式。通过设置 CTMC1 寄存器的 CTM1 和 CTM0 位选择任意工作模式。

比较匹配输出模式

要工作在此模式，CTMC1 寄存器中的 CTM1 和 CTM0 位需要设置为“00”。当工作在该模式，一旦计数器使能并开始计数，有三种方法来清零，分别是：计数器溢出，比较器 A 比较匹配发生和比较器 P 比较匹配发生。当 CTCCLR 位为低，有两种方法清除计数器。一种是比较器 P 比较匹配发生，另一种是 CCRP 所有位设置为零并使得计数器溢出。此时，比较器 A 和比较器 P 的请求标志位 CTMAF 和 CTMPF 将分别置起。

如果 CTMC1 寄存器的 CTCCLR 位设置为高，当比较器 A 比较匹配发生时计数器被清零。此时，即使 CCRP 寄存器的值小于 CCRA 寄存器的值，仅 CTMAF 中断请求标志产生。所以当 CTCCLR 为高时，不产生 CTMPF 中断请求标志。如果 CCRA 被清零，当计数达到最大值 3FFH 时，计数器溢出，而此时不产生 CTMAF 请求标志。

正如该模式名所言，当比较匹配发生后，CTM 输出脚状态改变。当比较器 A 比较匹配发生后 CTMAF 标志产生时，CTM 输出脚状态改变。比较器 P 比较匹配发生时产生的 CTMPF 标志不影响 CTM 输出脚。CTM 输出脚状态改变方式由 CTMC1 寄存器中 CTIO1 和 CTIO0 位决定。当比较器 A 比较匹配发生时，CTIO1 和 CTIO0 位决定 CTM 输出脚输出高，低或翻转当前状态。CTM 输出脚初始值，在 CTON 位由低到高电平的变化后通过 CTC位设置。注意，若 CTIO1 和 CTIO0 位同时为 0 时，引脚输出不变。



比较匹配输出模式 - CTCCLR=0

- 注：1. CTCCLR = 0 时，比较器 P 匹配将清除计数器。
2. CTM 输出引脚仅由 CTMAF 标志位控制
3. 输出引脚通过 CTON 位上升沿复位为初始值

定时 / 计数器模式

要工作在此模式，CTMC1 寄存器中的 CTM1 和 CTM0 位需要设置为“11”。定时 / 计数器模式与比较输出模式操作方式相同，并产生同样的中断请求标志。不同的是，在定时 / 计数器模式下 CTM 输出脚未使用。因此，比较匹配输出模式中的描述和时序图可以帮助理解此功能。该模式中未使用的 CTM 输出脚用作普通 I/O 脚或其它功能。

PWM 输出模式

要工作在此模式，CTMC1 寄存器中的 CTM1 和 CTM0 位需要设置为“10”。TM 的 PWM 功能在马达控制，加热控制，照明控制等方面十分有用。给 TM 输出脚提供一个频率固定但占空比可调的信号，将产生一个有效值等于 DC 均方根的 AC 方波。

由于 PWM 波形的周期和占空比可控，其波形的选择就极其灵活。在 PWM 输出模式中，CTCCLR 位不影响 PWM 操作。CCRA 和 CCRP 寄存器决定 PWM 波形，一个用来清除内部计数器并控制 PWM 波形的频率，另一个用来控制占空比。哪个寄存器控制频率或占空比取决于 CTMC1 寄存器的 CTD PX 位。所以 PWM 波形频率和占空比由 CCRA 和 CCRP 寄存器共同决定。

当比较器 A 或比较器 P 比较匹配发生时，将产生 CCRA 或 CCRP 中断标志。CTMC1 寄存器中的 CTOC 位决定 PWM 波形的极性，CTIO1 和 CTIO0 位使能 PWM 输出或将 CTM 输出脚置为逻辑高或逻辑低。CTPOL 位对 PWM 输出波形的极性取反。

● **CTM, PWM 输出模式，边沿对其模式，CTDPX = 0**

CCRP	001b	010b	011b	100b	101b	110b	111b	000b
Period	128	256	384	512	640	768	896	1024
Duty	CCRA							

若 $f_{SYS}=8\text{MHz}$ ，CTM 时钟源选择 $f_{SYS}/4$ ，CCRP=100b，CCRA=128，

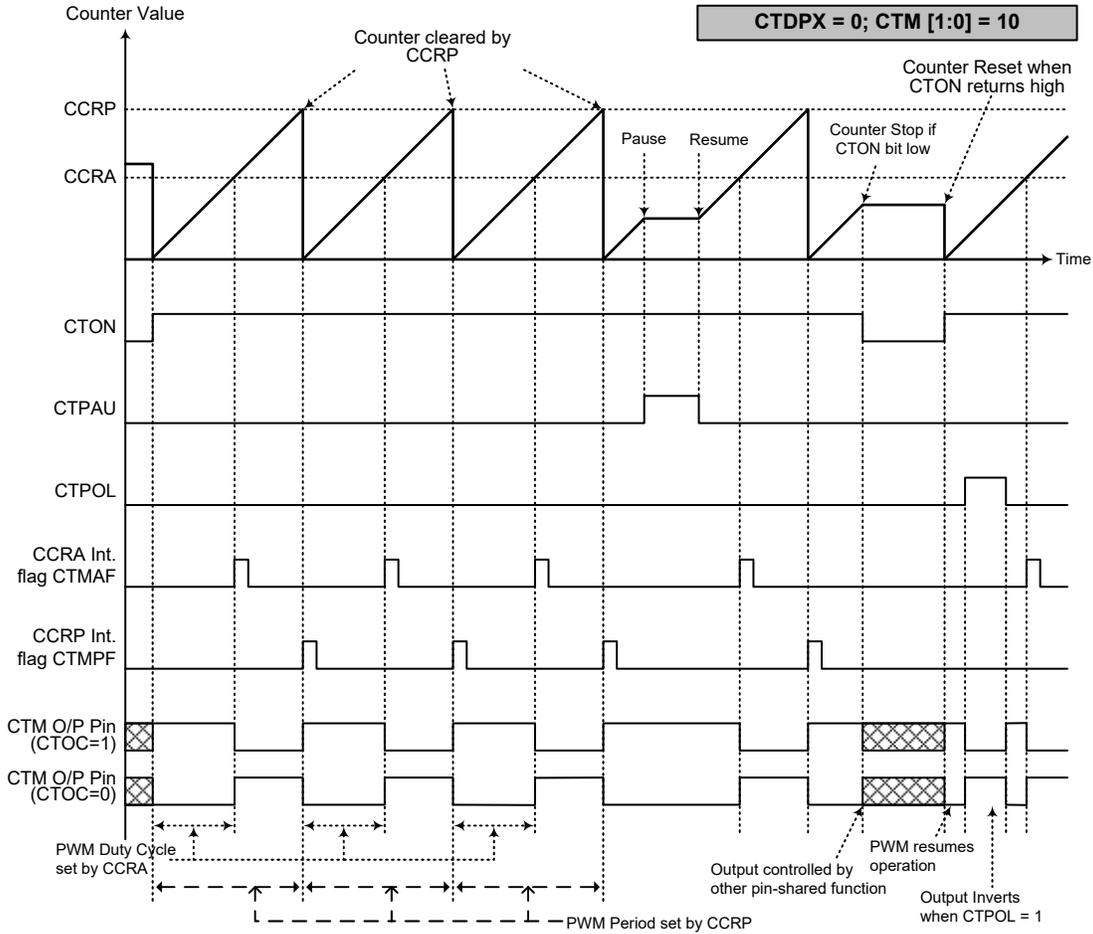
CTM PWM 输出频率 = $(f_{SYS}/4)/512=f_{SYS}/2048=3.9063\text{kHz}$ ， $duty=128/512=25\%$ 。

若由 CCRA 寄存器定义的 Duty 值等于或大于 Period 值，PWM 输出占空比为 100%。

● **CTM, PWM 输出模式，边沿对其模式，CTDPX = 1**

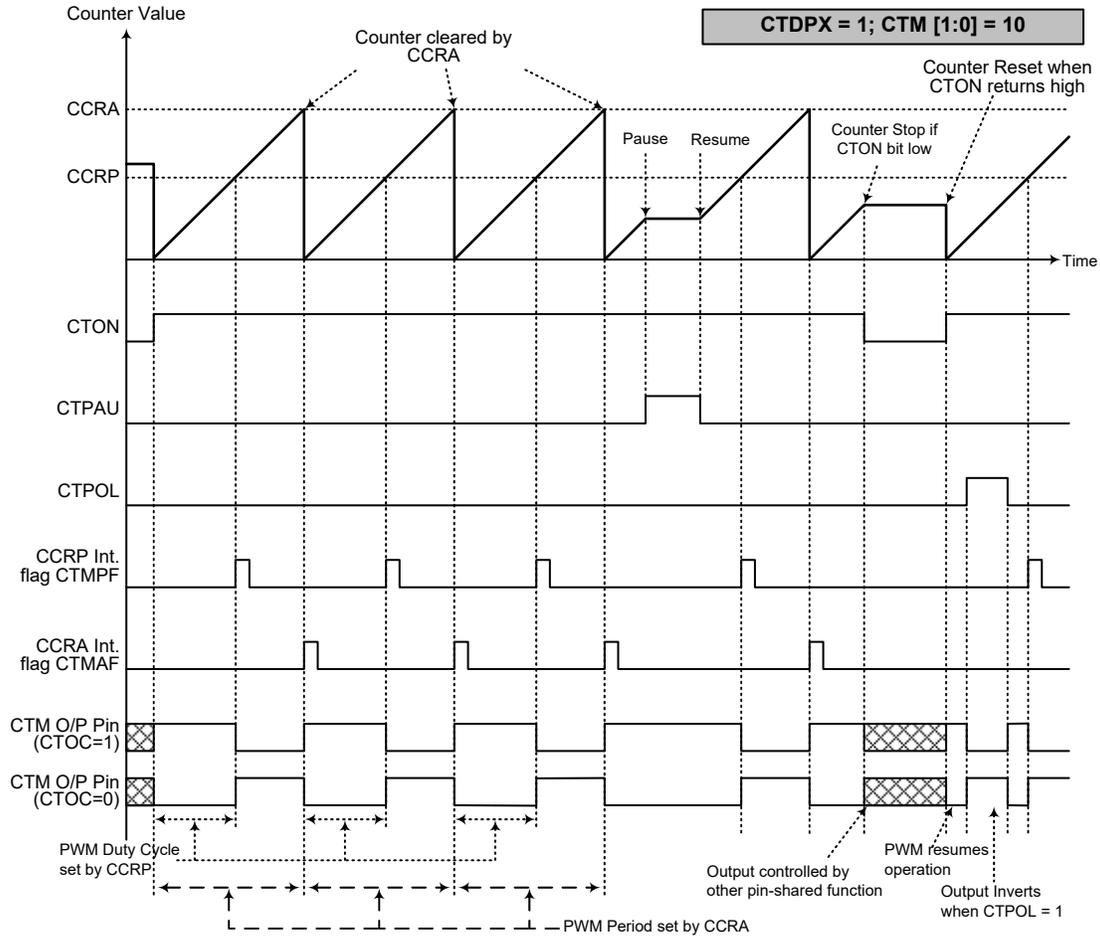
CCRP	001b	010b	011b	100b	101b	110b	111b	000b
Period	CCRA							
Duty	128	256	384	512	640	768	896	1024

PWM 的输出周期由 CCRA 寄存器的值与 CTM 的时钟共同决定，PWM 的占空比由 CCRP 寄存器的值决定。



PWM 输出模式 - CTDPX = 0

- 注：1. 这里的 CTDPX = 0 - 计数器由 CCRP 清除
2. 计数器清除设置 PWM 周期
3. 即使在 CTIO[1:0] = 00 或 01 时，内部 PWM 功能继续运行
4. CTCCLR 位对 PWM 操作没有影响



- 注：1. 这里的 CTD PX = 1 - 计数器由 CCRA 清除
 2. 计数器清除设置 PWM 周期
 3. 即使在 CTIO[1:0] = 00 或 01 时，内部 PWM 功能继续运行
 4. CTCCLR 位对 PWM 操作无影响

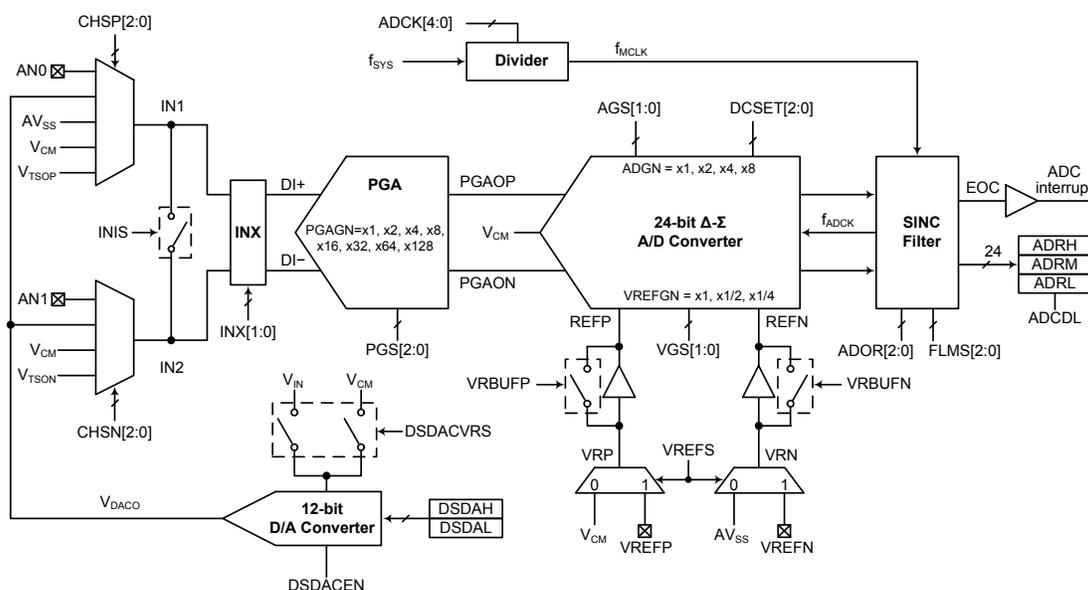
A/D 转换器

对于大多数电子系统而言，处理现实世界的模拟信号是共同的需求。为了完全由单片机来处理这些信号，首先需要通过 A/D 转换器将模拟信号转换成数字信号。将 A/D 转换器电路集成入单片机，可有效的减少外部器件，随之而来，具有降低成本和减少器件空间需求的优势。

A/D 转换器简介

此单片机包含一个多通道的 24 位 Delta Sigma 型高精度 A/D 转换器，它们可以直接接入外部模拟信号（来自传感器或其它控制信号）并直接将这些信号转换成 24 位的数字量。

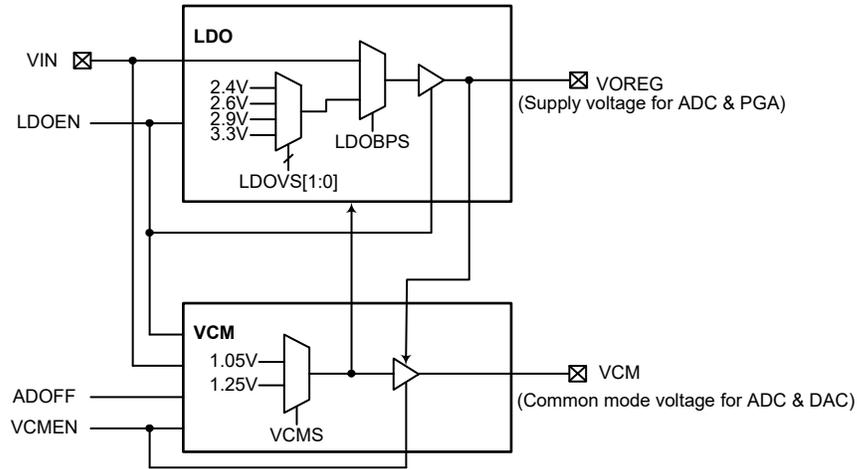
另外，ADC 输入信号的放大增益由 PGA 增益控制、ADC 增益控制和 ADC 参考电压增益控制共同确定。设计者可以选择最佳增益组合为输入信号提供所需的放大增益。下面的方框图说明了 A/D 转换器的基本操作功能。A/D 转换器输入通道由 2 个单端 A/D 输入通道或 1 组差分输入通道组成。信号在进入 24 位 Delta Sigma 型 A/D 转换器之前，输入信号通过 PGA 放大。A/D 转换调制器将 1-bit 转换后的数据输出到 SINC 滤波器，然后会转换成 24-bit 的数据，并将它们存储到特殊数据寄存器。此外，单片机还提供了一个温度传感器来补偿的 A/D 转换器由温度引起的偏差。这种高精度和高性能的特点，使得该单片机非常适用于体重秤及相关产品。



A/D 转换器结构

内部电源

该单片机内部集成一个 LDO 和一个 VCM 模块，用于产生稳定的电源电压，其基本功能操作如下图所示。内部的 LDO 电路为 PGA、ADC 或外部器件提供了一个固定电压。VCM 还可以作为 ADC 或 DAC 模块的参考电压。LDO 可提供 2.4V、2.6V、2.9V 或 3.3V 四个输出电压，通过 PWRC 寄存器中的 LDOVS1~LDOVS0 位选择。VCM 可提供两个输出电压，1.05V 和 1.25V，可由 PGAC1 寄存器中的 VCMS 位选择。LDO 和 VCM 功能分别由 LDOEN 位和 VCMEN 位控制，可将其关闭以降低功耗。



内部电源方框图

寄存器相关位			输出电压	
ADOFF	LDOEN	VCMEN	VOREG	VCM
1	0	x	除能	除能
1	1	x	使能	除能
0	0	0	除能	除能
0	1	0	使能	除能
0	0	1	除能	除能 (外部电压未接到 LDO 输出引脚)
				使能 (外部电压接到 LDO 输出引脚)
0	1	1	使能	使能

“x”：无关

电源控制表

• PWRC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	LDOEN	VCMEN	—	—	—	LDOBPS	LDOVS1	LDOVS0
R/W	R/W	R/W	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	—	—	—	0	0	0

- Bit 7 **LDOEN**: LDO 功能控制位
 0: 除能
 1: 使能
 如果 LDO 除能, 将不产生功耗, LDO 会在一个小下拉电阻的作用下输出低电平。
- Bit 6 **VCMEN**: VCM 功能控制位
 0: 除能
 1: 使能
 如果 VCM 除能, 将不产生功耗, VCM 输出脚会处于浮空状态。
- Bit 5~3 未定义, 读为 “0”
- Bit 2 **LDOBPS**: LDO 旁路功能控制位
 0: 除能
 1: 使能

Bit 1~0 **LDOVS1~LDOVS0**: LDO 输出电压选择位
 00: 2.4V
 01: 2.6V
 10: 2.9V
 11: 3.3V

A/D 转换器数据传输率的定义

Delta Sigma 型 A/D 转换器的数据传输率可以通过下面的公式计算:

$$\text{数据传输率} = \frac{f_{\text{ADCK}}}{\text{CHOP} \times \text{OSR}} = \frac{f_{\text{MCLK}}/N}{\text{CHOP} \times \text{OSR}} = \frac{f_{\text{MCLK}}}{N \times \text{CHOP} \times \text{OSR}}$$

f_{ADCK} : A/D 时钟输入, 来自 f_{MCLK}/N ;

f_{MCLK} : A/D 时钟源, 来自 f_{SYS} 或 $f_{\text{SYS}}/2/(\text{ADCK}[4:0]+1)$, 通过 ADCK[4:0] 位选择和设置;

N: 除数因子, 可以为 30 或 12, 通过 FLMS[2:0] 位选择;

CHOP: 采样数据量加倍功能控制位, 可以为 2 或 1, 通过 FLMS[2:0] 位选择;

OSR: 过采样率, 通过 ADOR[2:0] 位选择。

例如, 若需要一个 8Hz 的数据传输率, 可以选择 A/D 时钟源 f_{MCLK} 为 4MHz, 然后设置 FLMS[2:0]=000b, 即获得 A/D 转换时钟为 A/D 时钟源的 30 分频且 CHOP=2, 最后设置 ADOR[2:0]=001b, 选择过采样率为 8192。因此, 可以得到一个数据传输率 = 4MHz/(30×2×8192)=8Hz。

需注意的是当数据传输率为 10Hz, A/D 转换器对于频率为 50Hz 或 60Hz 交流电源有陷波抑制功能。

A/D 转换寄存器介绍

A/D 转换器的所有工作由一系列寄存器控制。3 个只读寄存器用来存放 24 位 A/D 转换数据的值。一个控制寄存器 PWRC 用于控制 PGA 和 A/D 转换器偏压及电源相关设置可参考“内部电源”章节介绍。三个寄存器用于控制 D/A 转换器的所有操作。剩下 6 个控制寄存器用于设置增益及 A/D 转换器的功能控制。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PWRC	LDOEN	VCMEN	—	—	—	LDOBPS	LDOVS1	LDOVS0
PGAC0	—	VGS1	VGS0	AGS1	AGS0	PGS2	PGS1	PGS0
PGAC1	VCMS	INIS	INX1	INX0	DCSET2	DCSET1	DCSET0	—
PGACS	—	—	CHSN2	CHSN1	CHSN0	CHSP2	CHSP1	CHSP0
ADRL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
ADRM	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
ADRH	D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
ADCR0	ADRST	ADSLP	ADOFF	ADOR2	ADOR1	ADOR0	—	VREFS
ADCR1	FLMS2	FLMS1	FLMS0	VRBUFN	VRBUFP	ADCDL	EOC	—
ADCS	—	—	—	ADCK4	ADCK3	ADCK2	ADCK1	ADCK0
DSDAH	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4
DSDAL	—	—	—	—	D3	D2	D1	D0
DSDACC	DSDACEN	DSDACVRS	—	—	—	—	—	—

A/D 转换寄存器列表

可编程增益放大器 – PGA

有三个与可编程增益相关的控制寄存器，PGAC0、PGAC1 和 PGACS。PGAC0 寄存器用于选择 PGA 增益、ADC 增益和 ADC 参考电压增益。PGAC1 寄存器用于定义输入端连接，差分输入偏置电压调整控制和 VCM 电压选择。PGACS 寄存器用于选择 PGA 的输入端信号。因此，必须通过 CHSP2~CHSP0 和 CHSN2~CHSN0 位来选择模拟输入通道、温度检测输入或内部电源中的哪些被连接到内部差分 A/D 转换器。

● PGAC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	VGS1	VGS0	AGS1	AGS0	PGS2	PGS1	PGS0
R/W	—	R/W						
POR	—	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 未定义，读为“0”

Bit 6~5 **VGS1~VGS0**: REFP/REFN 差分参考电压增益选择位

00: VREFGN = 1
01: VREFGN = 1/2
10: VREFGN = 1/4
11: 保留位

Bit 4~3 **AGS1~AGS0**: A/D 转换器 PGAOP/PGAON 差分输入信号增益选择位

00: ADGN = 1
01: ADGN = 2
10: ADGN = 4
11: ADGN = 8

Bit 2~0 **PGS2~PGS0**: DI+/DI- 差分通道输入增益选择位

000: PGAGN = 1
001: PGAGN = 2
010: PGAGN = 4
011: PGAGN = 8
100: PGAGN = 16
101: PGAGN = 32
110: PGAGN = 64
111: PGAGN = 128

● PGAC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	VCMS	INIS	INX1	INX0	DCSET2	DCSET1	DCSET0	—
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	—
POR	1	0	0	0	0	0	0	—

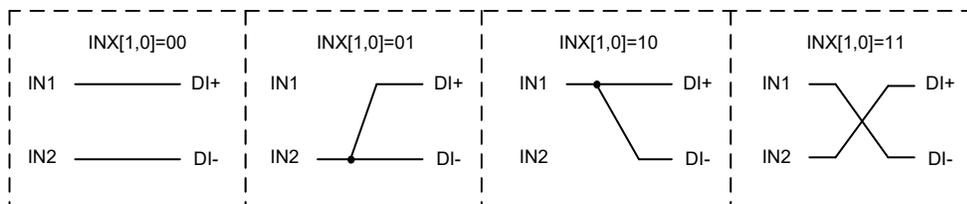
Bit 7 **VCMS**: 模拟共模电压选择

0: 1.05V
1: 1.25V

Bit 6 **INIS**: 选择输入端 IN1 和 IN2 内部连接控制位

0: 不连接
1: 连接

Bit 5~4 **INX1~INX0**: 选择输入端 IN1/IN2 以及 PGA 差分输入端 DI+/DI- 连接控制位



Bit 3~1 **DCSET2~DCSET0**: 差分输入信号 PGAOP/PGAON 偏置选择位

- 000: DCSET = +0V
- 001: DCSET = +0.25×ΔVR_I
- 010: DCSET = +0.5×ΔVR_I
- 011: DCSET = +0.75×ΔVR_I
- 100: DCSET = +0V
- 101: DCSET = -0.25×ΔVR_I
- 110: DCSET = -0.5×ΔVR_I
- 111: DCSET = -0.75×ΔVR_I

ΔVR_I为差分参考电压，可在输入信号的基础上选择一定的增益放大。

Bit 0 未定义，读为“0”

● PGACS 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	CHSN2	CHSN1	CHSN0	CHSP2	CHSP1	CHSP0
R/W	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 未定义，读为“0”

Bit 5~3 **CHSN2~CHSN0**: 反相输入端 IN2 输入信号选择位

- 000: AN1
- 001: 保留位
- 010: 保留位
- 011: 保留位
- 100: DACO
- 101: 保留位
- 110: V_{CM}
- 111: 温度传感器输出 - V_{TSOP}

这些位用于选择反相端 IN2 输入信号。对于单端输入应用，若 IN2 被选作单端输入，则 IN1 端应选择 V_{CM} 电压作为正相输入。为便于操作更合理，若选择 V_{TSOP} 信号作为反相端输入，建议选择 V_{TSOP} 为正相端输入。

Bit 2~0 **CHSP2~CHSP0**: 正相输入端 IN1 输入信号选择位

- 000: AN0
- 001: 保留位
- 010: 保留位
- 011: 保留位
- 100: DACO
- 101: 未使用，连接到 AVSS
- 110: V_{CM}
- 111: 温度传感器输出 - V_{TSOP}

这些位用于选择正相端 IN1 输入信号。对于单端输入应用，若 IN1 被选作单端输入，则 IN2 端应选择 V_{CM} 电压作为反相输入。为便于操作更合理，若选择 V_{TSOP} 信号作为正相端输入，建议选择 V_{TSOP} 为反相端输入。

D/A 转换器寄存器 – DSDAH, DSDAL, DSDACC

D/A 转换器有三个相关的控制寄存器。

• DSDAH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D11~D4**: D/A 转换器输出控制码, 仅用于 12-bit D/A 转换器

• DSDAL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	D3	D2	D1	D0
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义, 读为“0”

Bit 3~0 **D3~D0**: D/A 转换器输出控制码

注: 对该寄存器写值只会写入到影子缓存器中, 直到对 DSDAH 寄存器写值, 才会将影子缓存器的值复制到 DSDAL 寄存器。

• DSDACC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	DSDACEN	DSDACVRS	—	—	—	—	—	—
R/W	R/W	R/W	—	—	—	—	—	—
POR	0	0	—	—	—	—	—	—

Bit 7 **DSDACEN**: D/A 转换器使能或除能控制位

0: 除能
1: 使能

Bit 6 **DSDACVRS**: D/A 转换器参考电压选择位

0: D/A 转换器参考电压来自 V_{IN}
1: D/A 转换器参考电压来自 V_{CM}

Bit 5~0 未定义, 读为“0”

A/D 转换器数据寄存器 – ADRL, ADRM, ADRH

对于具有 24 位 A/D 转换器的单片机, 需要 3 个数据寄存器存放转换结果, 一个高字节寄存器 ADRH、一个中间字节寄存器 ADRM 和一个低字节寄存器 ADRL。在 A/D 转换完毕后, 单片机可以直接读取这些寄存器以获得转换结果。D0~D23 是 A/D 转换数据结果位。

• ADRL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”: 未知

Bit 7~0 A/D 转换器数据寄存器 bit 7~bit 0

● **ADRM 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7~0 A/D 转换器数据寄存器 bit 15~bit 8

● **ADRH 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7~0 A/D 转换器数据寄存器 bit 23~bit 16

A/D 转换控制寄存器 – ADCR0, ADCR1, ADCS

寄存器 ADCR0、ADCR1 和 ADCS 用来控制 A/D 转换器的功能和操作。这些 8 位的寄存器定义包括选择内部 A/D 转换器的参考源，A/D 时钟源，A/D 输出数据传输率，并控制和监视 A/D 转换器的开始和转换结束状态等。

● **ADCR0 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADRST	ADSLP	ADOFF	ADOR2	ADOR1	ADOR0	—	VREFS
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	—	R/W
POR	0	0	1	0	0	0	—	0

Bit 7 **ADRST**: A/D 转换器软件复位控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

此位可用于复位 A/D 转换器内部数字 SINC 滤波器。此位为低，A/D 转换正常工作，若将此位从低设为高，将复位内部数字 SINC 滤波器同时当前 A/D 转换的数据失效。再清零此位，将开始一次新的 A/D 转换。

Bit 6 **ADSLP**: A/D 转换器休眠模式控制位

- 0: 正常模式
- 1: 休眠模式

此位用于控制当通过设置 ADOFF 位为低开启 A/D 转换器后，A/D 转换器是否进入休眠模式。当 A/D 转换器开启后且此位为低时，A/D 转换器正常工作，反之若开启后此位为高则进入休眠模式。在休眠模式下，除 PGA 和内部 Bandgap 电路外的其它 A/D 转换电路都将关闭以减少功耗并缩短 V_{CM} 启动稳定时间。

Bit 5 **ADOFF**: A/D 转换器模块电源开 / 关控制位

- 0: A/D 转换器模块电源开
- 1: A/D 转换器模块电源关

此位控制 A/D 内部功能的电源。该位被清零将使能 A/D 转换器。如果该位设为高将关闭 A/D 转换器以降低功耗。由于 A/D 转换器在不执行转换动作时都会产生一定的功耗，所以这在电源敏感的电池应用中需要多加注意。

注：1. 建议在进入空闲 / 休眠模式前，设置 ADOFF=1 以减少功耗。

2. 无论 ADSLP 和 ADRST 位如何设置，ADOFF=1 将关闭 A/D 转换器模块的电源。

- Bit 4~2 **ADOR2~ADOR0:** A/D 转换器过采样率 (OSR) 选择位
 000: OSR = 16384
 001: OSR = 8192
 010: OSR = 4096
 011: OSR = 2048
 100: OSR = 1024
 101: OSR = 512
 110: OSR = 256
 111: OSR = 128
- Bit 1 未定义, 读为 “0”
- Bit 0 **VREFS:** A/D 转换器参考电压对选择位
 0: 内部参考电压对 – V_{CM} & AV_{SS}
 1: 外部参考电压对 – $VREFP$ & $VREFN$

● **ADCR1 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	FLMS2	FLMS1	FLMS0	VRBUFN	VRBUFP	ADCDL	EOC	—
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	—
POR	0	0	0	0	0	0	0	—

- Bit 7 ~ 5 **FLMS2~FLMS0:** A/D 转换器时钟 (f_{ADCK}) 分频比选择及采样数据加倍功能 (CHOP) 控制位
 000: CHOP = 2, $f_{ADCK} = f_{MCLK} / 30$
 010: CHOP = 2, $f_{ADCK} = f_{MCLK} / 12$
 100: CHOP = 1, $f_{ADCK} = f_{MCLK} / 30$
 110: CHOP = 1, $f_{ADCK} = f_{MCLK} / 12$
 其它值: 保留位
 若 CHOP=2, 为正常转换模式, 采样数据量加倍。若 CHOP=1, 则视为低延迟转换模式, 采样加倍功能关闭。
- Bit 4 **VRBUFN:** A/D 转换器反相参考电压输入缓存 (VRN) 控制位
 0: 除能输入缓存, 使能旁路功能
 1: 使能输入缓存, 除能旁路功能
- Bit 3 **VRBUFP:** A/D 转换器正相参考电压输入缓存 (VRP) 控制位
 0: 除能输入缓存, 使能旁路功能
 1: 使能输入缓存, 除能旁路功能
- Bit 2 **ADCDL:** A/D 转换器数据锁存功能控制位
 0: 除能数据锁存功能
 1: 使能数据锁存功能
 如果使能 A/D 转换数据锁存功能, 最新转换的数据将被锁存, 且不会更新后面的转换结果直到该功能被除能。虽然转换后的数据被锁存到数据寄存器, A/D 转换电路仍正常运行, 但并不产生中断, EOC 也不改变。建议在读取 ADRL、ADRM 和 ADRH 寄存器中的转换数据之前先将该位置高。读取后该位会被清零以除能 A/D 数据锁存功能, 以便下一笔转换结果的存储。这样可以防止在 A/D 转换过程中得到不需要的数据。
- Bit 1 **EOC:** A/D 转换结束标志
 0: A/D 转换中
 1: A/D 转换结束
 此位必须通过软件清除。
- Bit 0 未定义, 读为 “0”

• ADCS 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	ADCK4	ADCK3	ADCK2	ADCK1	ADCK0
R/W	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	0	0	0	0	0

Bit 7~5 未定义，读为“0”

Bit 4~0 **ADCK4~ADCK0**: A/D 转换器时钟源 (f_{MCLK}) 分频率选择位
0000~11110: $f_{MCLK} = f_{SYS}/2 / (ADCK[4:0]+1)$
11111: $f_{MCLK} = f_{SYS}$

A/D 转换器操作

该 A/D 转换器提供了四种工作模式，正常模式、暂停模式、休眠模式和复位模式，分别由 ADCR0 寄存器中的 ADOFF、ADSLP 和 ADRST 位控制。下表列出了工作模式的选择。

LDOEN	ADOFF	ADSLP	ADRST	工作模式	说明
0	1	x	x	暂停模式	Bandgap off, LDO off, V_{CM} off, PGA off, ADC off, 温度传感器 off, VRN/VRP 缓存 off, SINC 滤波器 off
1	1	x	x	暂停模式	Bandgap on, LDO on, V_{CM} off, PGA off, ADC off, 温度传感器 off, VRN/VRP 缓存 off, SINC 滤波器 off
0	0	1	x	休眠模式 (外部电压接到 LDO 输出引脚)	Bandgap on, LDO off, V_{CM} off, PGA on, ADC off, 温度传感器 off, VRN/VRP 缓存 off, SINC 滤波器 on
0	0	0	0	正常模式 (外部电压接到 LDO 输出引脚)	Bandgap on, LDO off, V_{CM} on/off ⁽¹⁾ , PGA on, ADC on, 温度传感器 on/off ⁽²⁾ , VRN/VRP 缓存 on/off ⁽³⁾ , SINC 滤波器 on
0	0	0	1	复位模式 (外部电压接到 LDO 输出引脚)	Bandgap on, LDO off, V_{CM} on/off ⁽¹⁾ , PGA on, ADC on, 温度传感器 on/off ⁽²⁾ , VRN/VRP 缓存 on/off ⁽³⁾ , SINC 滤波器复位
1	0	1	x	休眠模式	Bandgap on, LDO on, V_{CM} off, PGA on, ADC off, 温度传感器 off, VRN/VRP 缓存 off, SINC 滤波器 on
1	0	0	0	正常模式	Bandgap on, LDO on, V_{CM} on/off ⁽¹⁾ , PGA on, ADC on, 温度传感器 on/off ⁽²⁾ , VRN/VRP 缓存 on/off ⁽³⁾ , SINC 滤波器 on
1	0	0	1	复位模式	Bandgap on, LDO on, V_{CM} on/off ⁽¹⁾ , PGA on, ADC on, 温度传感器 on/off ⁽²⁾ , VRN/VRP 缓存 on/off ⁽³⁾ , SINC 滤波器复位

“x”：未知

- 注：1. 可以通过设置 VCMEN 位控制 V_{CM} on/off;
2. 可以通过设置 CHSN[2:0] 或 CHSP[2:0] 位控制温度传感器 on/off;
3. 可以通过相应设置 VRBUFN 或 VRBUPF 位控制 VRN 或 VRP 缓存 on/off。

A/D 转换器工作模式选择

要打开 A/D 转换器，首先应将 ADOFF 和 ADSLP 位清零，除能 A/D 转换器的暂停和休眠模式，以确保 A/D 转换器可以通电。ADCR0 寄存器中的 ADRST 位，用于上电后打开和复位 A/D 转换器。当单片机设定此位从逻辑低到逻辑高，然后再到逻辑低，一个模数转换后的数据就会开始在 SINC 滤波器中进行转换。设置完成后，A/D 转换器可以开始工作。这三位用于控制内部模数转换器的开启动作。

ADCR1 寄存器中的 EOC 位用于表明模数转换过程的完成。在转换周期结束后，EOC 位会被单片机自动地置为“1”。此外，也会置位中断控制寄存器内相应的 A/D 中断请求标志位，如果中断使能，就会产生对应的内部中断信号。A/D 内部中断信号将引导程序到相应的 A/D 内部中断入口。如果 A/D 内部中断被禁止，可以让单片机轮询 ADCR0 寄存器中的 EOC 位，检查此位是否被置高，以作为另一种侦测 A/D 转换周期结束的方法。A/D 转换数据将不断更新，如果 A/D 转换数据锁存功能使能，最新的转换数据会被锁存，这样后面再转换的数据不会被保存，直到该功能被关闭。

A/D 转换器的时钟源通常固定在 4MHz，来自系统时钟 f_{SYS} 或其分频，分频系数由 ADCS 寄存器中的 ADCK4~ADCK0 位决定，以获得固定 4MHz 的 ADC 时钟源。

A/D 转换器参考电压来自内部电源电压引脚 VCM 和 AVSS 或外部参考源引脚 VREFP 和 VREFN，可通过 ADCR0 寄存器的 VREFS 位来选择。

A/D 转换步骤

下面概述实现 A/D 转换过程的各个步骤。

- 步骤 1
使能 LDO 和 VCM，以提供电源给 PGA 和 ADC。
- 步骤 2
通过 PGAC0 寄存器，选择 PGA、ADC 和参考电压的增益。
- 步骤 3
通过 PGAC1 寄存器，选择 PGA 的输入引脚连接，VCM 电压电平和缓存器选项。
- 步骤 4
通过 ADCS 寄存器中的 ADCK4~ADCK0 位，选择所需的 A/D 转换时钟。
- 步骤 5
通过 ADCR0 寄存器中的 ADOR2~ADOR0 位及 ADCR1 寄存器中的 FLMS2~FLM0 位，选择输出数据传输率。
- 步骤 6
通过 PGACS 寄存器中的 CHSP2~CHSP0 和 CHSN2~CHSN0 位，选择连接至内部 PGA 的通道。
- 步骤 7
通过 ADCR0 寄存器中的 ADOFF 和 ADSLP 位，关闭暂停和休眠模式。
- 步骤 8
通过置高 ADCR0 寄存器中的 ADRST 位来复位 A/D 转换器，清除该位来释放复位状态。

- 步骤 9
如果要使用中断，则中断控制寄存器需要正确地设置，以确保 A/D 转换中断功能是激活的。总中断控制位 EMI 需要置位为“1”，以及 A/D 转换器中断位 ADE 也需要置位为“1”。
 - 步骤 10
可以轮询 ADCR1 寄存器中的 EOC 位，检查模数转换过程是否完成。当此位成为逻辑高时，表示转换过程已经完成。转换完成后，可读取 A/D 数据寄存器 ADRL、ADRM 和 ADRH 获得转换后的值。另一种方法是，若中断使能且堆栈未滿，则程序等待 A/D 中断发生。
- 注：若使用轮询 ADCR1 寄存器中 EOC 位的状态的方法来检查转换过程是否结束时，则中断使能的步骤可以省略。

编程注意事项

在编程时，如果 A/D 转换器未使用，通过设置 ADCR0 寄存器中的 ADOFF 为高，关闭 A/D 内部电路以减少电源功耗。此时，不考虑输入脚的模拟电压，内部 A/D 转换器电路不产生功耗。

A/D 转换功能

该单片机含有一组 24 位的 A/D 转换器，它的转换范围为 -8388608~8388607 (十进制)。转换后的数据以二进制补码的形式表示，最高位是转换数据的符号位。由于模拟输入最大值等于 V_{CM} 或差分参考输入电压 (由 ADCR0 寄存器的 VREFS 位选择) 放大后的电压值 ΔVR_I ，因此每一位可表示 $\Delta VR_I/8388608$ 的模拟输入值。

$$1 \text{ LSB} = \Delta VR_I / 8388608$$

通过下面的等式可估算 A/D 转换后的数据：

$$\Delta SI_I = (PGAGN \times ADGN \times \Delta DI_{\pm}) + DCSET$$

$$\Delta VR_I = VREGN \times \Delta VR_{\pm}$$

$$\text{ADC 转换数据} = (\Delta SI_I / \Delta VR_I) \times K$$

其中， $K=2^{23}$

注：1. PGAGN、ADGN 和 VREGN 的值由 PGS、AGS、VGS 控制位决定。

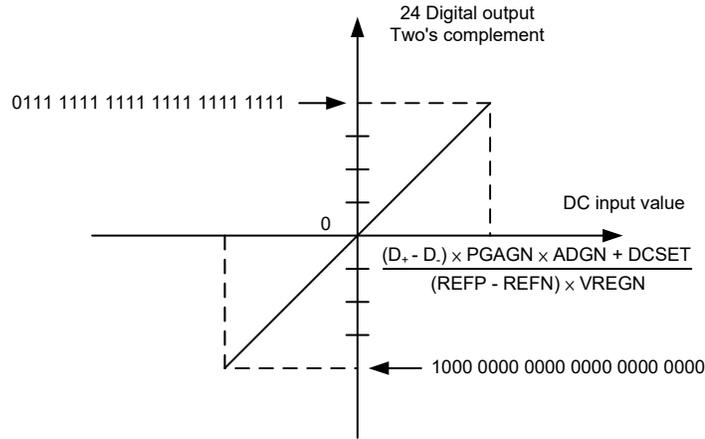
2. ΔSI_I : 经过放大和偏置校准后的差分输入信号
3. PGAGN: PGA 增益
4. ADGN: A/D 转换器增益
5. VREGN: 参考电压增益
6. ΔDI_{\pm} : 差分输入信号，来自外部通道或内部信号
7. DCSET: 偏置电压
8. ΔVR_{\pm} : 差分参考电压
9. ΔVR_I : 放大后的差分参考输入电压

由于 A/D 转换器的数字系统设计，其转换的最大值为 8388607，最小值为 -8388608，因此有一个中间值 0。A/D 转换数据公式说明了转换值的变化范围。

A/D 转换数据 (二进制补码, 十六进制值)	十进制值
0x7FFFFFFF	8388607
0x800000	-8388608

上面的 A/D 转换数据表说明了 A/D 转换值的范围。

下图显示直流输入电压值和 A/D 转换数据 (以二进制补码形式表示) 之间的关系。



A/D 转换数据

A/D 转换数据与输入电压和 PGA 的设置有关。A/D 转换输出数据以二进制补码的形式表示，代码的长度为 24 位，最高位为符号位。最高位“0”表示输出为正数，最高位“1”表示输出为负数。最大值是 8388607，最小值是 -8388608。如果输入信号大于最大值，转换后的数据最大不超过 8388607；如果输入信号小于最小值，转换后的数据最小不低于 -8388608。

A/D 转换数据转为电压值

设计者可以通过下面的公式来由转换后的数据推导电压值。

如果 MSB = 0 (转换数据为正数):

输入电压 = (转换数据 × LSB-DCSET) / (PGA × ADGN)

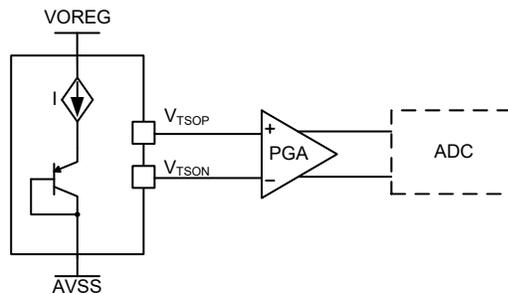
如果 MSB = 1 (转换数据为负数):

输入电压 = (转换数据的补码 × LSB-DCSET) / (PGA × ADGN)

注：补码 = 反码 + 1

温度传感器

该单片机提供了一个内部温度传感器以完善其性能。PGA 输入通道通过选择连接到 V_{TSOP} 或 V_{TSON} ，A/D 转换器可以获得温度信息，设计者可以对 A/D 转换数据做一些调整。下图说明了温度传感器的功能操作。



温度传感器结构

A/D 转换应用范例

范例：使用查询 EOC 的方式来检测转换结束

```
#include bh66f5233.inc
data.section 'data'
adc_result_data_l db ?
adc_result_data_m db ?
adc_result_data_h db ?
code.section 'code'
start:
    clr ADE ; disable ADC interrupt
    mov a, 0C3H ; Power control for PGA, ADC
    mov PWRC, a ; PWRC=11000011, LDO enable, VCM enable,
                ; LDO Bypass disable,
                ; LDO output voltage: 3.3V

    mov a, 000H
    mov PGAC0, a ; PGA gain=1, ADC gain=1, VREF gain=1
    mov a, 080H
    mov PGAC1, a ; VCM=1.25V, INIS, INX, DCSET in default
                ; value
    set VRBUF ; enable buffer for VREF+
    set VRBUFN ; enable buffer for VREF-
    set VREFS ; for using external reference
    clr ADOR2 ; for 10Hz output data rate,
                ; ADOR[2:0]=001, FLMS[2:0]=000

    clr ADOR1
    set ADOR0
    clr FLMS2
    clr FLMS1
    clr FLMS0
    clr ADOFF ; ADC exit power down mode.
    set ADRST ; ADC in reset mode
    clr ADRST ; ADC in conversion (continuous mode)
    clr EOC ; Clear "EOC" flag

loop:
    snz EOC ; Polling "EOC" flag
    jmp loop ; Wait for read data
    clr adc_result_data_h
    clr adc_result_data_m
    clr adc_result_data_l
    mov a, ADRL
    mov adc_result_data_l, a ; Get Low byte ADC value
    mov a, ADRM
    mov adc_result_data_m, a ; Get Middle byte ADC value
    mov a, ADRH
    mov adc_result_data_h, a ; Get High byte ADC value
get_adc_value_ok:
    clr EOC ; Clearing read flag
    jmp loop ; for next data read
end
```

串行接口模块 – SIM

该单片机内有一个串行接口模块，包括两种易与外部设备通信的串行接口：四线 SPI 或两线 I²C 接口。这两种接口具有相当简单的通信协议，单片机可以通过这些接口与传感器、闪存或 EEPROM 内存等硬件设备通信。因为这两种接口共用引脚和寄存器，所以要通过一个 SIMC0 寄存器中的 SIM2~SIM0 位来选择哪一种通信接口。若 SIM 功能使能，可通过上拉电阻控制寄存器选择与输入 / 输出口共用的 SIM 脚的上拉电阻。

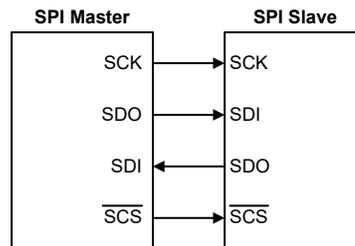
SPI 接口

SPI 接口常用于与外部设备如传感器、闪存或 EEPROM 内存等通信。四线 SPI 接口最初是由摩托罗拉公司研制，是一个有相当简单的通信协议的串行数据接口，这个协议可以简化与外部硬件的编程要求。

SPI 通信模式为全双工模式，且能以主 / 从模式的工作方式进行通信，单片机既可以做为主机，也可以做为从机。虽然 SPI 接口理论上允许一个主机控制多个从机，但此处的 SPI 中只有一个片选信号引脚 \overline{SCS} 。若主机需要控制多个从机，可使用输入 / 输出引脚选择从机。

SPI 接口操作

SPI 接口是一个全双工串行数据传输器。SPI 接口的四线为：SDI、SDO、SCK 和 \overline{SCS} 。SDI 和 SDO 是数据的输入和输出线。SCK 是串行时钟线， \overline{SCS} 是从机的选择线。SPI 的接口引脚与普通 I/O 口和 I²C 的功能脚共用。通过设定 SIMC0/SIMC2 寄存器的对应位，来使能 SPI 接口。SPI 可以通过 SIMC0 寄存器中的 SIMEN 位来除能或使能。连接到 SPI 接口的单片机以从主 / 从模式进行通信，且主机完成所有的数据传输初始化，并控制时钟信号。由于单片机只有一个 \overline{SCS} 引脚，所以只能拥有一个从机设备。可通过软件控制 \overline{SCS} 引脚使能与除能，设置 CSEN 位为“1”使能 \overline{SCS} 功能，设置 CSEN 位为“0”， \overline{SCS} 引脚将处于浮空状态。

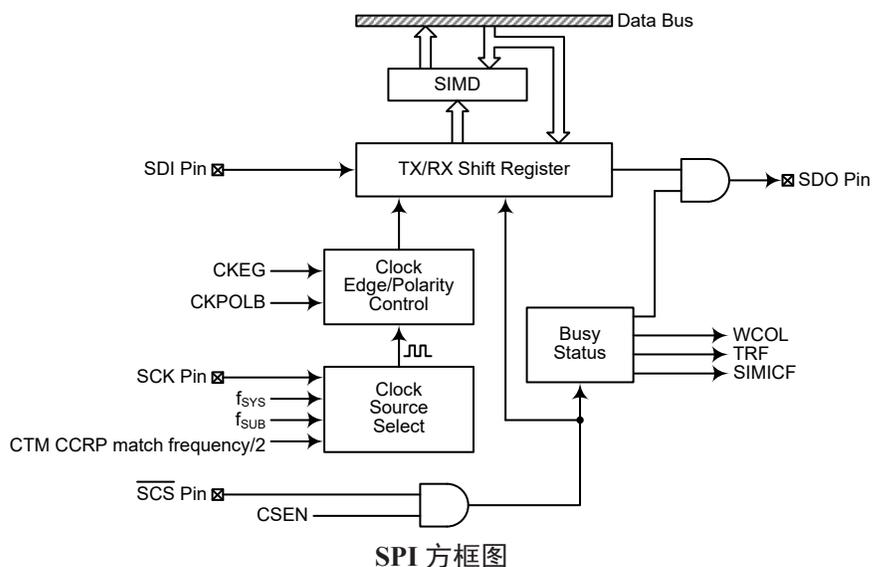


SPI 主 / 从机连接方式

该单片机的 SPI 功能具有以下特点：

- 全双工同步数据传输
- 主从模式
- 最低有效位先传或最高有效位先传的数据传输模式
- 传输完成标志位
- 时钟源上升沿或下降沿有效

SPI 接口状态受很多因素的影响，如单片机处于主机或从机的工作模式和 CSEN、SIMEN 位的状态。



SPI 寄存器

有三个内部寄存器用于控制 SPI 接口的所有操作，其中有一个数据寄存器 SIMD、两个控制寄存器 SIMC0 和 SIMC2。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SIMC0	SIM2	SIM1	SIM0	—	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
SIMC2	D7	D6	CKPOLB	CKEG	MLS	CSEN	WCOL	TRF
SIMD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

SIM 寄存器列表

● **SPI 数据寄存器 – SIMD 寄存器**

SIMD 用于存储发送和接收的数据。这个寄存器由 SPI 和 I²C 功能所共用。在单片机尚未将数据写入到 SPI 总线中时，要传输的数据应先存在 SIMD 中。SPI 总线接收到数据之后，单片机就可以从 SIMD 数据寄存器中读取。所有通过 SPI 传输或接收的数据都必须通过 SIMD 实现。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7~0 **D7~D0**: SIM 数据寄存器 bit 7 ~ bit 0

● **SPI 控制寄存器 – SIMC0 寄存器**

单片机中也有两个控制 SPI 接口功能的寄存器，SIMC0 和 SIMC2。应注意的是 SIMC2 与 I²C 接口功能中的寄存器 SIMA 是同一个寄存器。寄存器 SIMC0 用于控制使能 / 除能功能和设置数据传输的时钟频率。寄存器 SIMC2 用于其它的控制功能如 LSB/MSB 选择，写冲突标志位等。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIM2	SIM1	SIM0	—	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
R/W	R/W	R/W	R/W	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	1	1	1	—	0	0	0	0

Bit 7~5 **SIM2~SIM0: SIM 工作模式控制位**

- 000: SPI 主机模式; SPI 时钟为 $f_{sys}/4$
- 001: SPI 主机模式; SPI 时钟为 $f_{sys}/16$
- 010: SPI 主机模式; SPI 时钟为 $f_{sys}/64$
- 011: SPI 主机模式; SPI 时钟为 f_{sub}
- 100: SPI 主机模式; SPI 时钟为 CTM CCRP 匹配频率 /2
- 101: SPI 从机模式
- 110: I²C 从机模式
- 111: 未使用模式

这几位用于设置 SIM 功能的工作模式，用于选择 SPI 的主从模式和 SPI 的主机时钟频率及 I²C 或 SPI 功能。SPI 时钟源可来自于系统时钟也可以选择来自 f_{sub} 或 CTM。若选择的是作为 SPI 从机，则其时钟源从外部主机而得。

Bit 4 未定义，读为“0”

Bit 3~2 **SIMDEB1~SIMDEB0: I²C 去抖时间选择位**

这两个位只有在 SIM 设置成 I²C 接口模式时才有效。请参考 I²C 寄存器部分。

Bit 1 **SIMEN: SIM 控制位**

- 0: 除能
- 1: 使能

此位为 SIM 接口的开 / 关控制位。此位为“0”时，SIM 接口除能，SDI、SDO、SCK 和 SCS 或 SDA 和 SCL 脚将失去 SPI 或 I²C 功能，SIM 工作电流减小到最小值。此位为“1”时，SIM 接口使能。若 SIM 经由 SIM2~SIM0 位设置为工作在 SPI 接口，当 SIMEN 位由低到高转变时，SPI 控制寄存器中的设置不会发生变化，其首先应在应用程序中初始化。若 SIM 经由 SIM2~SIM0 位设置为工作在 I²C 接口，当 SIMEN 位由低到高转变时，I²C 控制寄存器中的设置，如 HTX 和 TXAK，将不会发生变化，其首先应在应用程序中初始化，此时相关 I²C 标志，如 HCF、HAAS、HBB、SRW 和 RXAK，将被设置为其默认状态。

Bit 0 **SIMICF: SIM SPI 未完成标志位**

- 0: 未发生
- 1: 发生

此位仅当 SIM 配置在 SPI 从机模式时有效。如果 SPI 工作在从机模式且 SIMEN 和 CSEN 位都为“1”，但在 SPI 数据传输完全结束前 SCS 线被外部主机拉高，SIMICF 和 TRF 位都会被置高。在这种情况下，如果相应的中断功能使能将产生一个中断。然而，如果 SIMICF 位是由软件应用程序设为 1，那么 TRF 位将不会置高。

● SPI 控制寄存器 – SIMC2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	CKPOLB	CKEG	MLS	CSEN	WCOL	TRF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

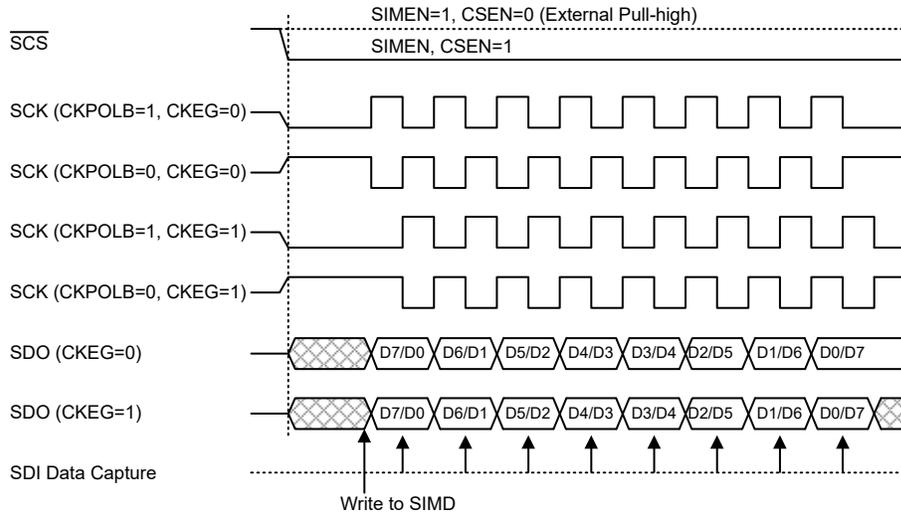
- Bit 7~6 **D7~D6:** 未定义位
用户可通过软件程序对这两位进行读写。
- Bit 5 **CKPOLB:** 时钟线的基础状态位
0: 当时钟无效时, SCK 口为高电平
1: 当时钟无效时, SCK 口为低电平
此位决定了时钟线的基础状态, 当时钟无效时, 若此位为高, SCK 为低电平, 若此位为低, SCK 为高电平。
- Bit 4 **CKEG:** SPI 的 SCK 有效时钟边沿类型位
CKPOLB=0
0: SCK 为高电平且在 SCK 上升沿抓取数据
1: SCK 为高电平且在 SCK 下降沿抓取数据
CKPOLB=1
0: SCK 为低电平且在 SCK 下降沿抓取数据
1: SCK 为低电平且在 SCK 上升沿抓取数据
CKEG 和 CKPOLB 位用于设置 SPI 总线上时钟信号输入和输出方式。在执行数据传输前, 这两位必须被设置, 否则将产生错误的时钟边沿信号。CKPOLB 位决定时钟线的基本状态, 若时钟无效且此位为高, 则 SCK 为低电平, 若时钟无效且此位为低, 则 SCK 为高电平。CKEG 位决定有效时钟边沿类型, 取决于 CKPOLB 的状态。
- Bit 3 **MLS:** SPI 数据移位命令位
0: LSB
1: MSB
数据移位选择位, 用于选择数据传输时高位优先传输还是低位优先传输。此位设置为高时高位优先传输, 为低时低位优先传输。
- Bit 2 **CSEN:** SPI \overline{SCS} 引脚控制位
0: 除能
1: 使能
CSEN 位用于 \overline{SCS} 引脚的使能 / 除能控制。此位为低时, \overline{SCS} 除能并处于浮空状态。此位为高时, SCS 作为选择脚。
- Bit 1 **WCOL:** SPI 写冲突标志位
0: 无冲突
1: 冲突
WCOL 标志位用于监测数据冲突的发生。此位为高时, 数据在传输时被写入 SIMD 寄存器。若数据正在被传输时, 此操作无效。此位可被应用程序清零。
- Bit 0 **TRF:** SPI 发送 / 接收结束标志位
0: 数据正在发送
1: 数据发送结束
TRF 位为发送 / 接收结束标志位, 当 SPI 数据传输结束时, 此位自动置为高, 但须通过应用程序设置为“0”。此位也可用于产生中断。

SPI 通信

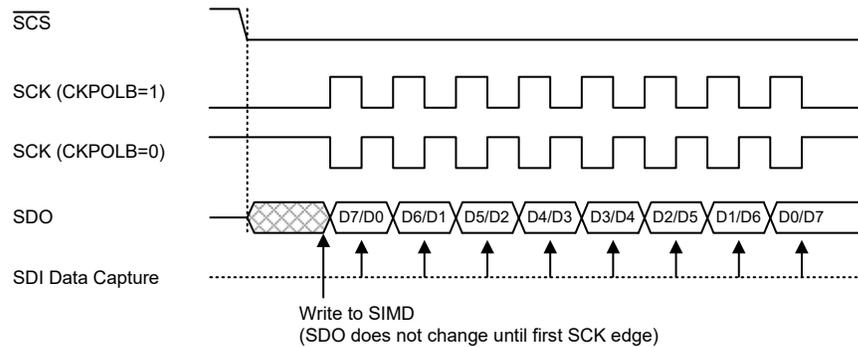
将 SIMEN 设置为高, 使能 SPI 功能之后, 单片机处于主机模式, 当数据写入到寄存器 SIMD 的同时传输 / 接收开始进行。数据传输完成时, TRF 位将自动被置位但清除只能通过应用程序完成。单片机处于从机模式时, 收到主机发来的信号之后, 会传输 SIMD 中的数据, 而且在 SDI 引脚上的数据也会被移位到 SIMD 寄存器中。主机应在输出时钟信号之前先输出一个 \overline{SCS} 信号以使能

从机，从机的数据传输功能也应在与 \overline{SCS} 信号相关的适当时候准备就绪，这由 CKPOLB 和 CKEG 位决定。所附时序图表明了 在 CKPOLB 和 CKEG 位各种设置情况下从机数据与 \overline{SCS} 信号的关系。

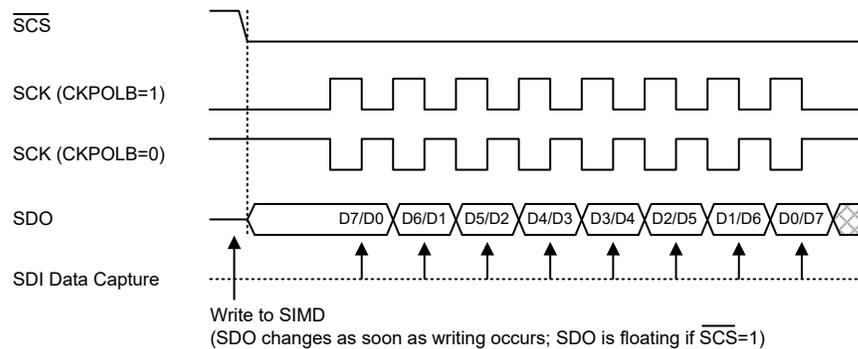
即使在单片机处于空闲模式，SPI 功能仍将继续执行。



SPI 主机模式时序

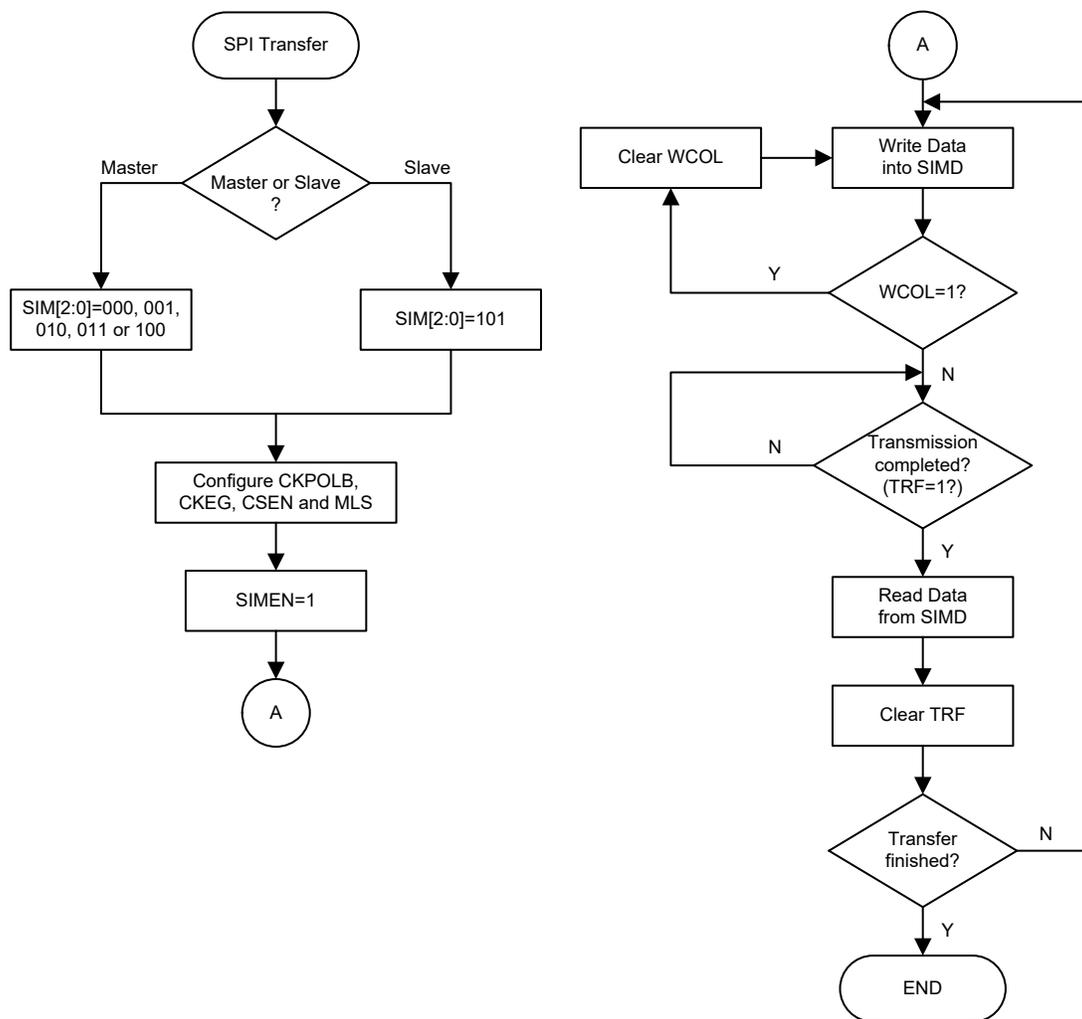


SPI 从机模式时序 - CKEG=0



Note: For SPI slave mode, if SIMEN=1 and CSEN=0, SPI is always enabled and ignores the \overline{SCS} level.

SPI 从机模式时序 - CKEG=1



SPI 传输控制流程图

SPI 使能 / 除能

设置 CSEN=1、 $\overline{\text{SCS}}=0$ 将使能 SPI 总线，然后等待写数据到 SIMD 寄存器 (TXRX 缓存器)。单片机处于主机模式，数据写入 SIMD 寄存器后，自动开始数据传输或接收操作。数据传输完成时，TRF 位将自动被置位。单片机处于从机模式，SCK 引脚上收到脉冲信号之后，会传输 TXRX 中的数据，或将 SDI 引脚上的数据移入。

当 SPI 总线除能时，SCK、SDI、SDO、 $\overline{\text{SCS}}$ 可通过相应的引脚共用控制位选择作为 I/O 口或其它功能引脚使用。

SPI 操作步骤

四线制 SPI 接口可完成所有主 / 从模式通信工作。

在 SIMC2 寄存器中，CSEN 位控制 SPI 接口的所有功能。设置此位为高， \overline{SCS} 信号线有效将使能 SPI 接口。设置此位为低，SPI 接口将除能， \overline{SCS} 信号线处于浮空状态因此不能控制 SPI 接口。CSEN 位和 SIMC0 寄存器中的 SIMEN 位设置为高，使得 SDI 信号线处于浮空状态且 SDO 信号线为高电平。主机模式中，如果 SCK 信号线为高还是低取决于 SIMC2 寄存器中的时钟极性选择位 CKPOLB。从机模式中，SCK 信号线处于浮空状态。如果 SIMEN 位设置为低，SPI 接口被除能，通过设置相应引脚共用控制位， \overline{SCS} 、SDI、SDO 和 SCK 可作为 I/O 口或其它功能引脚使用。主机模式中，当数据被写入 SIMD 寄存器后，主机完成所有的数据传输初始化，并控制时钟信号。从机模式中，由外部主机发出数据传送 / 接收时钟信号。下面介绍主从模式中数据传输步骤。

主机模式：

- 步骤 1
设置 SIMC0 控制寄存器中的 SIM2~SIM0 位，选择 SPI 主机模式和时钟源。
- 步骤 2
设置 CSEN 和 MLS 位，选择高位或低位数据优先传送，这必须与从机设备一致。
- 步骤 3
设置 SIMC0 控制寄存器中的 SIMEN 位，使能 SPI 接口功能。
- 步骤 4
对于写操作：写数据到 SIMD 寄存器，实际上此时数据会被存储在 TXRX 缓存器中。再使用 SCK 和 \overline{SCS} 信号线将数据输出。跳至步骤 5。
对于读操作：从 SDI 信号线移入的数据将被存储在 TXRX 缓存器中，直到所有数据接收完毕，此时数据全部锁存至 SIMD 寄存器。
- 步骤 5
检测 WCOL 位，若此位为高，则发生数据冲突并跳回至步骤 4；若为低，则继续执行下面的步骤。
- 步骤 6
检测 TRF 位或等待 SPI 串行总线中断发生。
- 步骤 7
从 SIMD 寄存器中读数据。
- 步骤 8
清除 TRF。
- 步骤 9
跳回至步骤 4。

从机模式：

- 步骤 1
设置 SIMC0 控制寄存器中的 SIM2~SIM0 位，选择 SPI 从机模式。
- 步骤 2
设置 CSEN 和 MLS 位，选择高位或低位数据优先传送，这必须与主机设备一致。
- 步骤 3
设置 SIMC0 控制寄存器中的 SIMEN 位，使能 SPI 接口功能。

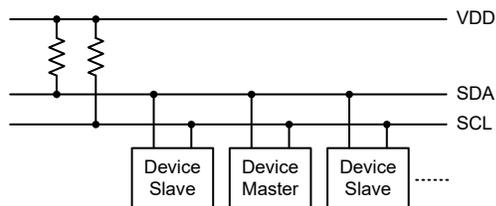
- 步骤 4
对于写操作：写数据到 SIMD 寄存器，实际上此时数据会被存储在 TXRX 缓存器中。等待主机时钟 SCK 信号和 SCS 信号。跳至步骤 5。
对于读操作：从 SDI 信号线移入的数据将被存储在 TXRX 缓存器中，直到所有数据接收完毕，此时数据全部锁存至 SIMD 寄存器。
- 步骤 5
检测 WCOL 位，若此位为高，则发生数据冲突并跳回至步骤 4；若为低，则继续执行下面的步骤。
- 步骤 6
检测 TRF 位或等待 SPI 串行总线中断发生。
- 步骤 7
从 SIMD 寄存器中读数据。
- 步骤 8
清除 TRF。
- 步骤 9
跳回至步骤 4。

错误侦测

SIMC2 寄存器中的 WCOL 位用于数据传输期间监测数据冲突的发生。此位由 SPI 串行接口设置为高，而由应用程序来清除为零。在数据传输期间如果写数据到 SIMD，此位被置高提示数据冲突发生，并阻止数据继续被写入。

I²C 接口

I²C 可以和传感器、EEPROM 内存等外部硬件接口进行通信。最初是由飞利浦公司研制，是适用于同步串行数据传输的双线式低速串行接口。I²C 接口具有两线通信，非常简单的通信协议和在同一总线上和多个设备进行通信的能力的优点，使之在很多的应用场合中大受欢迎。

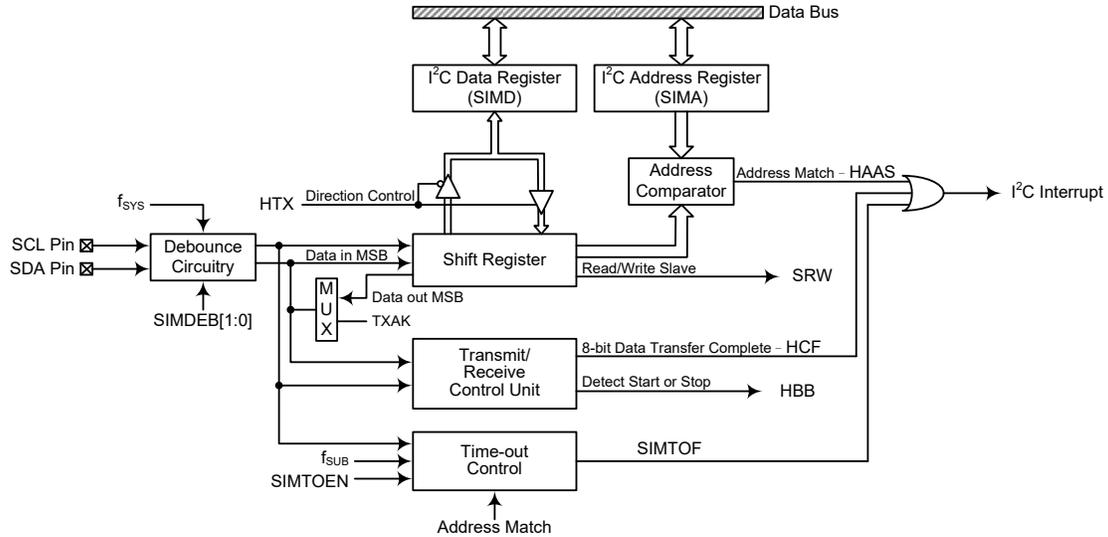


I²C 主从总线连接图

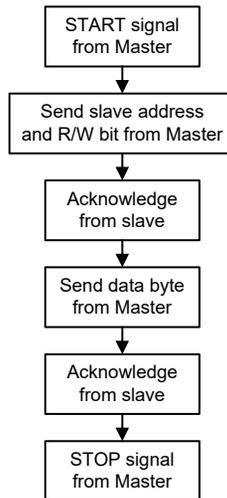
I²C 接口操作

I²C 串行接口是一个双线的接口，有一条串行数据线 SDA 和一条串行时钟线 SCL。由于可能有多个设备在同一条总线上相互连接，所以这些设备的输出都是开漏型输出。因此应在这些输出上都应加上拉电阻。应注意的是，I²C 总线上的每个设备都没有选择线，但分别与唯一的地址一一对应，用于 I²C 通信。

如果有两个设备通过双向的 I²C 总线进行通信，那么就存在一个主机和一个从机。主机和从机都可以用于传输和接收数据，但只有主机才可以控制总线动作。那些处于从机模式的设备，要在 I²C 总线上传输数据只有两种方式，一是从机发送模式，二是从机接收模式。即使 I²C 设备被激活，上拉电阻控制功能和 SCL/SDA 引脚功能仍有效，其上拉电阻功能由相关上拉电阻控制寄存器控制。



I²C 方框图



SIMDEB1 和 SIMDEB0 位决定 I²C 接口的去抖时间。这个功能可以使用内部时钟在外部时钟上增加一个去抖间隔，减小时钟线上毛刺发生的可能性，以避免单片机发生误动作。如果选择了这个功能，去抖时间可以选择 2 个或 4 个系统时钟。为了达到需要的 I²C 数据传输速度，系统时钟 f_{SYS} 和 I²C 去抖时间之间存在一定的关系。I²C 标准模式或者快速模式下，用户需注意所选的系统时钟频率与标准匹配去抖时间的设置，其具体关系如下表所示。

I ² C 去抖时间选择	I ² C 标准模式 (100kHz)	I ² C 快速模式 (400kHz)
无去抖时间	$f_{SYS} > 2 \text{ MHz}$	$f_{SYS} > 5 \text{ MHz}$
2 个系统时钟去抖时间	$f_{SYS} > 4 \text{ MHz}$	$f_{SYS} > 10 \text{ MHz}$
4 个系统时钟去抖时间	$f_{SYS} > 8 \text{ MHz}$	$f_{SYS} > 20 \text{ MHz}$

I²C 最小 f_{SYS} 频率

I²C 寄存器

I²C 总线有三个控制寄存器 SIMC0、SIMC1 和 SIMTOC，一个地址寄存器 SIMA 以及一个数据寄存器 SIMD。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SIMC0	SIM2	SIM1	SIM0	–	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
SIMC1	HCF	HAAS	HBB	HTX	TXAK	SRW	IAMWU	RXAK
SIMD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SIMA	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	D0
SIMTOC	SIMTOEN	SIMTOF	SIMTOS5	SIMTOS4	SIMTOS3	SIMTOS2	SIMTOS1	SIMTOS0

I²C 寄存器列表

● I²C 数据寄存器 – SIMD 寄存器

SIMD 用于存储发送和接收的数据。这个寄存器由 SPI 和 I²C 功能所共用。在单片机将数据写入到 I²C 总线之前，要传输的数据应先存在 SIMD 中。I²C 总线接收到数据之后，单片机就可以从 SIMD 数据寄存器中读取。所有通过 I²C 传输或接收的数据都必须通过 SIMD 实现。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7~0 **D7~D0**: SIM 数据寄存器位 bit 7 ~ bit 0

● I²C 地址寄存器 – SIMA 寄存器

SIMA 寄存器也在 SPI 接口功能中使用，但其名称改为 SIMC2。SIMA 寄存器用于存放 7 位从机地址，寄存器 SIMA 中的 bit 7~bit 1 是单片机的从机地址，bit 0 未定义。如果接至 I²C 的主机发送出的地址和寄存器 SIMA 中存储的地址相符，那么就选中了这个从机。应注意的是寄存器 SIMA 和 SPI 接口使用的寄存器 SIMC2 共用同一个寄存器地址。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~1 **A6~A0**: I²C 从机地址位
A6~A0 是从机地址 bit 6 ~ bit 0。

Bit 0 **D0**: 保留位，可读写。

● I²C 控制寄存器 – SIMC0 寄存器

单片机中有三个控制 I²C 接口功能的寄存器，SIMC0、SIMC1 和 SIMTOC。寄存器 SIMC0 用于控制使能 / 除能功能和设置数据传输的时钟频率。寄存器 SIMC1 包括多个用于指示 I²C 传输状态的相关标志位。SIMTOC 寄存器用于控制 I²C 超时功能，此寄存器在 I²C 超前一节介绍。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIM2	SIM1	SIM0	—	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
R/W	R/W	R/W	R/W	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	1	1	1	—	0	0	0	0

Bit 7~5 **SIM2~SIM0: SIM 工作模式控制位**

- 000: SPI 主机模式; SPI 时钟为 $f_{sys}/4$
- 001: SPI 主机模式; SPI 时钟为 $f_{sys}/16$
- 010: SPI 主机模式; SPI 时钟为 $f_{sys}/64$
- 011: SPI 主机模式; SPI 时钟为 f_{sub}
- 100: SPI 主机模式; SPI 时钟为 CTM CCRP 匹配频率 /2
- 101: SPI 从机模式
- 110: I²C 从机模式
- 111: 未使用模式

这几位用于设置 SIM 功能的工作模式，用于选择 SPI 的主从模式和 SPI 的主机时钟频率及 I²C 或 SPI 功能。SPI 时钟源可来自于系统时钟和 f_{sub} 也可以选择来自 CTM。若选择的是作为 SPI 从机，则其时钟源从外部主机而得。

Bit 4 未定义，读为“0”

Bit 3~2 **SIMDEB1~SIMDEB0: I²C 去抖时间选择位**

- 00: 无去抖时间
- 01: 2 个系统时钟去抖时间
- 1x: 4 个系统时钟去抖时间

当设置 SIM2~SIM0 位为“110”将 SIM 设置为 I²C 接口功能时，这两个位用于选择 I²C 去抖时间。

Bit 1 **SIMEN: SIM 控制位**

- 0: 除能
- 1: 使能

此位为 SIM 接口的开 / 关控制位。此位为“0”时，SIM 接口除能，SDI、SDO、SCK 和 SCS 或 SDA 和 SCL 脚将失去 SPI 或 I²C 功能，SIM 工作电流减小到最小值。此位为“1”时，SIM 接口使能。若 SIM 经由 SIM2~SIM0 位设置为工作在 SPI 接口，当 SIMEN 位由低到高转变时，SPI 控制寄存器中的设置不会发生变化，其首先应在应用程序中初始化。若 SIM 经由 SIM2~SIM0 位设置为工作在 I²C 接口，当 SIMEN 位由低到高转变时，I²C 控制寄存器中的设置，如 HTX 和 TXAK，将不会发生变化，其首先应在应用程序中初始化，此时相关 I²C 标志，如 HCF、HAAS、HBB、SRW 和 RXAK，将被设置为其默认状态。

Bit 0 **SIMICF: SIM SPI 未完成标志位**

此位仅当 SIM 配置在 SPI 从机模式时有效。请参考 SPI 寄存器部分。

● I²C 控制寄存器 – SIMC1 寄存器

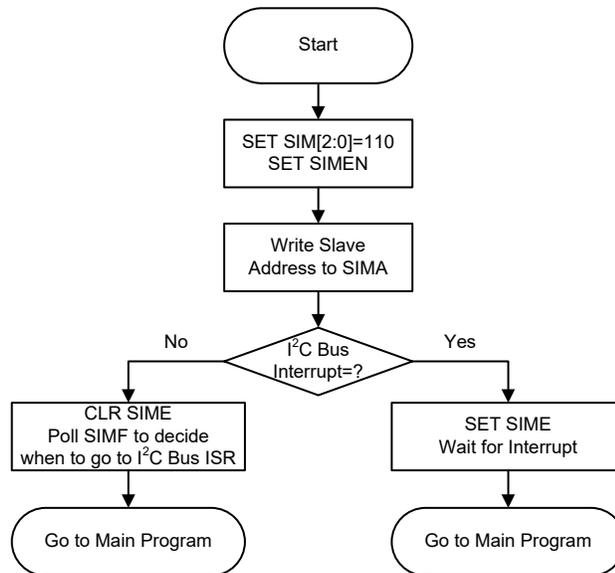
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	HCF	HAAS	HBB	HTX	TXAK	SRW	IAMWU	RXAK
R/W	R	R	R	R/W	R/W	R	R/W	R
POR	1	0	0	0	0	0	0	1

- Bit 7 **HCF**: I²C 总线数据传输结束标志位
0: 数据正在被传输
1: 8 位数据传输完成
数据正在传输时该位为低。当 8 位数据传输完成时, 此位为高并产生一个中断。
- Bit 6 **HAAS**: I²C 地址匹配标志位
0: 地址不匹配
1: 地址匹配
此标志位用于决定从机地址是否与主机发送的地址相同。若地址匹配此位为高, 否则此位为低。
- Bit 5 **HBB**: I²C 总线忙标志位
0: I²C 总线闲
1: I²C 总线忙
当检测到 START 信号时 I²C 忙, 此位变为高电平。当检测到 STOP 信号时 I²C 总线空闲, 该位变为低电平。
- Bit 4 **HTX**: 从机处于发送或接收模式标志位
0: 从机处于接收模式
1: 从机处于发送模式
- Bit 3 **TXAK**: I²C 总线发送应答标志位
0: 从机发送应答标志
1: 从机没有发送应答标志
从机接收完 8 位数据之后, 该位将在第九个从机时钟时被传到总线上。如果从机想要接收更多的数据, 则应在接收数据之前将此位设置为“0”。
- Bit 2 **SRW**: I²C 从机读 / 写位
0: 从机应处于接收模式
1: 从机应处于发送模式
SRW 位是从机读写位。决定主机是否希望传输数据或接收来自 I²C 总线的的数据。当传输地址和从机的地址相同时, HAAS 位会被设置为高, 从机将检测 SRW 位来决定进入发送模式还是接收模式。如果 SRW 位为高时, 主机请求从总线上读数据, 此时从机处于传输模式。当 SRW 位为“0”时, 主机往总线上写数据, 从机处于接收模式以读取数据。
- Bit 1 **IAMWU**: I²C 地址匹配唤醒控制位
0: 除能
1: 使能
此位设置为“1”则使能 I²C 地址匹配使系统从休眠或空闲模式中唤醒的功能。若进入休眠或空闲模式前 IAMWU 已经置高以使能 I²C 地址匹配唤醒功能, 在系统唤醒后须软件清除此位以确保单片机正确地运行。
- Bit 0 **RXAK**: I²C 总线接收应答标志位
0: 从机接收到应答标志
1: 从机没有接收到应答标志
RXAK 位是接收应答标志位。如果 RXAK 位为“0”, 即表示 8 位数据传输之后, 从机在第九个时钟有接受到一个应答信号。如果从机处于发送状态, 从机作为发送方会检查 RXAK 位来判断主机接收方是否愿意继续接收下一个字节。因此发送方会一直发送数据, 直到 RXAK 为“1”时才停止发送数据。这时, 发送方将释放 SDA 线, 主机方可发出停止信号从而释放 I²C 总线。

I²C 总线通信

I²C 总线上的通信需要四步完成，一个起始信号，一个从机地址发送，一个数据传输，还有一个停止信号。当起始信号被写入 I²C 总线时，总线上的所有从机都会接收到这个起始信号并且被通知总线上即将有数据到达。数据的前 7 位是从机地址，高位在前，低位在后。如果发出的地址和从机地址匹配，SIMC1 寄存器的 HAAS 位会被置位，同时产生 I²C 中断。进入中断服务程序后，系统要检测 HAAS 位和 SIMTOF 位，以判断 I²C 总线中断是来自从机地址匹配，还是来自 8 位数据传输完毕，或是来自 I²C 超时。在数据传输中，要注意的是，在 7 位从机地址被发送后，接下来的一位，即第 8 位，是读 / 写控制位，该位的值会反映到 SRW 位中。从机通过检测 SRW 位以确定自己是要进入发送模式还是接收模式。在 I²C 总线开始传送数据前，需要先初始化 I²C 总线，初始化 I²C 总线步骤如下：

- 步骤 1
设置 SIMC0 寄存器中 SIM2~SIM0 位为“110”和 SIMEN 位为“1”，以能使 I²C 总线。
- 步骤 2
向 I²C 总线地址寄存器 SIMA 写入从机地址。
- 步骤 3
设置 SIME 位以能使能 SIM 中断。



I²C 总线初始化流程图

I²C 总线起始信号

起始信号只能由连接 I²C 总线的主机产生，而不是由从机产生。总线上的所有从机都可以侦测到起始信号。如果有从机侦测到起始信号，则表明 I²C 总线处于忙碌状态，并会置位 HBB。起始信号是指在 SCL 为高电平时，SDA 线上发生从高到低的电平变化。

从机地址

总线上的所有从机都会侦测由主机发出的起始信号。发送起始信号后，紧接着主机会发送从机地址以选择要进行数据传输的从机。所有在 I²C 总线上的从机接收到 7 位地址数据后，都会将其与各自内部的地址进行比较。如果从机从主机上接收到的地址与自身内部的地址相匹配，则会产生一个 I²C 总线中断信号。地址位接下来的一位为读 / 写状态位 (即第 8 位)，将被保存到 SIMC1 寄存器的 SRW 位，从机随后发出一个低电平应答信号 (即第 9 位)。当从机地址匹配时，从机会将状态标志位 HAAS 置位。

I²C 总线中断有三个中断源，当程序运行至中断服务子程序时，通过检测 HAAS 位和 SIMTOF 位，以判断 I²C 总线中断是来自从机地址匹配，还是来自 8 位数据传递完毕，或是来自 I²C 超时。当是从机地址匹配发生中断时，则从机或是用于发送模式并将数据写进 SIMD 寄存器，或是用于接收模式并从 SIMD 寄存器中读取空值以释放 SCL 线。

I²C 总线读 / 写信号

SIMC1 寄存器的 SRW 位用来表示主机是要从 I²C 总线上读取数据还是要将数据写到 I²C 总线上。从机通过检测该位以确定自己是作为发送方还是接收方。当 SRW 置 “1”，表示主机要从 I²C 总线上读取数据，从机则作为发送方，将数据写到 I²C 总线；当 SRW 清 “0”，表示主机要写数据到 I²C 总线上，从机则做为接收方，从 I²C 总线上读取数据。

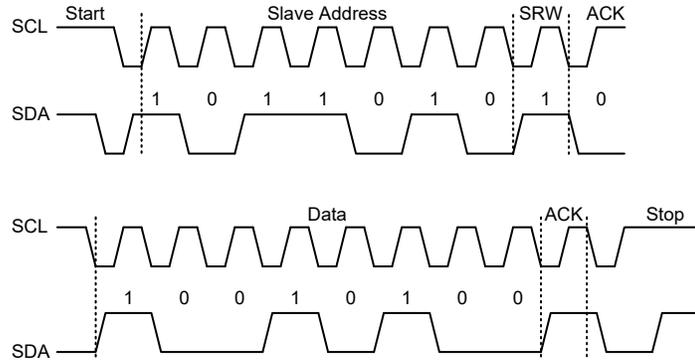
I²C 总线从机地址应答信号

主机发送呼叫地址后，当 I²C 总线上的任何从机内部地址与其匹配时，会发送一个应答信号。此应答信号会通知主机有从机已经接收到了呼叫地址。如果主机没有收到应答信号，则主机必须发送停止 (STOP) 信号以结束通信。当 HAAS 为高时，表示从机接收到的地址与自己内部地址匹配，则从机需检查 SRW 位，以确定自己是作为发送方还是作为接收方。如果 SRW 位为高，从机须设置成发送方，这样会置位 SIMC1 寄存器的 HTX 位。如果 SRW 位为低，从机须设置成接收方，这样会清零 SIMC1 寄存器的 HTX 位。

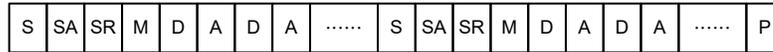
I²C 总线数据和应答信号

在从机确认接收到从地址后，会进行 8 位宽度的数据传输。这个数据传输顺序是的高位在前，低位在后。接收方在接收到 8 位数据后必须发出一个应答信号 (“0”) 以继续接收下一个数据。如果从机发送方没接收到来自主机接收方的应答信号，发送方将释放 SDA 线，此时主机方可发出 STOP 信号以释放 I²C 总线。所传送的数据存储在 SIMD 寄存器中。如果设置成发送方，从机必须先将欲传输的数据写到 SIMD 寄存器中；如果设置成接收方，从机必须从 SIMD 寄存器读取数据。

当接收器想要继续接收下一个数据时，必须在第 9 个时钟发出应答信号 (TXAK)。被设为发送方的从机将检测寄存器 SIMC1 中的 RXAK 位以判断是否传输下一个字节的数据，如果从机不传输下一个字节，那么它将释放 SDA 线并等待接收主机的停止信号。

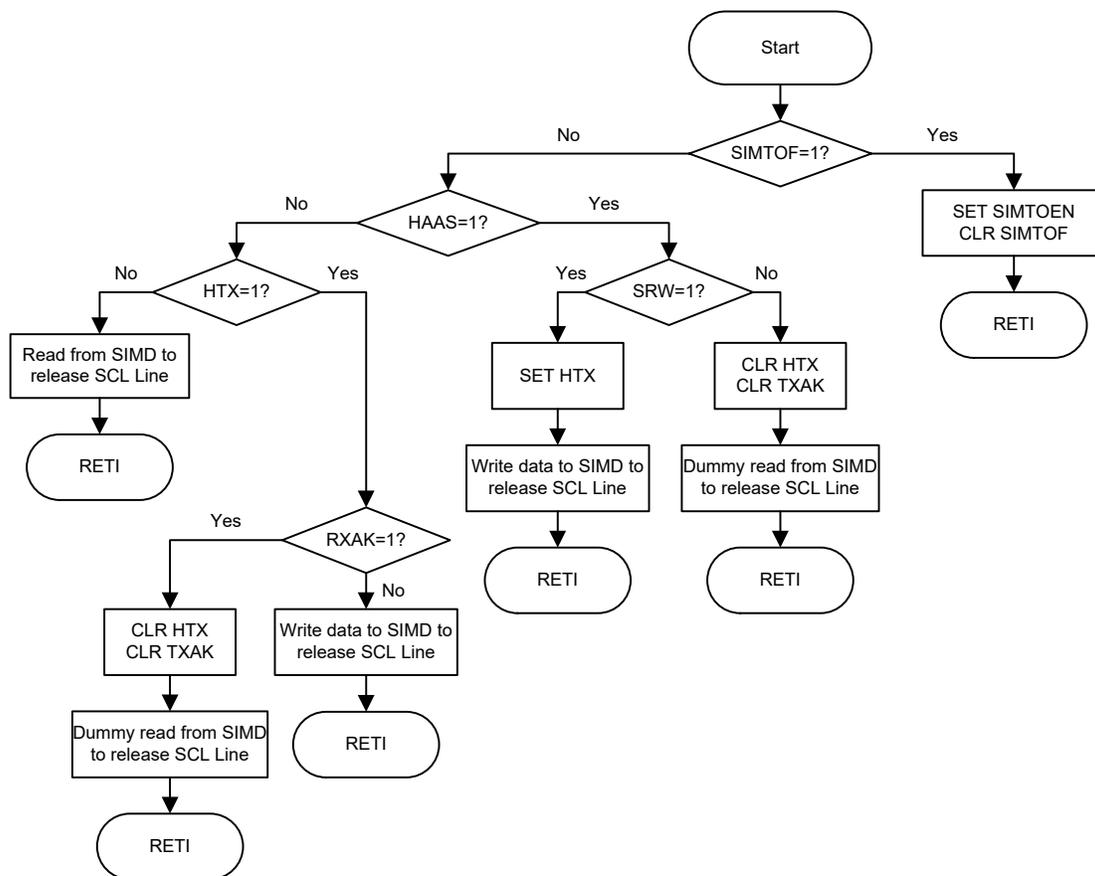


S=Start (1 bit)
SA=Slave Address (7 bits)
SR=SRW bit (1 bit)
M=Slave device send acknowledge bit (1 bit)
D=Data (8 bits)
A=ACK (RXAK bit for transmitter, TXAK bit for receiver, 1 bit)
P=Stop (1 bit)



注：* 当从机地址匹配时，单片机必须选择设置为发送模式还是接收模式。若设置为发送模式，需写数据至 SIMD 寄存器；若设置为接收模式，需立即从 SIMD 寄存器中虚读数据以释放 SCL 线。

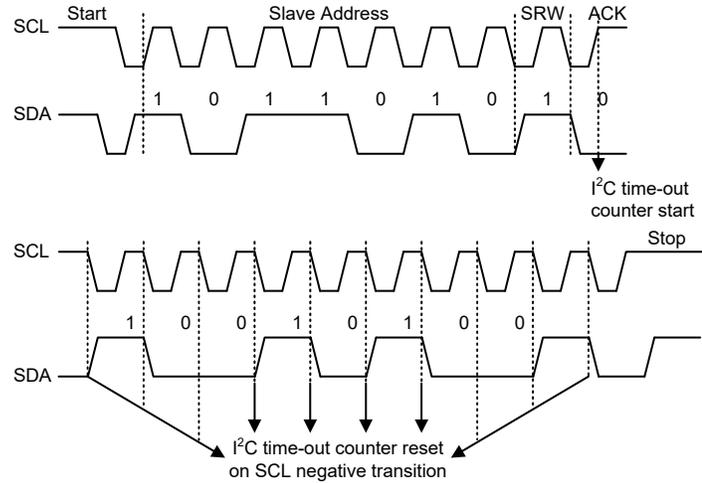
I²C 通信时序图



I²C 总线 ISR 流程图

I²C 超时控制

超时功能可减少 I²C 接收错误的时钟源而引起的锁死问题。如果连接到 I²C 总线的时钟源经过一段时间还未接收到，则在一定的超时周期后，I²C 电路和寄存器将复位。超时计数器在 I²C 总线“START”和“地址匹配”条件下开始计数，且在 SCL 下降沿清零。在下一个 SCL 下降沿到来之前，如果超时时间大于 SIMTOC 寄存器指定的超时周期，则超时发生。I²C “STOP”条件发生时超时功能终止。



I²C 超时时序图

当 I²C 超时计数器溢出时，计数器将停止计数，SIMTOEN 位被清零，且 SIMTOF 位被置高以表明超时计数器中断发生。超时计数器中断使用的也是 I²C 中断向量。当 I²C 超时发生时，I²C 内部电路会被复位，寄存器也将发生如下复位情况。

寄存器	I ² C 超时发生后
SIMD, SIMA, SIMC0	保持不变
SIMC1	复位至 POR

超时发生后的 I²C 寄存器

SIMTOF 标志位由应用程序清零。共有 64 个超时周期，可通过 SIMTOC 寄存器的 SIMTOSn 位进行选择。超时周期可通过公式计算： $((1\sim64) \times (32/f_{SUB}))$ 。由此可得超时周期范围为 1ms~64ms。

● SIMTOC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIMTOEN	SIMTOF	SIMTOS5	SIMTOS4	SIMTOS3	SIMTOS2	SIMTOS1	SIMTOS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **SIMTOEN**: I²C 超时控制位
0: 除能
1: 使能

Bit 6 **SIMTOF**: I²C 超时标志位
0: 超时未发生
1: 超时发生

Bit 5~0 **SIMTOS5~SIMTOS0**: I²C 超时时间选择位
I²C 超时时钟源是 $f_{SUB}/32$
I²C 超时时间计算方法： $([SIMTOS[5:0]+1] \times (32/f_{SUB}))$

中断

中断是单片机一个重要功能。当外部事件或内部功能如定时器模块或 A/D 转换器有效，并且产生中断时，系统会暂时中止当前的程序而转到执行相对应的中断服务程序。此单片机提供多个外部中断和内部中断功能，外部中断由 INT0~INT1 引脚动作产生，而内部中断由各种内部功能，如定时器模块、时基、LVD、EEPROM 和 A/D 转换器等产生。

中断寄存器

中断控制基本上是在一定单片机条件发生时设置请求标志位，应用程序中中断使能位的设置是通过位于专用数据存储中的一系列寄存器控制的。寄存器总的分为三类。第一类是 INTC0~INTC2 寄存器，用于设置基本的中断；第二类是 MFI0~MFI1 寄存器，用于设置多功能中断；最后一种有 INTEG 寄存器，用于设置外部中断边沿触发类型。

寄存器中含有中断控制位和中断请求标志位。中断控制位用于使能或除能各种中断，中断请求标志位用于存放当前中断请求的状态。它们都按照特定的模式命名，前面表示中断类型的缩写，紧接着的字母“E”代表使能/除能位，“F”代表请求标志位。

功能	使能位	请求标志位	注释
总中断	EMI	—	—
INTn 脚	INTnE	INTnF	n=0 or 1
SIM	SIME	SIMF	—
时基	TBnE	TBnF	n=0 or 1
A/D 转换器	ADE	ADF	—
多功能	MFnE	MFnF	n=0 or 1
EEPROM	DEE	DEF	—
LVD	LVE	LVF	—
CTM	CTMPE	CTMPF	—
	CTMAE	CTMAF	—

中断寄存器位命名模式

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
INTEG	—	—	—	—	INT1S1	INT1S0	INT0S1	INT0S0
INTC0	—	ADF	INT1F	INT0F	ADE	INT1E	INT0E	EMI
INTC1	—	MF1F	SIMF	MFOF	—	MF1E	SIME	MF0E
INTC2	—	—	TB1F	TB0F	—	—	TB1E	TB0E
MFI0	—	—	CTMAF	CTMPF	—	—	CTMAE	CTMPE
MFI1	—	—	DEF	LVF	—	—	DEE	LVE

中断寄存器列表

• INTEG 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	INT1S1	INT1S0	INT0S1	INT0S0
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3~2 **INT1S1~INT1S0**: INT1 脚中断边沿控制位
 00: 除能
 01: 上升沿
 10: 下降沿
 11: 双沿

Bit 1~0 **INT0S1~INT0S0**: INT0 脚中断边沿控制位
 00: 除能
 01: 上升沿
 10: 下降沿
 11: 双沿

• INTC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	ADF	INT1F	INT0F	ADE	INT1E	INT0E	EMI
R/W	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 未定义，读为“0”

Bit 6 **ADF**: A/D 转换器中断请求标志位
 0: 无请求
 1: 中断请求

Bit 5 **INT1F**: INT1 中断请求标志位
 0: 无请求
 1: 中断请求

Bit 4 **INT0F**: INT0 中断请求标志位
 0: 无请求
 1: 中断请求

Bit 3 **ADE**: A/D 转换器中断控制位
 0: 除能
 1: 使能

Bit 2 **INT1E**: INT1 中断控制位
 0: 除能
 1: 使能

Bit 1 **INT0E**: INT0 中断控制位
 0: 除能
 1: 使能

Bit 0 **EMI**: 总中断控制位
 0: 除能
 1: 使能

• INTC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	MF1F	SIMF	MF0F	—	MF1E	SIME	MF0E
R/W	—	R/W	R/W	R/W	—	R/W	R/W	R/W
POR	—	0	0	0	—	0	0	0

- Bit 7 未定义，读为“0”
- Bit 6 **MF1F**: 多功能中断 1 请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 5 **SIMF**: SIM 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 4 **MF0F**: 多功能中断 0 请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 3 未定义，读为“0”
- Bit 2 **MF1E**: 多功能中断 1 控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 1 **SIME**: SIM 中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 0 **MF0E**: 多功能中断 0 控制位
0: 除能
1: 使能

• INTC2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	TB1F	TB0F	—	—	TB1E	TB0E
R/W	—	—	R/W	R/W	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	—	—	0	0

- Bit 7~6 未定义，读为“0”
- Bit 5 **TB1F**: 时基中断 1 请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 4 **TB0F**: 时基中断 0 请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 3~2 未定义，读为“0”
- Bit 1 **TB1E**: 时基中断 1 控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 0 **TB0E**: 时基中断 0 控制位
0: 除能
1: 使能

● MF10 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	CTMAF	CTMPF	—	—	CTMAE	CTMPE
R/W	—	—	R/W	R/W	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	—	—	0	0

Bit 7~6 未定义，读为“0”

Bit 5 **CTMAF**: CTM 比较器 A 匹配中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求

Bit 4 **CTMPF**: CTM 比较器 P 匹配中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求

Bit 3~2 未定义，读为“0”

Bit 1 **CTMAE**: CTM 比较器 A 匹配中断控制位
0: 除能
1: 使能

Bit 0 **CTMPE**: CTM 比较器 P 匹配中断控制位
0: 除能
1: 使能

● MF11 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	DEF	LVF	—	—	DEE	LVE
R/W	—	—	R/W	R/W	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	—	—	0	0

Bit 7~6 未定义，读为“0”

Bit 5 **DEF**: EEPROM 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求

Bit 4 **LVF**: LVD 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求

Bit 3~2 未定义，读为“0”

Bit 1 **DEE**: EEPROM 中断控制位
0: 除能
1: 使能

Bit 0 **LVE**: LVD 中断控制位
0: 除能
1: 使能

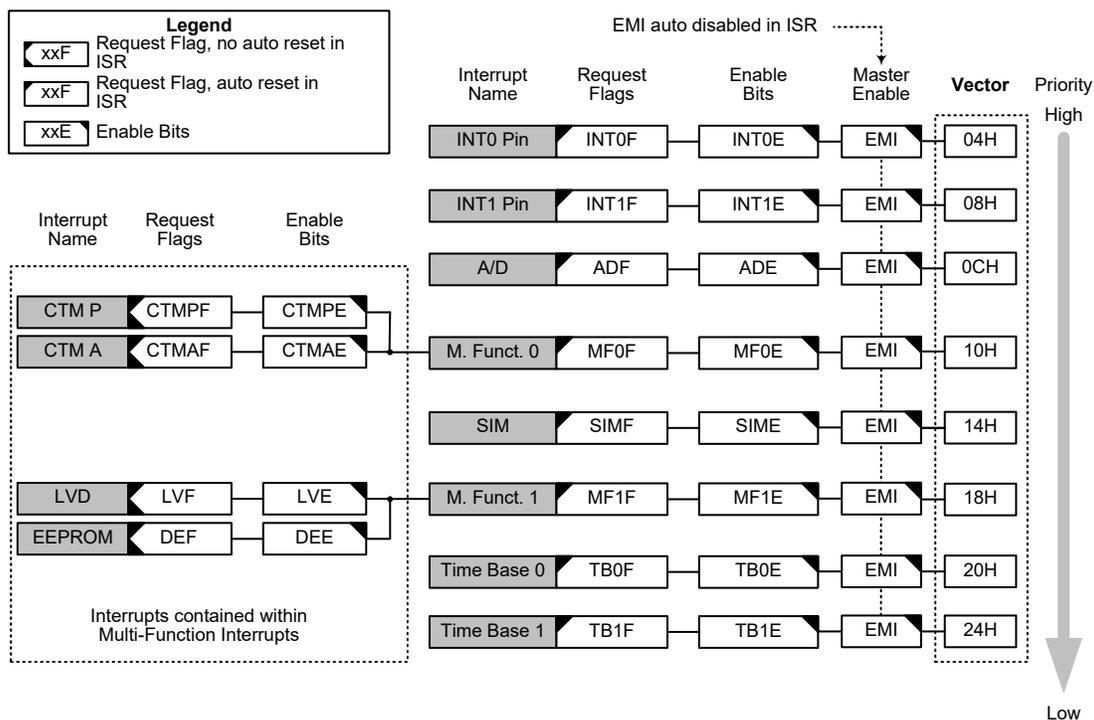
中断操作

若中断事件条件产生，如一个 TM 比较器 P、比较器 A 匹配或 A/D 转换结束等等，相关中断请求标志将置起。中断标志产生后程序是否会跳转至相关中断向量执行是由中断使能位的条件决定的。若使能位为“1”，程序将跳至相关中断向量中执行；若使能位为“0”，即使中断请求标志置起中断也不会发生，程序也不会跳转至相关中断向量执行。若总中断使能位为“0”，所有中断都将除能。

当中断发生时，下条指令的地址将被压入堆栈。相应的中断向量地址加载至 PC 中。系统将从此向量取下条指令。中断向量处通常为跳转指令，以跳转到相应的中断服务程序。中断服务程序必须以“RETI”指令返回至主程序，以继续执行原来的程序。

各个中断使能位以及相应的请求标志位，以优先级的次序显示在下图。一些中断源有自己的向量，但是有些中断却共用多功能中断向量。一旦中断子程序被响应，系统将自动清除 EMI 位，所有其它的中断将被屏蔽，这个方式可以防止任何进一步的中断嵌套。其它中断请求可能发生在此期间，虽然中断不会立即响应，但是中断请求标志位会被记录。

如果某个中断服务子程序正在执行时，有另一个中断要求立即响应，那么 EMI 位应在程序进入中断子程序后置位，以允许此中断嵌套。如果堆栈已满，即使此中断使能，中断请求也不会被响应，直到 SP 减少为止。如果要求立刻动作，则堆栈必须避免成为储满状态。请求同时发生时，执行优先级如下流程图所示。所有被置起的中断请求标志都可把单片机从休眠或空闲模式中唤醒，若要防止唤醒动作发生，在单片机进入休眠或空闲模式前应将相应的标志置起。



中断结构

外部中断

通过 INT0~INT1 引脚上的信号变化可控制外部中断。当触发沿选择位设置好触发类型，INT0~INT1 引脚的状态发生变化，外部中断请求标志 INT0F~INT1F 被置位时外部中断请求产生。若要跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和相应中断使能位 INT0E~INT1E 需先被置位。此外，必须使用 INTEG 寄存器使能外部中断功能并选择触发沿类型。外部中断引脚和普通 I/O 口共用，如果相应寄存器中的中断使能位被置位，此引脚将被作为外部中断脚使用。此时该引脚必须通过设置控制寄存器，将该引脚设置为输入口。当中断使能，堆栈未满足并且外部中断脚状态改变，将调用外部中断向量程序。当响应外部中断服务子程序时，中断请求标志位 INT0F~INT1F 会自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。注意，即使此引脚被用作外部中断输入，其上拉电阻选项仍保持有效。

寄存器 INTEG 被用来选择有效的边沿类型，来触发外部中断。可以选择上升沿还是下降沿或双沿触发都产生外部中断。注意 INTEG 也可以用来除能外部中断功能。

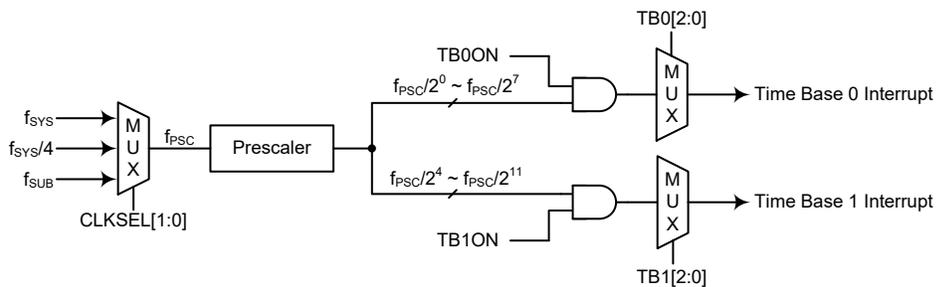
SIM 中断

串行接口模块中断，即 SIM 中断。当一个字节数据已由 SIM 接口接收或发送完，或 PC 从机地址匹配，或 PC 超时，中断请求标志 SIMF 被置位，SIM 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和串行接口中断使能位 SIME 需先被置位。当中断使能，堆栈未满足且以上任一种情况发生时，可跳转至相关中断向量程序中执行。当响应中断服务子程序时，串行接口中断标志位 SIMF 会自动复位且 EMI 将被自动清零以除能其它中断。

时基中断

时基中断提供一个固定周期的中断信号，由各自的定时器功能产生溢出信号控制。当各自的中断请求标志 TB0F 或 TB1F 被置位时，中断请求发生。当总中断使能位 EMI 和时基使能位 TB0E 或 TB1E 被置位，允许程序跳转到各自的中断向量地址。当中断使能，堆栈未满足且时基溢出时，将调用它们各自的中断向量程序。当响应中断服务子程序时，相应的中断请求标志位 TB0F 或 TB1F 会自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。

时基中断的目的是提供一个固定周期的中断信号。其时钟源 f_{PSC} 来自内部时钟源 f_{SYS} 、 $f_{SYS}/4$ 或 f_{SUB} 。 f_{PSC} 输入时钟首先经过分频器，分频率由程序设置 TB0C 和 TB1C 寄存器相关位获取合适的分频值以提供更长的时基中断周期。相应的控制时基中断周期的时钟源可通过 PSCR 寄存器的 CLKSEL1 和 CLKSEL0 位选择。



时基中断

● PSCR 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	CLKSEL1	CLKSEL0
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **CLKSEL1~CLKSEL0**: 分频器时钟源选择

00: f_{SYS}
01: $f_{SYS}/4$
1x: f_{SUB}

● TB0C 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TB0ON	—	—	—	—	TB02	TB01	TB00
R/W	R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	0	—	—	—	—	0	0	0

Bit 7 **TB0ON**: 时基 0 使能 / 除能控制位

0: 除能
1: 使能

Bit 6~3 未定义，读为“0”

Bit 2~0 **TB02~TB00**: 选择时基 0 溢出周期位

000: $2^8/f_{PSC}$
001: $2^9/f_{PSC}$
010: $2^{10}/f_{PSC}$
011: $2^{11}/f_{PSC}$
100: $2^{12}/f_{PSC}$
101: $2^{13}/f_{PSC}$
110: $2^{14}/f_{PSC}$
111: $2^{15}/f_{PSC}$

● TB1C 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TB1ON	—	—	—	—	TB12	TB11	TB10
R/W	R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	0	—	—	—	—	0	0	0

Bit 7 **TB1ON**: 时基 1 使能 / 除能控制位

0: 除能
1: 使能

Bit 6~3 未定义，读为“0”

Bit 2~0 **TB12~TB10**: 选择时基 1 溢出周期位

000: $2^8/f_{PSC}$
001: $2^9/f_{PSC}$
010: $2^{10}/f_{PSC}$
011: $2^{11}/f_{PSC}$
100: $2^{12}/f_{PSC}$
101: $2^{13}/f_{PSC}$
110: $2^{14}/f_{PSC}$
111: $2^{15}/f_{PSC}$

A/D 转换器中断

A/D 转换器中断由 A/D 转换动作的结束来控制。当 A/D 转换器中断请求标志被置位，即 A/D 转换过程完成时，中断请求发生。当总中断使能位 EMI 和 A/D 中断使能位 ADE 被置位，允许程序跳转到各自的中断向量地址。当中断使能，堆栈未满且 A/D 转换动作结束时，将调用它们各自的中断向量子程序。当响应中断服务子程序时，相应的中断请求标志位 ADF 会自动清零。EMI 位也会被清零以除能其它中断。

多功能中断

此单片机中有两个多功能中断，与其它中断不同，它没有独立源，但由其它现有的中断源构成，即 TM 中断、LVD 中断和 EEPROM 中断。

当多功能中断中任何一种中断请求标志 MF_nF 被置位，多功能中断请求产生。当中断使能，堆栈未满，包括在多功能中断中的任意一个中断发生时，将调用多功能中断向量中的一个子程序。当响应中断服务子程序时，相关多功能请求标志位会自动复位且 EMI 位会自动清零以除能其它中断。

但必须注意的是，在中断响应时，虽然多功能中断标志会自动复位，但多功能中断源的请求标志位，即 TM 中断、LVD 中断和 EEPROM 中断的请求标志位不会自动复位，必须由应用程序清零。

EEPROM 中断

EEPROM 中断也属于多功能中断。当写周期结束，EEPROM 中断请求标志 DEF 被置位，EEPROM 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI、EEPROM 中断使能位 DEE 和相应多功能中断使能位需先被置位。当中断使能，堆栈未满且 EEPROM 写周期结束时，可跳转至相关多功能中断向量子程序中执行。当 EEPROM 中断响应，EMI 将被自动清零以除能其它中断，多功能中断请求标志也可自动清除，但 DEF 标志需在应用程序中手动清除。

LVD 中断

LVD 中断也属于多功能中断。当低电压检测功能检测到一个低电源电压或低 LVDIN 输入电压时，LVD 中断请求标志 LVF 被置位，LVD 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI、低电压中断使能位 LVE 和相应多功能中断使能位需先被置位。当中断使能，堆栈未满且低电压条件发生时，可跳转至相关多功能中断向量子程序中执行。当低电压中断响应，EMI 将被自动清零以除能其它中断，多功能中断请求标志也可自动清除，但 LVF 标志需在应用程序中手动清除。

TM 中断

简易型 TM 有两个中断，分别来自比较器 P、A 匹配，都属于多功能中断。所有的 TM 都有两个中断请求标志位及两个使能位。当 TM 比较器 P、A 匹配情况发生时，相应 TM 中断请求标志被置位，TM 中断请求产生。

若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI、相应 TM 中断使能位和相关多功能中断使能位 MF_nE 需先被置位。当中断使能，堆栈未满且 TM 比较器匹配情况发生时，可跳转至相关多功能中断向量子程序中执行。当 TM 中断响应，EMI 将被自动清零以除能其它中断，相关 MF_nF 标志也可自动清除，但 TM 中断请求标志需在应用程序中手动清除。

中断唤醒功能

每个中断都具有将处于休眠或空闲模式的单片机唤醒的能力。当中断请求标志由低到高转换时唤醒动作产生，其与中断是否使能无关。因此，尽管单片机处于休眠或空闲模式且系统振荡器停止工作，如有外部中断脚上产生外部边沿跳变，低电压都可能导致其相应的中断标志被置位，由此产生中断，因此必须注意避免伪唤醒情况的发生。若中断唤醒功能被除能，单片机进入休眠或空闲模式前相应中断请求标志应被置起。中断唤醒功能不受中断使能位的影响。

编程注意事项

通过禁止相关中断使能位，可以屏蔽中断请求，然而，一旦中断请求标志位被设定，它们会被保留在中断控制寄存器内，直到相应的中断服务子程序执行或请求标志位被软件指令清除。

多功能中断中所含中断相应程序执行时，多功能中断请求标志 MF_nF 可以自动清零，但各自的请求标志需在应用程序中手动清除。

建议在中断服务子程序中不要使用“CALL 子程序”指令。中断通常发生在不可预料的情况或是需要立刻执行的某些应用。假如只剩下一层堆栈且没有控制好中断，当“CALL 子程序”在中断服务子程序中执行时，将破坏原来的控制序列。

所有中断在休眠或空闲模式下都具有唤醒功能，当中断请求标志发生由低到高的转变时都可产生唤醒功能。若要避免相应中断产生唤醒动作，在单片机进入休眠或空闲模式前需先将相应请求标志置为高。

当进入中断服务程序，系统仅将程序计数器的内容压入堆栈，如果中断服务程序会改变状态寄存器或其它的寄存器的内容而破坏控制流程，应事先将这些数据保存起来。

若从中断子程序中返回可执行 RET 或 RETI 指令。除了能返回至主程序外，RETI 指令还能自动设置 EMI 位为高，允许进一步中断。RET 指令只能返回至主程序，清除 EMI 位，除能进一步中断。

低电压检测 – LVD

该单片机具有低电压检测功能，即 LVD。该功能使能用于监测电源电压 V_{DD} ，或 LVDIN 输入电压，若低于一定值可提供一个警告信号。此功能在电池类产品中非常有用，在电池电压较低时产生警告信号。低电压检测也可产生中断信号。

LVD 寄存器

低电压检测功能由 LVDC 寄存器控制。VLVD2~VLVD0 位用于选择 8 个固定电压中的一个参考点。LVDO 位被置位时低电压情况发生，若 LVDO 位为低表明 V_{DD} 电压或 LVDIN 输入电压工作在当前所设置低电压水平值之上。LVDEN 位用于控制低电压检测功能的开启 / 关闭，设置此位为高使能此功能，反之，关闭内部低电压检测电路。低电压检测会有一定的功耗，在不使用时可考虑关闭此功能，此举在功耗要求严格的电池供电应用中值得考虑。

• LVDC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	LVDO	LVDEN	VBGEN	VLVD2	VLVD1	VLVD0
R/W	—	—	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 未定义，读为“0”

Bit 5 **LVDO**: LVD 输出标志位
0: 未检测到低电压
1: 检测到低电压

Bit 4 **LVDEN**: 低电压检测控制位
0: 除能
1: 使能

Bit 3 **VBGEN**: Bandgap 电压输出使能控制位
0: 除能
1: 使能

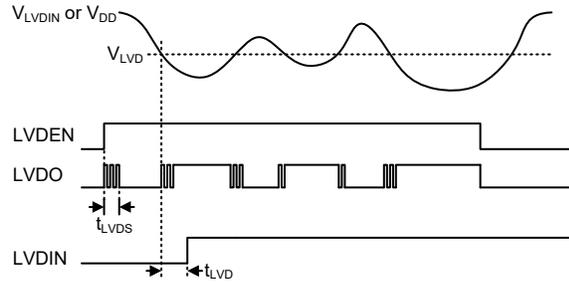
当 LVD 或 LVR 使能或者 VBGEN 位置高时，Bandgap 电路使能。

Bit 2~0 **VLVD2~VLVD0**: 选择 LVD 电压位
000: $V_{LVDIN} \leq 1.04V$
001: 2.2V
010: 2.4V
011: 2.7V
100: 3.0V
101: 3.3V
110: 3.6V
111: 4.0V

当这些位设置为 000 时，LVD 将 LVDIN 引脚输入电压和参考电压进行比较以监测 LVDIN 输入电压。当这些位设为 000 以外的其它值时，LVD 将电源电压跟所选参考电压进行比较以监测电源电压值。

LVD 操作

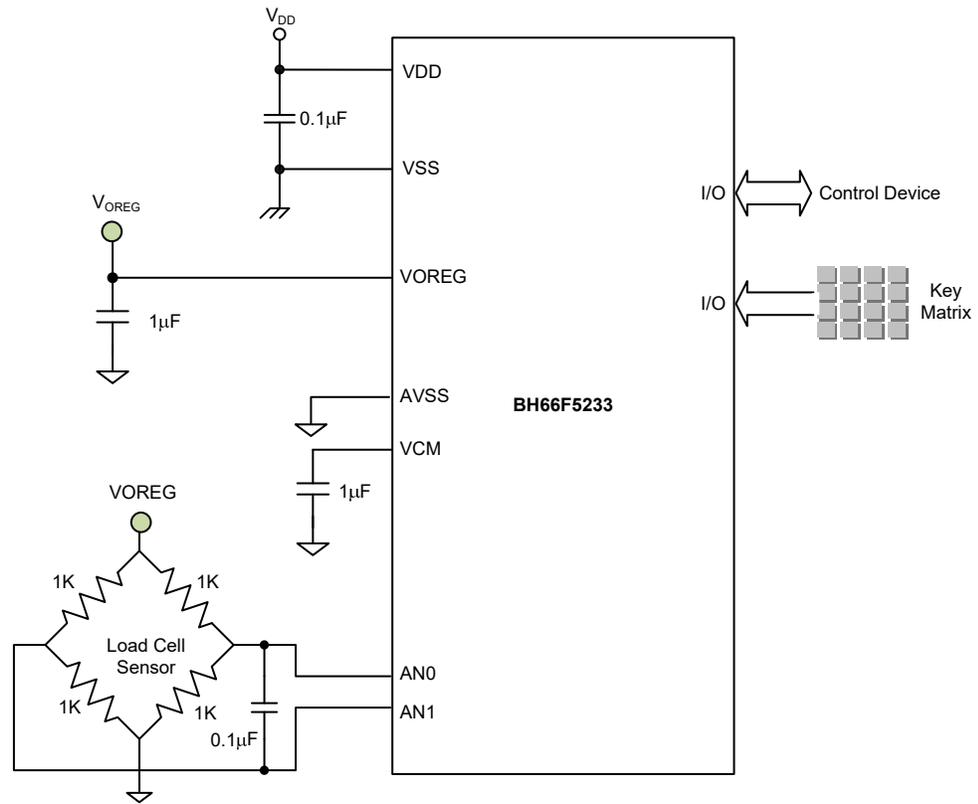
通过比较电源电压 V_{DD} 或 V_{LVDIN} 输入电压与存储在 $LVDC$ 寄存器中的预置电压值的结果，低电压检测功能工作。其设置的范围为 $1.04V \sim 4.0V$ 。当电源电压 V_{DD} 低于预置电压值时， $LVDO$ 位被置为高，表明低电压产生。低电压检测功能由一个自动使能的参考电压提供。当单片机进入休眠模式时，即使 $LVDEN$ 位为高，低电压检测器除能。低电压检测器使能后，读取 $LVDO$ 位前，电路稳定需要一定的延时 t_{LVDS} 。注意， V_{DD} 或 V_{LVDIN} 电压可能上升或下降比较缓慢，在 V_{LVD} 电压值附近时， $LVDO$ 位可能有多种变化。



LVD 操作

低电压检测器也有自己的中断功能，也是属于多功能中断的一种，它是除了轮询 $LVDO$ 位之外的另一种检测低电压的方法。中断条件产生置位 $LVDO$ 并延时 t_{LVD} 后，中断产生。此种情况下，若 V_{DD} 或 V_{LVDIN} 降至小于 V_{LVD} 预置电压值时，中断请求标志位 LVF 将被置位，中断产生，单片机将从休眠或空闲模式中被唤醒。若不要求低电压检测的唤醒功能使能，在单片机进入休眠或空闲模式前应将 LVF 标志置为高。

应用电路



指令集

简介

任何单片机成功运作的核心在于它的指令集，此指令集为一组程序指令码，用来指导单片机如何去执行指定的工作。在 Holtek 单片机中，提供了丰富且灵活的指令，共超过六十条，程序设计者可以事半功倍地实现它们的应用。

为了更加容易理解各种各样的指令码，接下来按功能分组介绍它们。

指令周期

大部分的操作均只需要一个指令周期来执行。分支、调用或查表则需要两个指令周期。一个指令周期相当于四个系统时钟周期，因此如果在 8MHz 的系统时钟振荡器下，大部分的操作将在 0.5 μ s 中执行完成，而分支或调用操作则将在 1 μ s 中执行完成。虽然需要两个指令周期的指令通常指的是 JMP、CALL、RET、RETI 和查表指令，但如果牵涉到程序计数器低字节寄存器 PCL 也将多花费一个周期去加以执行。即指令改变 PCL 的内容进而导致直接跳转至新地址时，需要多一个周期去执行，例如“CLR PCL”或“MOV PCL, A”指令。对于跳转指令必须注意的是，如果比较的结果牵涉到跳转动作将多花费一个周期，如果没有则需一个周期即可。

数据的传送

单片机程序中数据传送是使用最为频繁的操作之一，使用三种 MOV 的指令，数据不但可以从寄存器转移至累加器（反之亦然），而且能够直接移动立即数到累加器。数据传送最重要的应用之一是从输入端口接收数据或传送数据到输出端口。

算术运算

算术运算和数据处理是大部分单片机应用所必需具备的能力，在 Holtek 单片机内部的指令集中，可直接实现加与减的运算。当加法的结果超出 255 或减法的结果少于 0 时，要注意正确的处理进位和借位的问题。INC、INCA、DEC 和 DECA 指令提供了对一个指定地址的值加一或减一的功能。

逻辑和移位运算

标准逻辑运算例如 AND、OR、XOR 和 CPL 全都包含在 Holtek 单片机内部的指令集中。大多数牵涉到数据运算的指令，数据的传送必须通过累加器。在所有逻辑数据运算中，如果运算结果为零，则零标志位将被置位，另外逻辑数据运用形式还有移位指令，例如 RR、RL、RRC 和 RLC 提供了向左或向右移动一位的方法。不同的移位指令可满足不同的应用需要。移位指令常用于串行端口的程序应用，数据可从内部寄存器转移至进位标志位，而此位则可被检验，移位运算还可应用在乘法与除法的运算组成中。

分支和控制转换

程序分支是采取使用 JMP 指令跳转至指定地址或使用 CALL 指令调用子程序的形式，两者之不同在于当子程序被执行完毕后，程序必须马上返回原来的地址。这个动作是由放置在子程序里的返回指令 RET 来实现，它可使程序跳回 CALL 指令之后的地址。在 JMP 指令中，程序则只是跳到一个指定的地址而已，并不需如 CALL 指令般跳回。一个非常有用的分支指令是条件跳转，跳转条件是由数据存储器或指定位来加以决定。遵循跳转条件，程序将继续执行下一条指令或略过且跳转至接下来的指令。这些分支指令是程序走向的关键，跳转条件可能是外部开关输入，或是内部数据位的值。

位运算

提供数据存储器中单个位的运算指令是 Holtek 单片机的特性之一。这特性对于输出端口位的设置尤其有用，其中个别的位或端口的引脚可以使用“SET [m].i”或“CLR [m].i”指令来设定其为高位或低位。如果没有这特性，程序设计师必须先读入输入口的 8 位数据，处理这些数据，然后再输出正确的新数据。这种读入 - 修改 - 写出的过程现在则被位运算指令所取代。

查表运算

数据的储存通常由寄存器完成，然而当处理大量固定的数据时，它的存储量常常造成对个别存储器的不便。为了改善此问题，Holtek 单片机允许在程序存储器中建立一个表格作为数据可直接存储的区域，只需要一组简易的指令即可对数据进行查表。

其它运算

除了上述功能指令外，其它指令还包括用于省电的“HALT”指令和使程序在极端电压或电磁环境下仍能正常工作的看门狗定时器控制指令。这些指令的使用则请查阅相关的章节。

指令集概要

下表中说明了按功能分类的指令集，用户可以将该表作为基本的指令参考。

惯例

x: 立即数
m: 数据存储器地址
A: 累加器
i: 第 0~7 位
addr: 程序存储器地址

助记符	说明	指令周期	影响标志位
算术运算			
ADD A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV
ADDM A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入数据存储器	1 ^注	Z, C, AC, OV
ADD A, x	ACC 与立即数相加，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV
ADC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV
ADCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入数据存储器	1 ^注	Z, C, AC, OV
SUB A, x	ACC 与立即数相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV
SUB A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV
SUBM A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入数据存储器	1 ^注	Z, C, AC, OV
SBC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志的反相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV
SBCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入数据存储器	1 ^注	Z, C, AC, OV
DAA [m]	将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数，并将结果放入数据存储器	1 ^注	C
逻辑运算			
AND A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入 ACC	1	Z
OR A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入 ACC	1	Z
XOR A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入 ACC	1	Z
ANDM A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入数据存储器	1 ^注	Z
ORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入数据存储器	1 ^注	Z
XORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入数据存储器	1 ^注	Z
AND A, x	ACC 与立即数做“与”运算，结果放入 ACC	1	Z
OR A, x	ACC 与立即数做“或”运算，结果放入 ACC	1	Z
XOR A, x	ACC 与立即数做“异或”运算，结果放入 ACC	1	Z
CPL [m]	对数据存储器取反，结果放入数据存储器	1 ^注	Z
CPLA [m]	对数据存储器取反，结果放入 ACC	1	Z
递增和递减			
INCA [m]	递增数据存储器，结果放入 ACC	1	Z
INC [m]	递增数据存储器，结果放入数据存储器	1 ^注	Z
DECA [m]	递减数据存储器，结果放入 ACC	1	Z
DEC [m]	递减数据存储器，结果放入数据存储器	1 ^注	Z

助记符	说明	指令周期	影响标志位
移位			
RRA [m]	数据存储器右移一位，结果放入 ACC	1	无
RR [m]	数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	1 ^注	无
RRCA [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入 ACC	1	C
RRC [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	1 ^注	C
RLA [m]	数据存储器左移一位，结果放入 ACC	1	无
RL [m]	数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	1 ^注	无
RLCA [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入 ACC	1	C
RLC [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	1 ^注	C
数据传送			
MOV A,[m]	将数据存储器送至 ACC	1	无
MOV [m],A	将 ACC 送至数据存储器	1 ^注	无
MOV A, x	将立即数送至 ACC	1	无
位运算			
CLR [m].i	清除数据存储器的位	1 ^注	无
SET [m].i	置位数据存储器的位	1 ^注	无
转移			
JMP addr	无条件跳转	2	无
SZ [m]	如果数据存储器为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SZA [m]	数据存储器送至 ACC，如果内容为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SNZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位不为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SIZ [m]	递增数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SDZ [m]	递减数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SIZA [m]	递增数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SDZA [m]	递减数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
CALL0 addr	子程序调用	2	无
RET	从子程序返回	2	无
RET A, x	从子程序返回，并将立即数放入 ACC	2	无
RETI	从中断返回	2	无
查表			
TABRD [m]	读取特定页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2 ^注	无
TABRDC [m]	读取当前页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2 ^注	无
TABRDL [m]	读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2 ^注	无
其它指令			
NOP	空指令	1	无
CLR [m]	清除数据存储器	1 ^注	无
SET [m]	置位数据存储器	1 ^注	无

助记符	说明	指令周期	影响标志位
CLR WDT	清除看门狗定时器	1	TO, PDF
CLR WDT1	预清除看门狗定时器	1	TO, PDF
CLR WDT2	预清除看门狗定时器	1	TO, PDF
SWAP [m]	交换数据存储器的高低字节, 结果放入数据存储器	1 ^注	无
SWAPA [m]	交换数据存储器的高低字节, 结果放入 ACC	1	无
HALT	进入暂停模式	1	TO, PDF

- 注: 1. 对跳转指令而言, 如果比较的结果牵涉到跳转即需多达 2 个周期, 如果没有发生跳转, 则只需一个周期。
2. 任何指令若要改变 PCL 的内容将需要 2 个周期来执行。
3. 对于“CLR WDT1”或“CLR WDT2”指令而言, TO 和 PDF 标志位也许会受执行结果影响, “CLR WDT1”和“CLR WDT2”被连续地执行后, TO 和 PDF 标志位会被清除, 否则 TO 和 PDF 标志位保持不变

指令定义

ADC A, [m]	Add Data Memory to ACC with Carry
指令说明	将指定的数据存储器、累加器内容以及进位标志相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV、Z、AC、C
ADCM A, [m]	Add ACC to Data Memory with Carry
指令说明	将指定的数据存储器、累加器内容和进位标志位相加，结果存放到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV、Z、AC、C
ADD A, [m]	Add Data Memory to ACC
指令说明	将指定的数据存储器和累加器内容相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C
ADD A, x	Add immediate data to ACC
指令说明	将累加器和立即数相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + x$
影响标志位	OV、Z、AC、C
ADDM A, [m]	Add ACC to Data Memory
指令说明	将指定的数据存储器和累加器内容相加，结果存放到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C
AND A, [m]	Logical AND Data Memory to ACC
指令说明	将累加器中的数据和指定数据存储器内容做逻辑与，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$
影响标志位	Z

AND A, x	Logical AND immediate data to ACC
指令说明	将累加器中的数据和立即数做逻辑与，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ “AND” } x$
影响标志位	Z
ANDM A, [m]	Logical AND ACC to Data Memory
指令说明	将指定数据存储器内容和累加器中的数据做逻辑与，结果存放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC \text{ “AND” } [m]$
影响标志位	Z
CALL addr	Subroutine call
指令说明	无条件地调用指定地址的子程序，此时程序计数器先加 1 获得下一个要执行的指令地址并压入堆栈，接着载入指定地址并从新地址继续执行程序，由于此指令需要额外的运算，所以为一个 2 周期的指令。
功能表示	$Stack \leftarrow Program\ Counter + 1$ $Program\ Counter \leftarrow addr$
影响标志位	无
CLR [m]	Clear Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容清零。
功能表示	$[m] \leftarrow 00H$
影响标志位	无
CLR [m].i	Clear bit of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的 i 位内容清零。
功能表示	$[m].i \leftarrow 0$
影响标志位	无
CLR WDT	Clear Watchdog Timer
指令说明	WDT 计数器、暂停标志位 PDF 和看门狗溢出标志位 TO 清零。
功能表示	WDT cleared $TO \ \& \ PDF \leftarrow 0$
影响标志位	TO、PDF

CLR WDT1	Preclear Watchdog Timer
指令说明	PDF 和 TO 标志位都被清 0。必须配合 CLR WDT2 一起使用清除 WDT 计时器。当程序仅执行 CLR WDT1，而没有执行 CLR WDT2 时，PDF 与 TO 保留原状态不变。
功能表示	WDT ← 00H TO & PDF ← 0
影响标志位	TO、PDF
CLR WDT2	Preclear Watchdog Timer
指令说明	PDF 和 TO 标志位都被清 0。必须配合 CLR WDT1 一起使用清除 WDT 计时器。当程序仅执行 CLR WDT2，而没有执行 CLR WDT1 时，PDF 与 TO 保留原状态不变。
功能表示	WDT ← 00H TO & PDF ← 0
影响标志位	TO、PDF
CPL [m]	Complement Data Memory
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1。
功能表示	[m] ← $\overline{[m]}$
影响标志位	Z
CPLA [m]	Complement Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1，而结果被储存回累加器且数据存储器中的内容不变。
功能表示	ACC ← $\overline{[m]}$
影响标志位	Z

DAA [m] 指令说明	Decimal-Adjust ACC for addition with result in Data Memory 将累加器中的内容转换为 BCD (二进制转成十进制) 码。 如果低四位的值大于“9”或 AC=1, 那么 BCD 调整就执行对原值加“6”, 否则原值保持不变; 如果高四位的值大于“9”或 C=1, 那么 BCD 调整就执行对原值加“6”。 BCD 转换实质上是根据累加器和标志位执行 00H, 06H, 60H 或 66H 的加法运算, 结果存放和数据存储器。只有进位标志位 C 受影响, 用来指示原始 BCD 的和是否大于 100, 并可以进行双精度十进制数的加法运算。
功能表示	[m] ← ACC + 00H 或 [m] ← ACC + 06H 或 [m] ← ACC + 60H 或 [m] ← ACC + 66H
影响标志位	C
DEC [m] 指令说明	Decrement Data Memory 将指定数据存储器内容减 1。
功能表示	[m] ← [m] - 1
影响标志位	Z
DECA [m] 指令说明	Decrement Data Memory with result in ACC 将指定数据存储器的内容减 1, 把结果存放回累加器并保持指定数据存储器的内容不变。
功能表示	ACC ← [m] - 1
影响标志位	Z
HALT 指令说明	Enter power down mode 此指令终止程序执行并关掉系统时钟, RAM 和寄存器的内容保持原状态, WDT 计数器和分频器被清“0”, 暂停标志位 PDF 被置位 1, WDT 溢出标志位 TO 被清 0。
功能表示	TO ← 0 PDF ← 1
影响标志位	TO、PDF
INC [m] 指令说明	Increment Data Memory 将指定数据存储器的内容加 1。
功能表示	[m] ← [m] + 1
影响标志位	Z

INCA [m]	Increment Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1，结果存放回累加器并保持指定的数据存储器内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
JMP addr	Jump unconditionally
指令说明	程序计数器的内容无条件地由被指定的地址取代，程序由新的地址继续执行。当新的地址被加载时，必须插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。
功能表示	$Program Counter \leftarrow addr$
影响标志位	无
MOV A, [m]	Move Data Memory to ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容复制到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow [m]$
影响标志位	无
MOV A, x	Move immediate data to ACC
指令说明	将 8 位立即数载入累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow x$
影响标志位	无
MOV [m], A	Move ACC to Data Memory
指令说明	将累加器的内容复制到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC$
影响标志位	无
NOP	No operation
指令说明	空操作，接下来顺序执行下一条指令。
功能表示	$PC \leftarrow PC+1$
影响标志位	无
ORA, [m]	Logical OR Data Memory to ACC
指令说明	将累加器中的数据和指定的数据存储器内容逻辑或，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "OR" } [m]$
影响标志位	Z

ORA, x	Logical OR immediate data to ACC
指令说明	将累加器中的数据 and 立即数逻辑或，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "OR" } x$
影响标志位	Z
ORMA, [m]	Logical OR ACC to Data Memory
指令说明	将存在指定数据存储器的数据和累加器逻辑或，结果放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC \text{ "OR" } [m]$
影响标志位	Z
RET	Return from subroutine
指令说明	将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复，程序由取回的地址继续执行。
功能表示	$Program\ Counter \leftarrow Stack$
影响标志位	无
RETA, x	Return from subroutine and load immediate data to ACC
指令说明	将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复且累加器载入指定的立即数，程序由取回的地址继续执行。
功能表示	$Program\ Counter \leftarrow Stack$ $ACC \leftarrow x$
影响标志位	无
RETI	Return from interrupt
指令说明	将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复且中断功能通过设置 EMI 位重新使能。EMI 是控制中断使能的主控制位。如果在执行 RETI 指令之前还有中断未被相应，则这个中断将在返回主程序之前被相应。
功能表示	$Program\ Counter \leftarrow Stack$ $EMI \leftarrow 1$
影响标志位	无
RL [m]	Rotate Data Memory left
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位。
功能表示	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $[m].0 \leftarrow [m].7$
影响标志位	无

RLA [m]	Rotate Data Memory left with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位，结果送到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $ACC.0 \leftarrow [m].7$
影响标志位	无
RLC [m]	Rotate Data Memory Left through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位。
功能表示	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $[m].0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$
影响标志位	C
RLC A [m]	Rotate Data Memory left through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $ACC.0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$
影响标志位	C
RR [m]	Rotate Data Memory right
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位且第 0 位移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1) \ (i=0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
RRA [m]	Rotate Data Memory right with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位，第 0 位移到第 7 位，移位结果存放到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1) \ (i=0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无

RRC [m]	Rotate Data Memory right through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
RRCA [m]	Rotate Data Memory right through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
SBC A, [m]	Subtract Data Memory from ACC with Carry
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SBCM A, [m]	Subtract Data Memory from ACC with Carry and result in Data Memory
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SDZ [m]	Skip if Decrement Data Memory is 0
指令说明	将指定的数据存储器的内容减 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令，由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无

<p>SDZA [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Decrement data memory and place result in ACC,skip if 0 将指定数据存储器内容减 1，判断是否为 0，如果为 0 则跳过下一条指令，此结果将存放累加器，但指定数据存储器内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>$ACC \leftarrow [m]-1$，如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>SET [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Set Data Memory 将指定数据存储器的每一位设置为 1。</p> <p>$[m] \leftarrow FFH$</p> <p>无</p>
<p>SET [m].i 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Set bit of Data Memory 将指定数据存储器的第 i 位置位为 1。</p> <p>$[m].i \leftarrow 1$</p> <p>无</p>
<p>SIZ [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if increment Data Memory is 0 将指定的数据存储器内容加 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>$[m] \leftarrow [m]+1$，如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>SIZA [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if increment Data Memory is zero with result in ACC 将指定数据存储器内容加 1，判断是否为 0，如果为 0 则跳过下一条指令，此结果会被存放累加器，但是指定数据存储器内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>$ACC \leftarrow [m]+1$，如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>

SNZ [m].i	Skip if bit i of Data Memory is not 0
指令说明	判断指定数据存储器的第 i 位，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 [m].i≠0，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
SUB A, [m]	Subtract Data Memory from ACC
指令说明	将累加器的内容减去指定的数据存储器的数据，把结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SUBM A, [m]	Subtract Data Memory from ACC with result in Data Memory
指令说明	将累加器的内容减去指定数据存储器的数据，结果存放到指定的数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SUB A, x	Subtract immediate Data from ACC
指令说明	将累加器的内容减去立即数，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - x$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SWAP [m]	Swap nibbles of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的低 4 位和高 4 位互相交换。
功能表示	$[m].3\sim[m].0 \leftrightarrow [m].7\sim[m].4$
影响标志位	无
SWAPA [m]	Swap nibbles of Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的低 4 位与高 4 位互相交换，再将结果存放到累加器且指定数据寄存器的数据保持不变。
功能表示	$ACC.3\sim ACC.0 \leftarrow [m].7\sim[m].4$ $ACC.7\sim ACC.4 \leftarrow [m].3\sim[m].0$
影响标志位	无

<p>SZ [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if Data Memory is 0</p> <p>判断指定数据存储器的内容是否为 0，若为 0，则程序跳下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 [m]=0, 跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>SZA [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if Data Memory is 0 with data movement to ACC</p> <p>将指定数据存储器内容复制到累加器，并判断指定数据存储器的内容是否为 0，若为 0 则跳下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>ACC ←[m]，如果 [m]=0，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>SZ [m].i 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Skip if bit i of Data Memory is 0</p> <p>判断指定数据存储器的第 i 位是否为 0，若为 0，则跳下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。</p> <p>如果 [m].i=0，跳过下一条指令执行</p> <p>无</p>
<p>TABRD [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Read table (specific page) to TBLH and Data Memory</p> <p>将表格指针对 TBHP 和 TBLP 所指的程序代码低字节 (指定页) 移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码 (低字节)</p> <p>TBLH ← 程序代码 (高字节)</p> <p>无</p>
<p>TABRDC [m] 指令说明</p> <p>功能表示</p> <p>影响标志位</p>	<p>Read table (current page) to TBLH and Data Memory</p> <p>将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (当前页) 移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。</p> <p>[m] ← 程序代码 (低字节)</p> <p>TBLH ← 程序代码 (高字节)</p> <p>无</p>

TABRDL [m]	Read table (last page) to TBLH and Data Memory
指令说明	将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (最后一页) 移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)
影响标志位	无
XORA, [m]	Logical XOR Data Memory to ACC
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或, 结果存放到累加器。
功能表示	ACC ← ACC “XOR” [m]
影响标志位	Z
XORM A, [m]	Logical XOR ACC to Data Memory
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或, 结果放到数据存储器。
功能表示	[m] ← ACC “XOR” [m]
影响标志位	Z
XORA, x	Logical XOR immediate data to ACC
指令说明	将累加器的数据与立即数逻辑异或, 结果存放到累加器。
功能表示	ACC ← ACC “XOR” x
影响标志位	Z

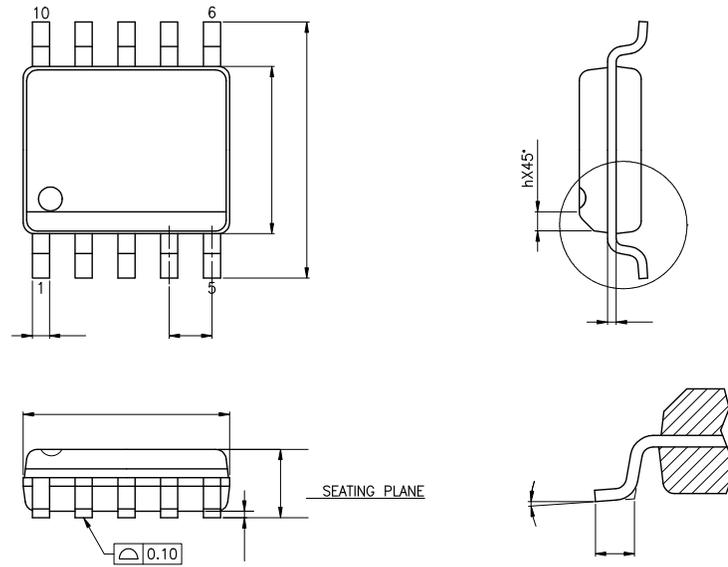
封装信息

请注意，这里提供的封装信息仅作为参考。由于这个信息经常更新，提醒用户咨询 [Holtek 网站](#) 以获取最新版本的[封装信息](#)。

封装信息的相关内容如下所示，点击可链接至 Holtek 网站相关信息页面。

- 封装信息 (包括外形尺寸、包装带和卷轴规格)
- 封装材料信息
- 纸箱信息

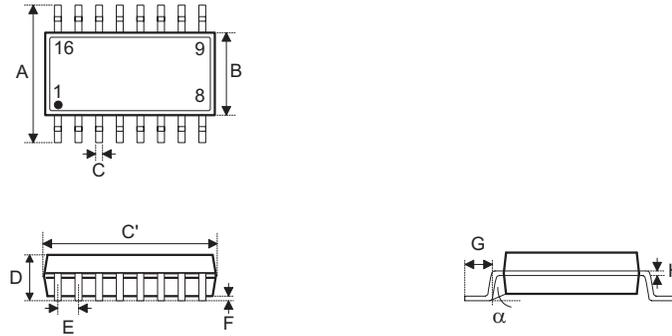
10-pin SOP (150mil) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.236 BSC	—
B	—	0.154 BSC	—
C	0.012	—	0.018
C'	—	0.193 BSC	—
D	—	—	0.069
E	—	0.039 BSC	—
F	0.004	—	0.010
G	0.016	—	0.050
H	0.004	—	0.010
α	0°	—	8°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	6.00 BSC	—
B	—	3.90 BSC	—
C	0.30	—	0.45
C'	—	4.90 BSC	—
D	—	—	1.75
E	—	1.00 BSC	—
F	0.10	—	0.25
G	0.40	—	1.27
H	0.10	—	0.25
α	0°	—	8°

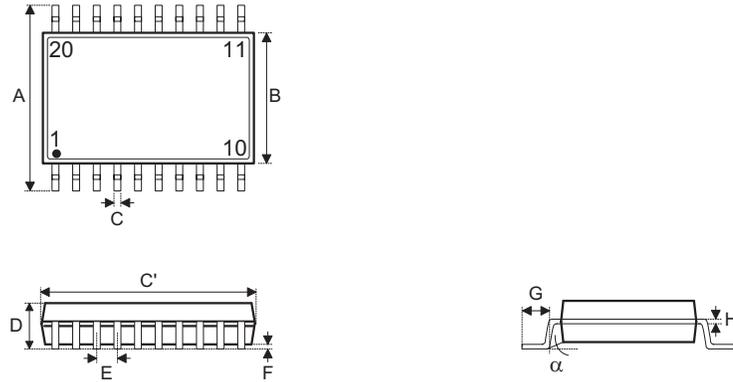
16-pin NSOP (150mil) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.236 BSC	—
B	—	0.154 BSC	—
C	0.012	—	0.020
C'	—	0.390 BSC	—
D	—	—	0.069
E	—	0.050 BSC	—
F	0.004	—	0.010
G	0.016	—	0.050
H	0.004	—	0.010
α	0°	—	8°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	6.0 BSC	—
B	—	3.9 BSC	—
C	0.31	—	0.51
C'	—	9.9 BSC	—
D	—	—	1.75
E	—	1.27 BSC	—
F	0.10	—	0.25
G	0.40	—	1.27
H	0.10	—	0.25
α	0°	—	8°

20-pin NSOP (150mil) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.228	0.236	0.244
B	0.146	0.154	0.161
C	0.009	—	0.012
C'	0.382	0.390	0.398
D	—	—	0.069
E	—	0.032 BSC	—
F	0.002	—	0.009
G	0.020	—	0.031
H	0.008	—	0.010
α	0°	—	8°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	5.80	6.00	6.20
B	3.70	3.90	4.10
C	0.23	—	0.30
C'	9.70	9.90	10.10
D	—	—	1.75
E	—	0.80 BSC	—
F	0.05	—	0.23
G	0.50	—	0.80
H	0.21	—	0.25
α	0°	—	8°

Copyright® 2019 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的，然而 **Holtek** 对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明，**Holtek** 不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。**Holtek** 产品不授权用于救生、维生从机或系统中做为关键从机。**Holtek** 拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考我们的网址 <http://www.holtek.com/zh/>。